

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

整流模块

MD1000A

ChunShu Rectifier CO., LTD.

特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV} 1000A
 V_{RRM} 1600V
 I_{FSM} $20A \times 10^3$
 I_{2t} $2040A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			1000	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			1570	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} $t_p=10ms$, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			50	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			20	KA
I_{2t}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			2040	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.31	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=3000A$	25			1.82	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.080	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热					$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min$, $I_{iso}:1mA(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M12)				14		N·m
F_m	安装扭矩(M10)				10		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_f	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

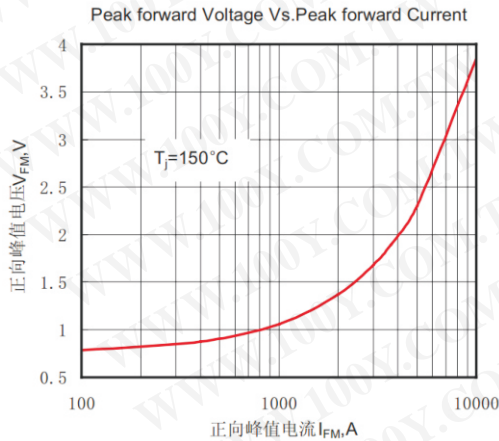


Fig.1 正向伏安特性曲线

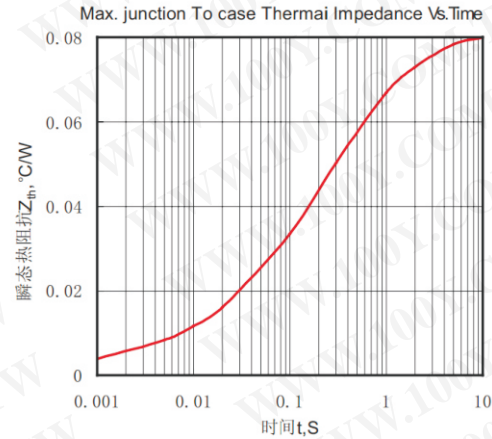


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

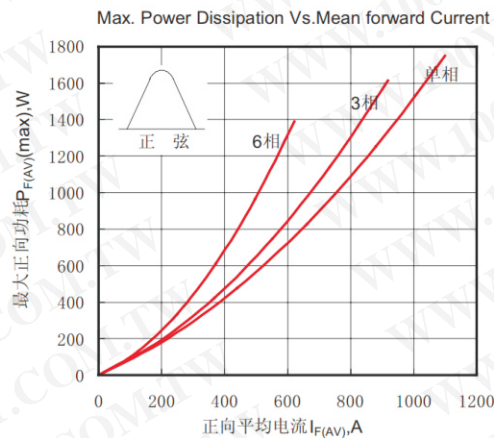


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

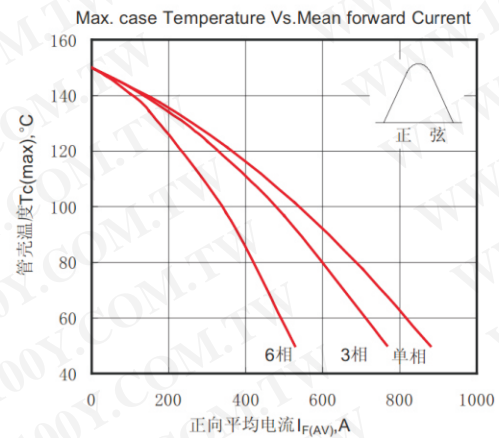


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

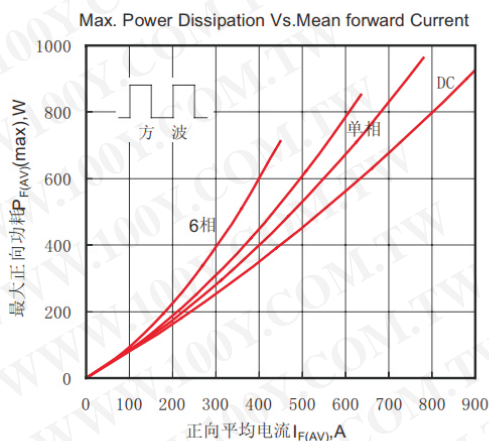


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

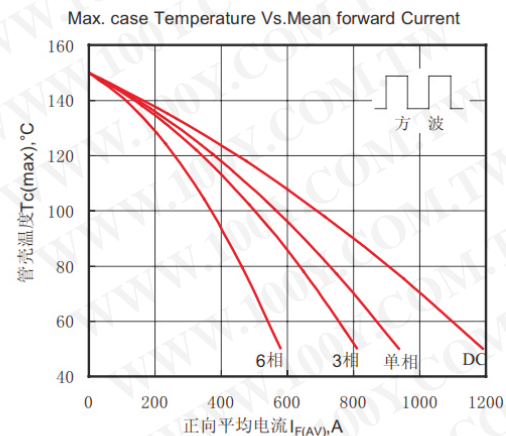


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

整流模块

MD1000A

ChunShu Rectifier CO., LTD.

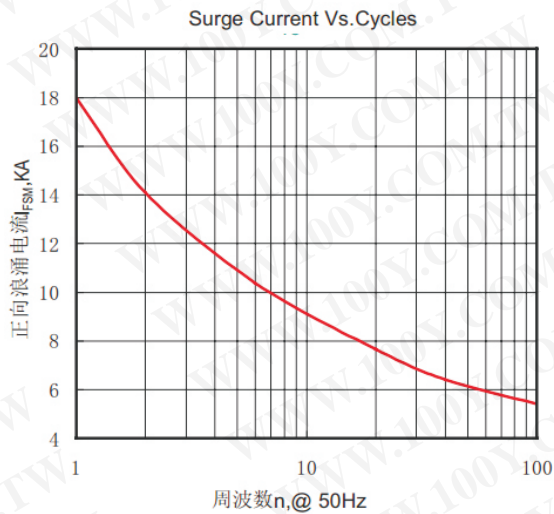


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

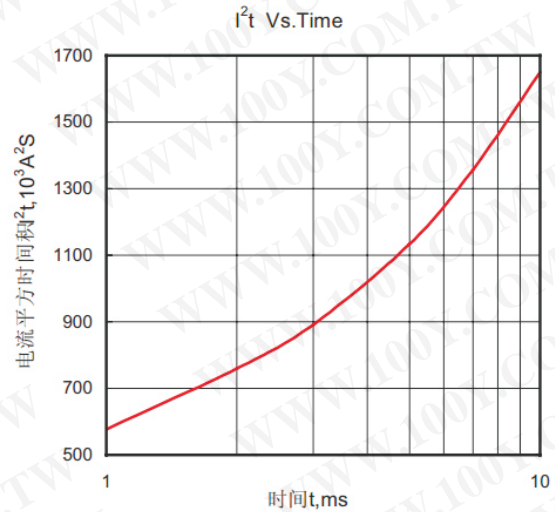
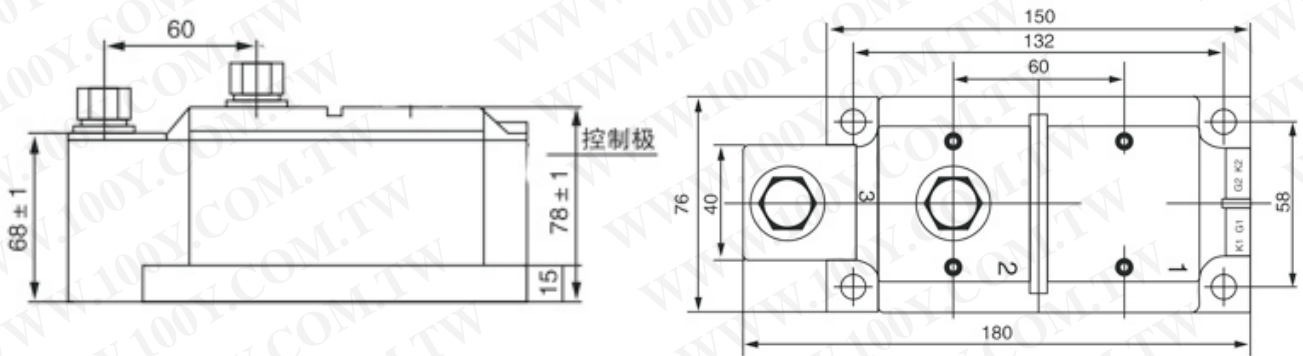


Fig.8 I²t特性曲线

外形尺寸图



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

整流模块

MD110A

ChunShu Rectifier CO., LTD.

特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	110A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$2.6A \times 10^3$
I_{zt}	$34.4A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			110	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			173	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			2.60	KA
I_{zt}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			34.4	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r_f	斜率电阻		150			1.74	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=330A$	25			1.40	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.570	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.2	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}=1mA(max)$			2500		V
F_m	安装扭矩(M5)					4	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

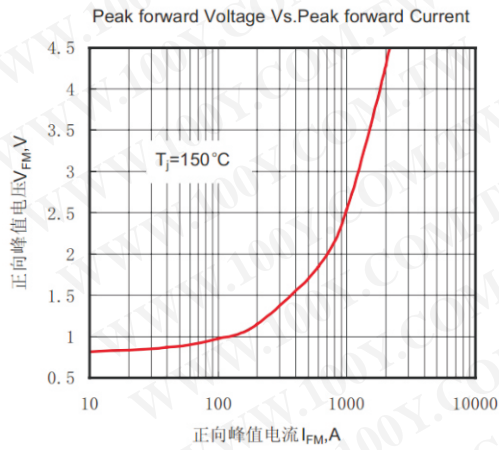


Fig.1 正向伏安特性曲线

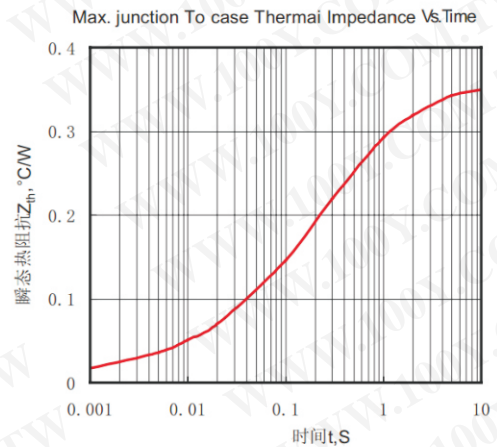


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

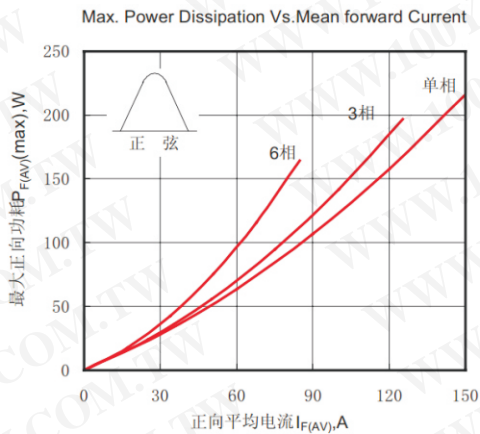


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

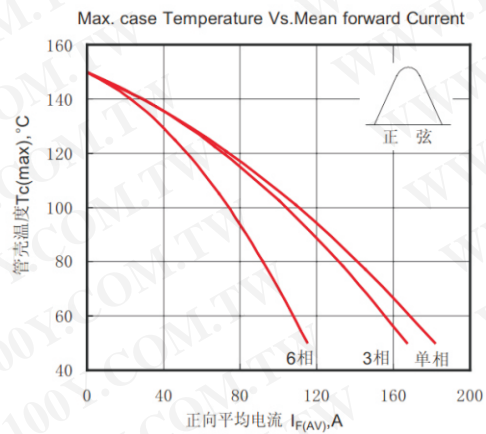


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

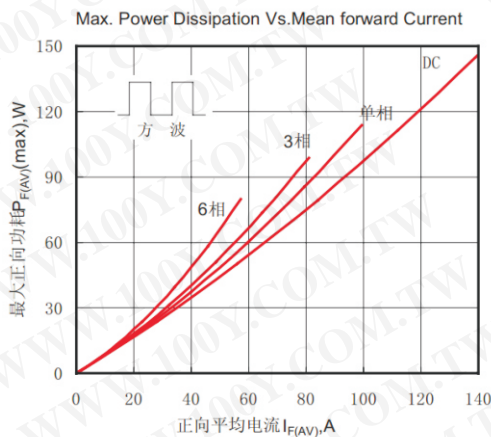


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

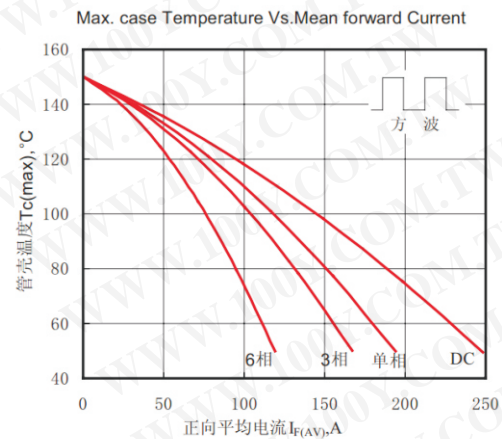


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

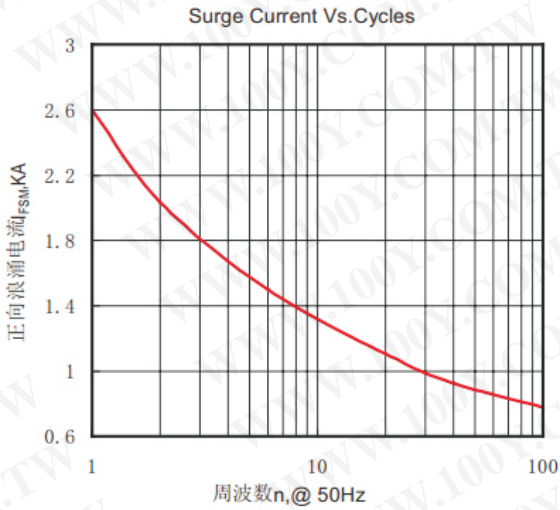


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

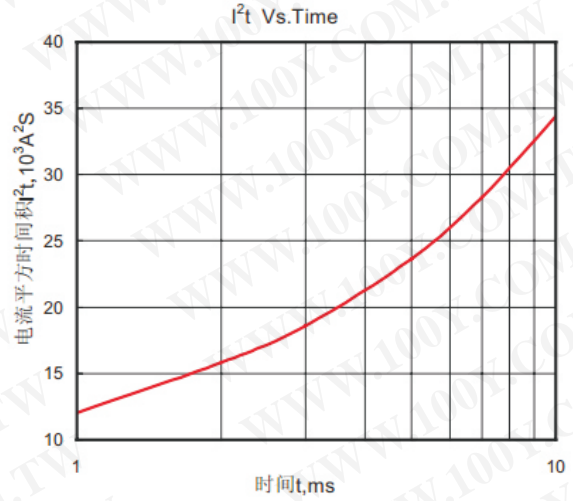
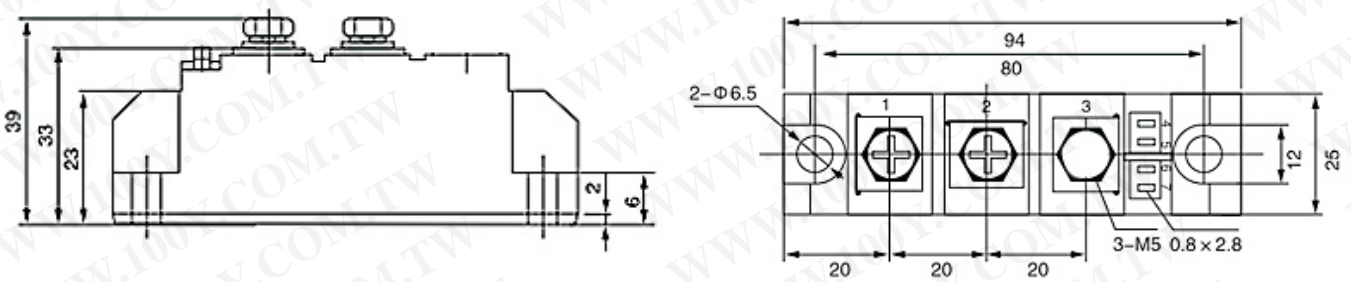


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	130A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$3.9A \times 10^3$
I_{2t}	$77.5A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			130	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			212	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			12	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			3.90	KA
I_{2t}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			77.5	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r_F	斜率电阻		150			1.18	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=410A$	25			1.38	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.310	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.08	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}:1mA(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_f	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

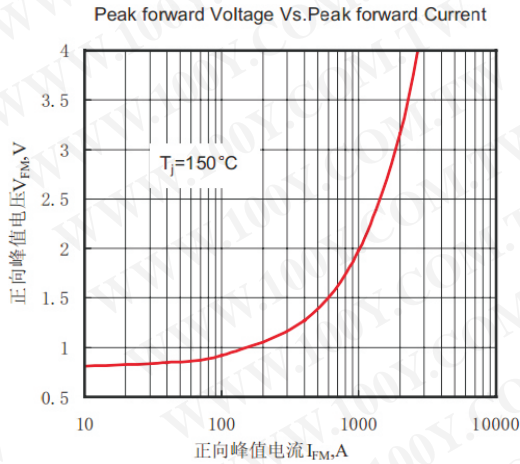


Fig.1 正向伏安特性曲线

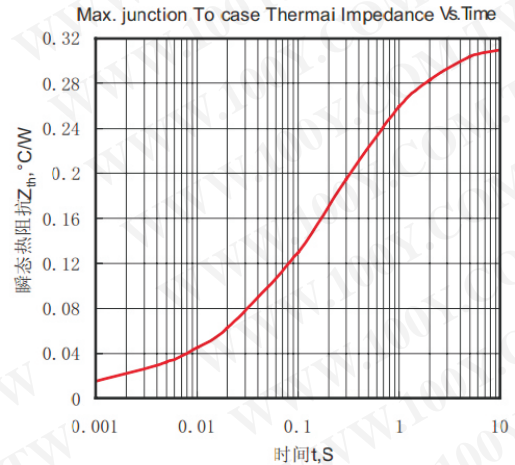


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

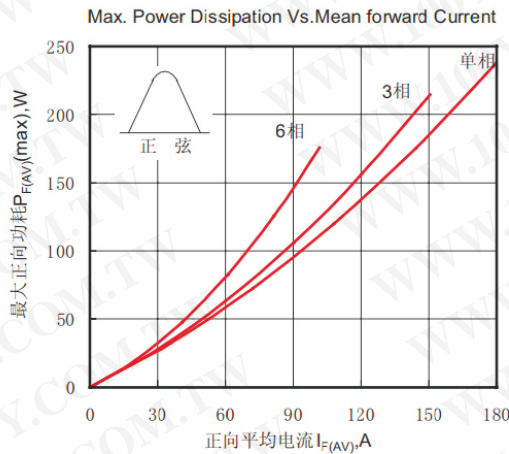


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

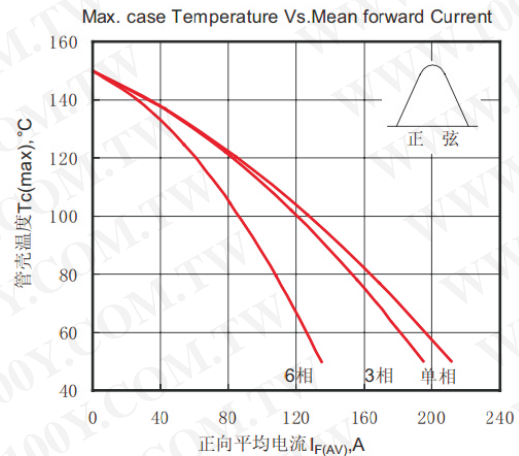


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

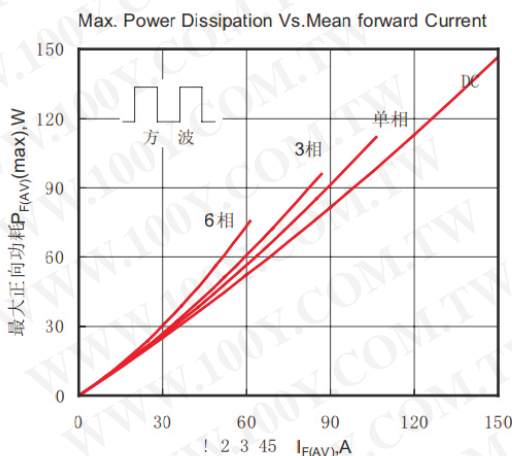


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

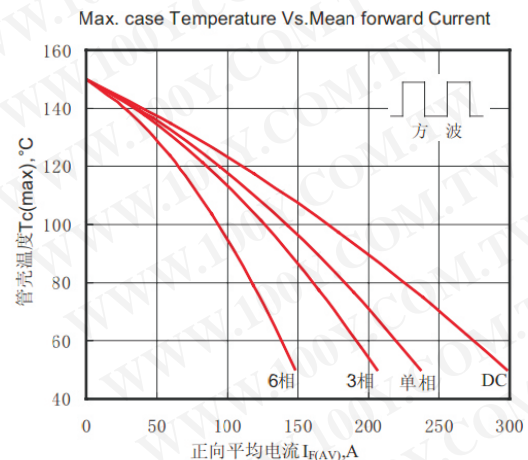


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

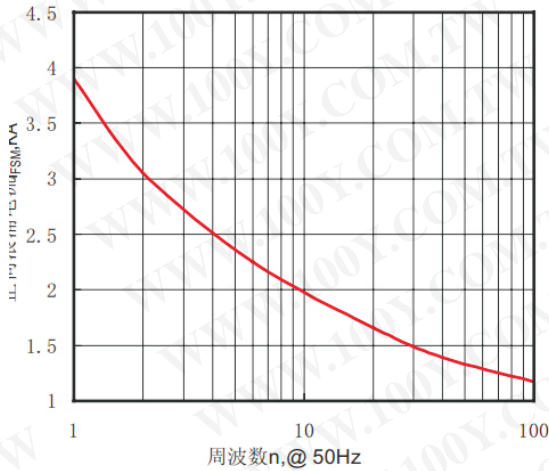


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

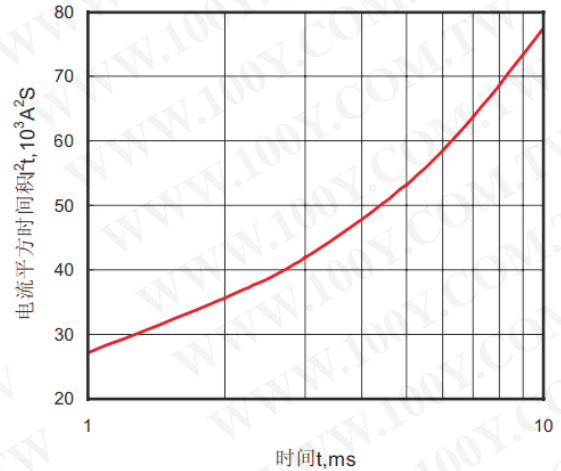
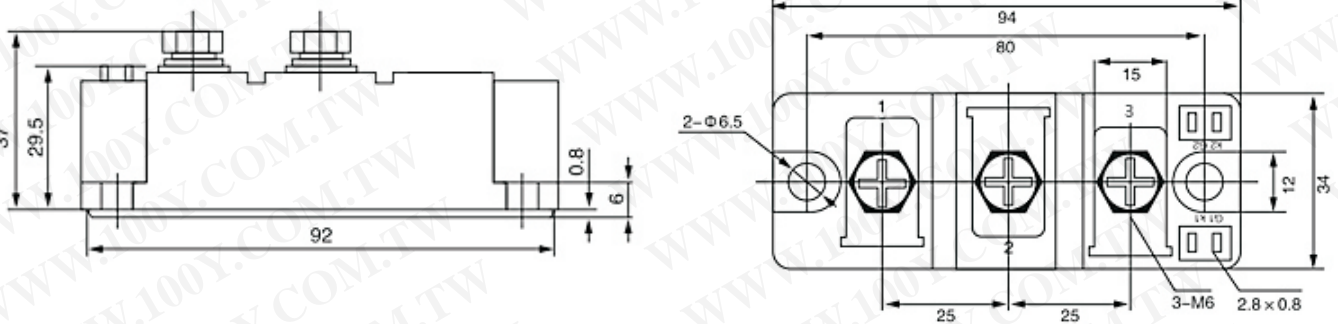


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	160A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$6A \times 10^3$
I_{2t}	$184A^2 \cdot S \cdot 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			160	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			251	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			12	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			6.00	KA
I_{2t}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			184	$A^2 \cdot s \cdot 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r_F	斜率电阻		150			1.35	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=480A$	25			1.56	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.230	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.08	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}: 1mA(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_f	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

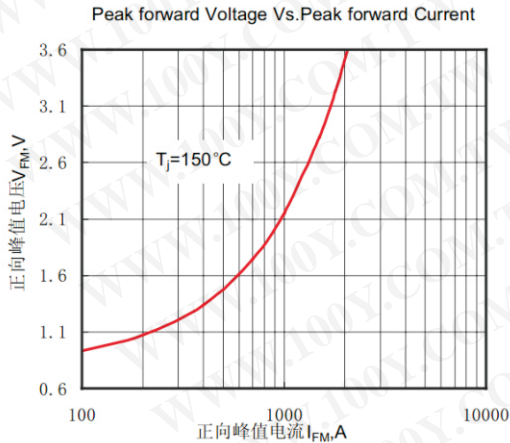


Fig.1 正向伏安特性曲线

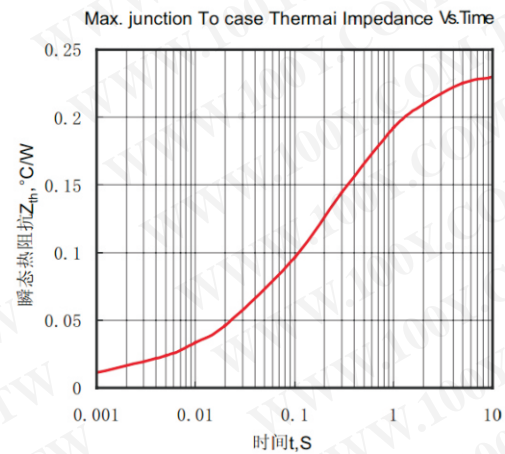


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

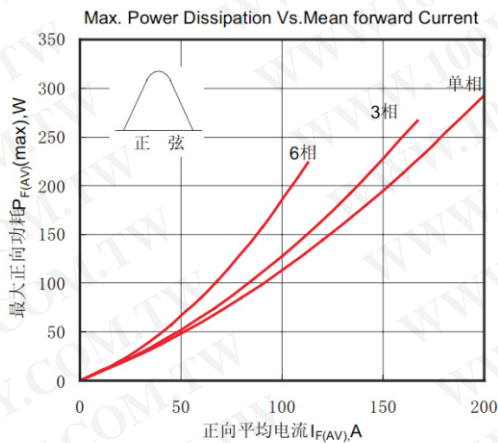


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

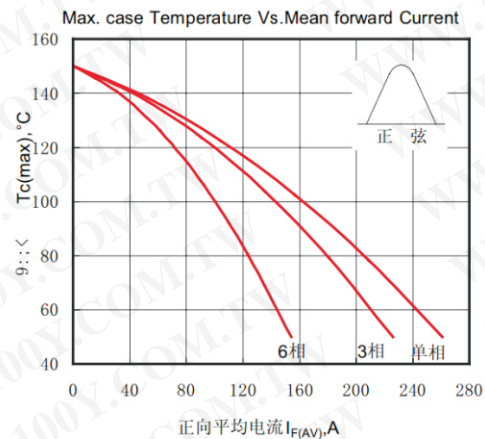


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

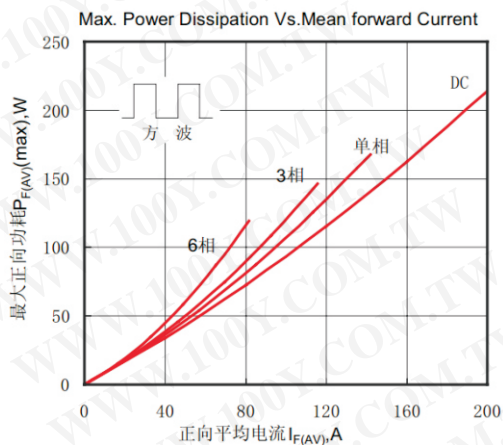


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

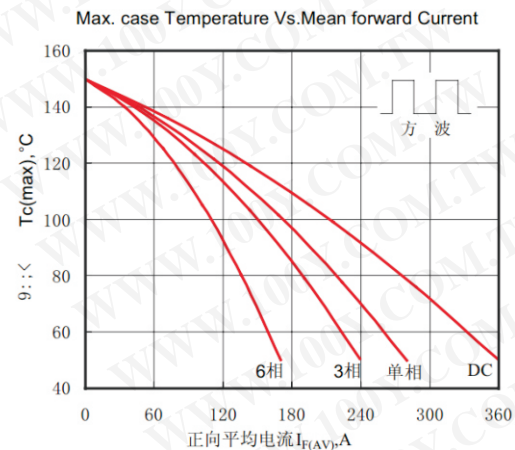


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

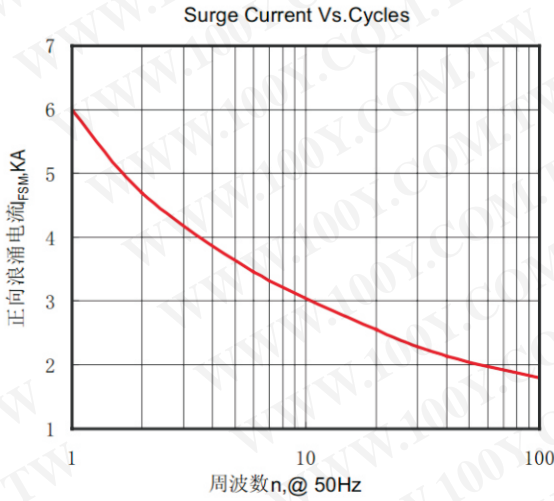


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

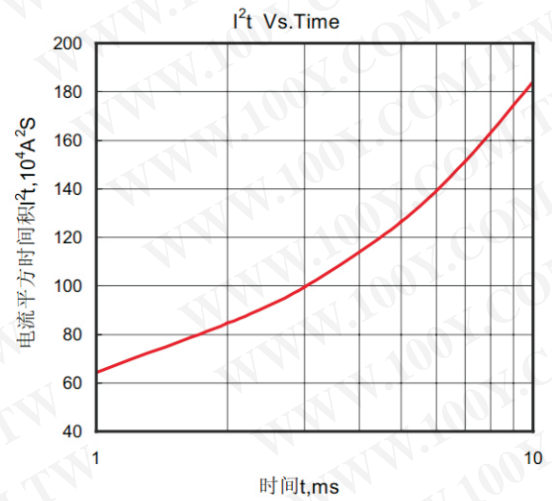
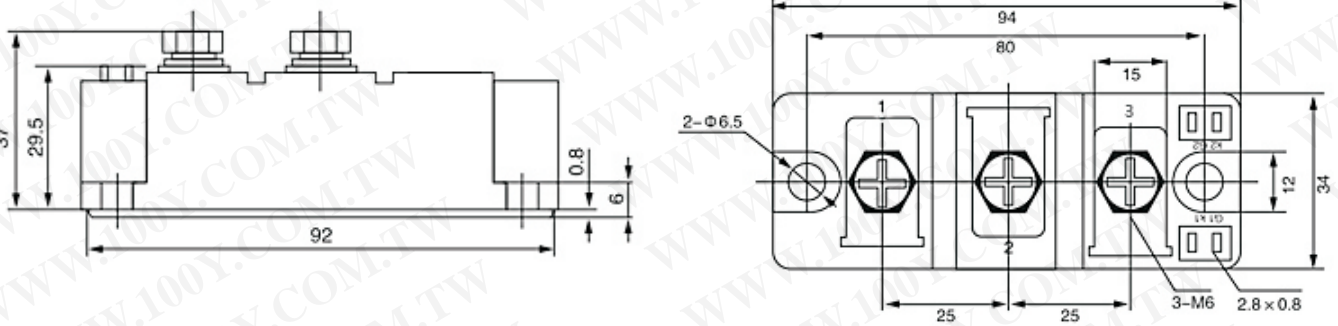


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	200A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$8A \times 10^3$
I_{2t}	$326A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150		200		A
I_{FRMS}	方均根电流		150		314		A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	1600			V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150		12		mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150		8.00		KA
I_{2t}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150		326		$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150		0.75		V
r_F	斜率电阻		150		0.88		m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=600A$	25		1.38		V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热			0.210		$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热			0.08		$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}=1mA(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_f	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

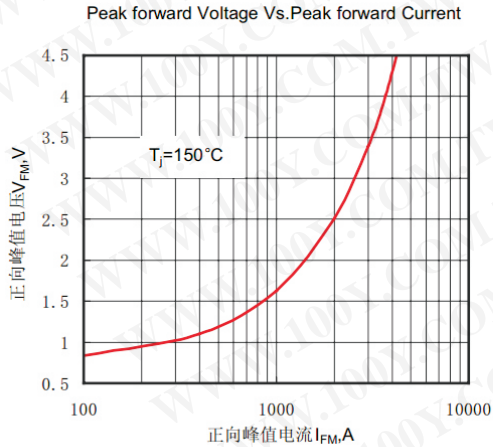


Fig.1 正向伏安特性曲线

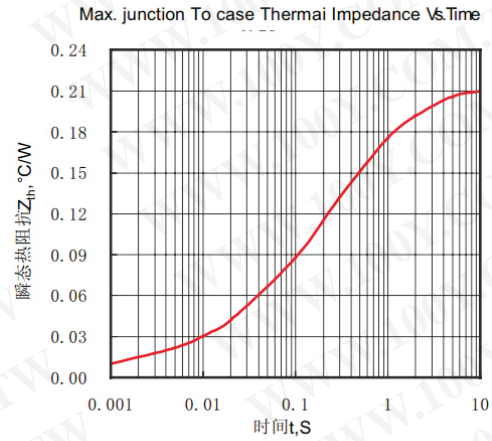


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

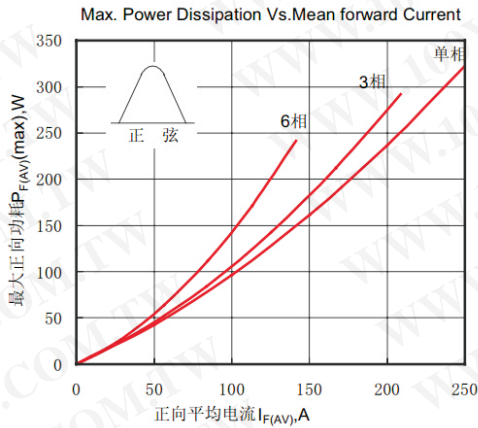


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

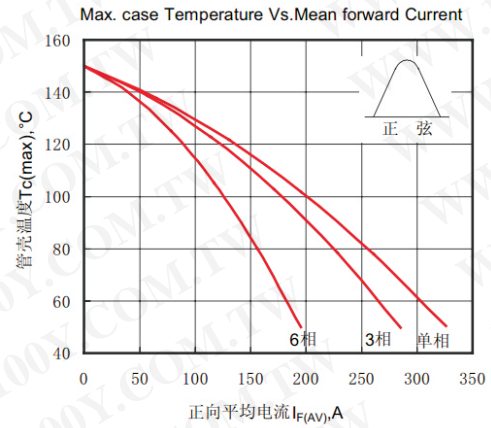


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

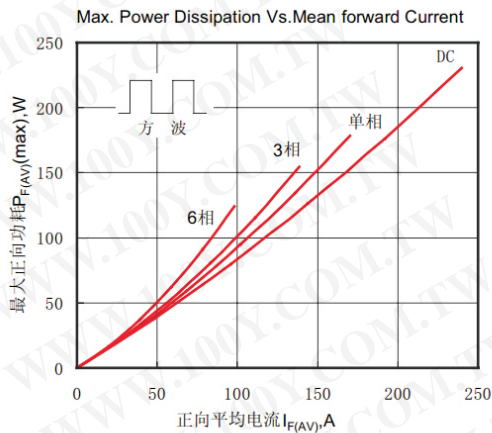


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

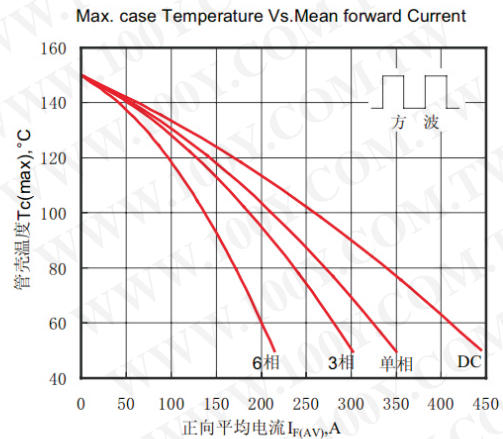


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

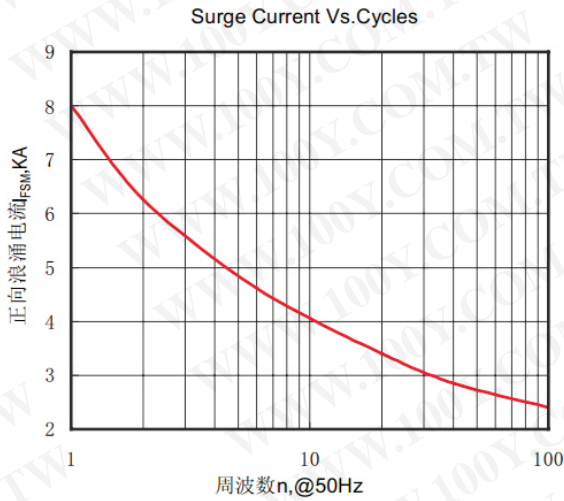


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

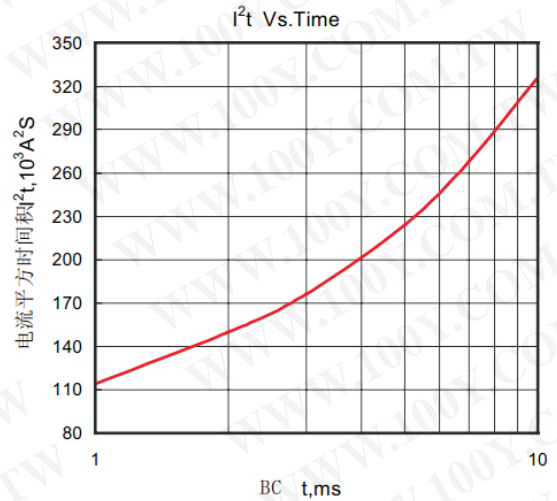
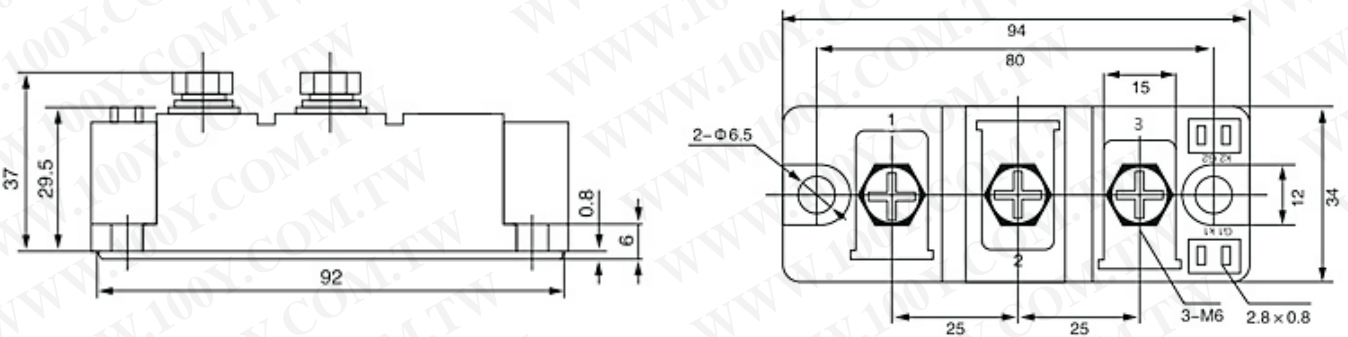


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV} 250A
 V_{RRM} 1600V
 I_{FSM} $11A \times 10^3$
 I_{t^2} $617A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^\circ C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^\circ C$	150			250	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			393	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			20	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			11.0	KA
I_{t^2}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			617	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.76	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=750A$	25			1.43	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.140	$^\circ C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.04	$^\circ C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}=1mA(max)$			2500		V
F_m	安装扭矩(M8)					12	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^\circ C$
W_l	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

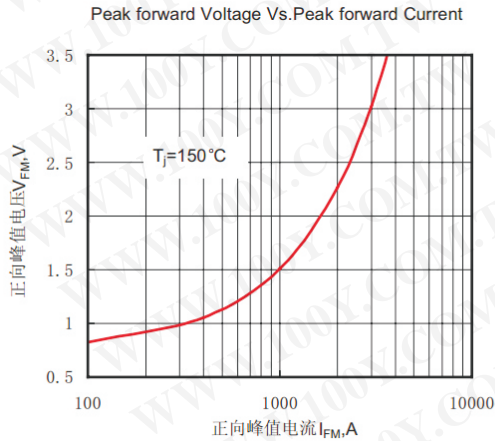


Fig.1 正向伏安特性曲线

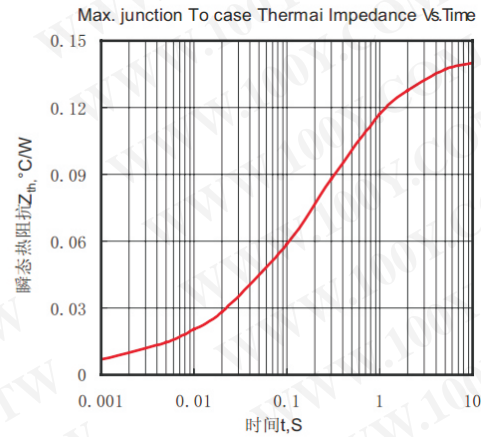


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

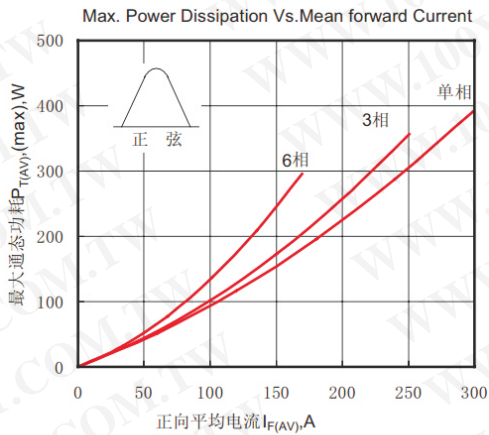


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

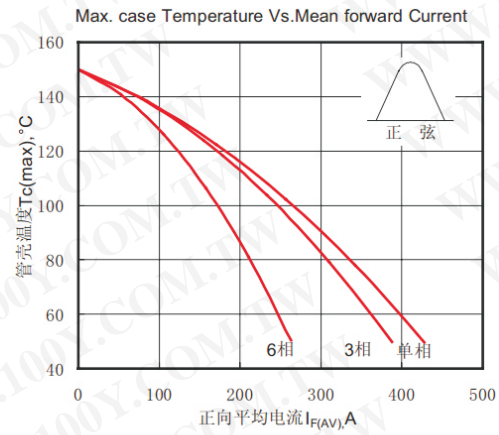


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

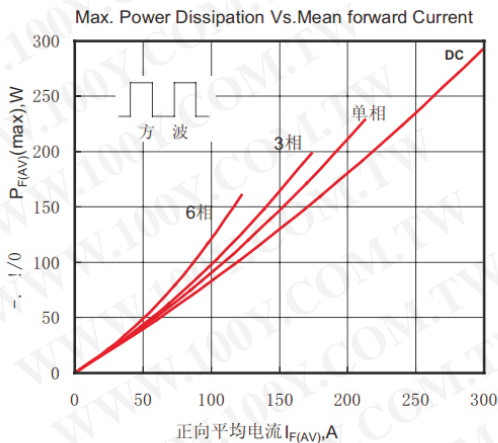


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

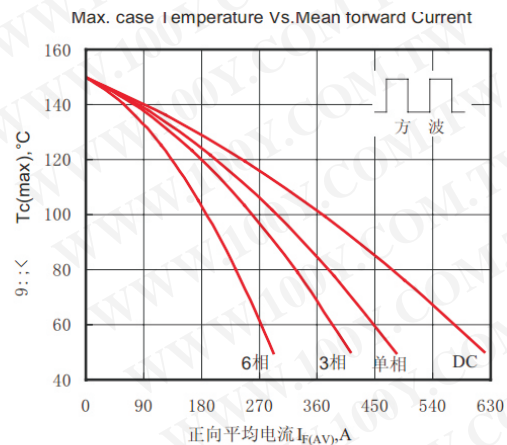


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

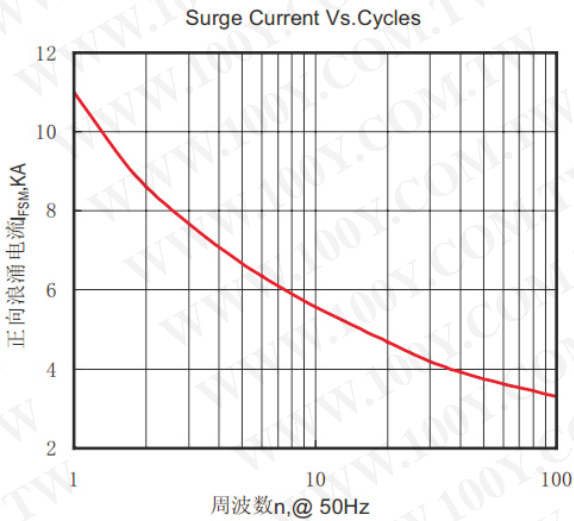


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

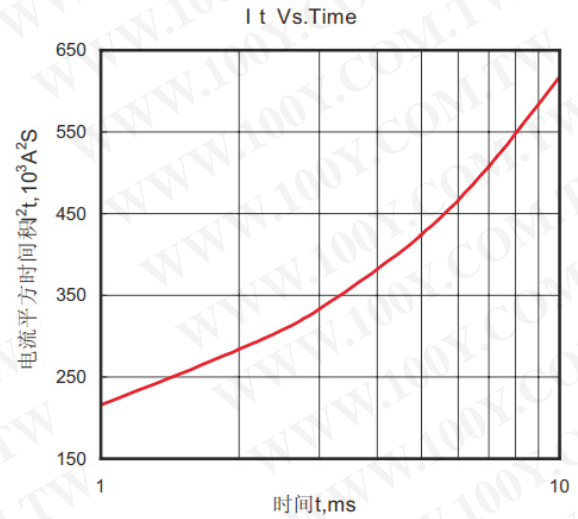
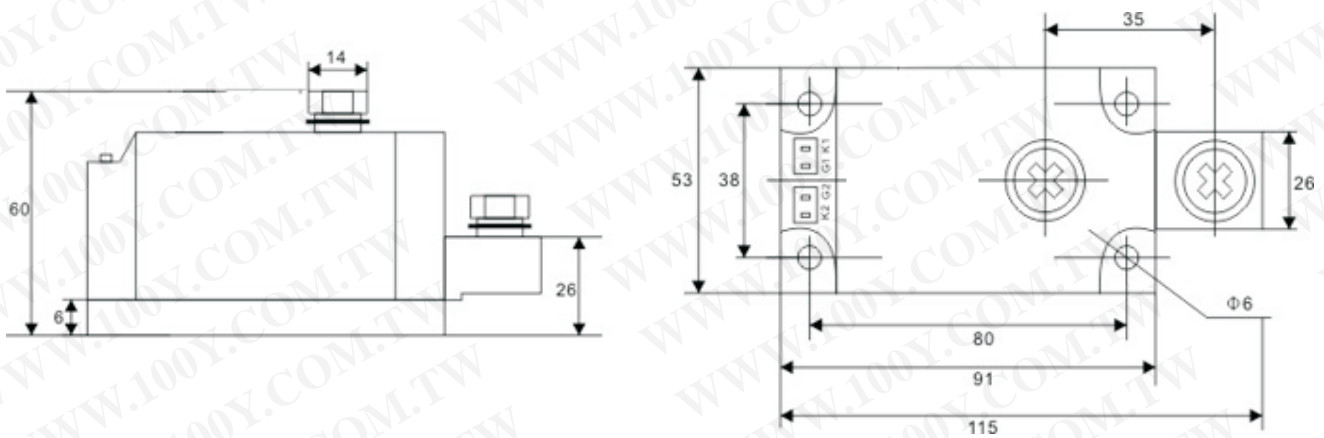


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	25A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$0.65A \times 10^3$
I_{zt}	$2.1A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^\circ C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^\circ C$	150			25	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			41	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			0.65	KA
I_{zt}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			2.1	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r_f	斜率电阻		150			9.80	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=80A$	25			1.65	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				1.300	$^\circ C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.2	$^\circ C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}=1mA(max)$			2500		V
F_m	安装扭矩(M5)				4		N·m
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^\circ C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

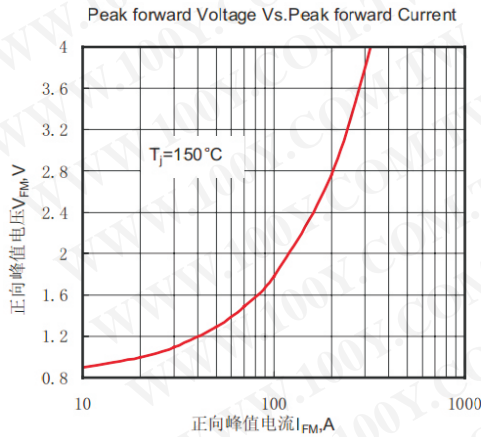


Fig.1 正向伏安特性曲线

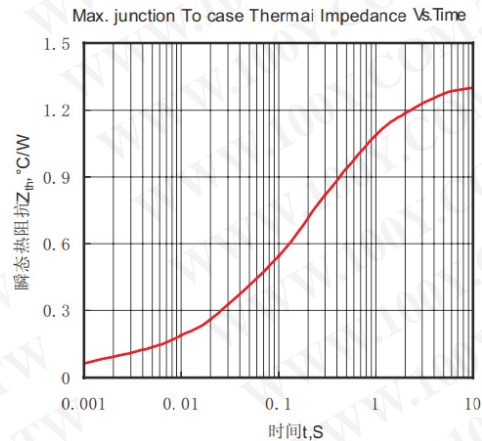


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

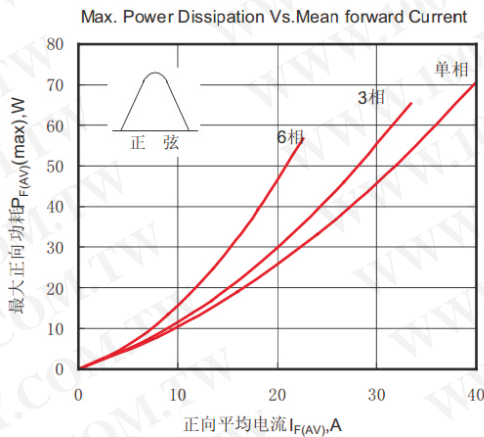


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

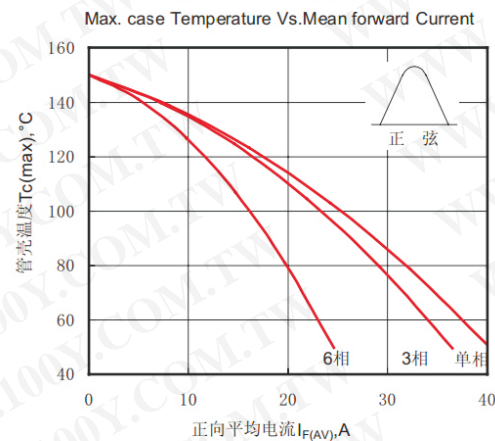


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

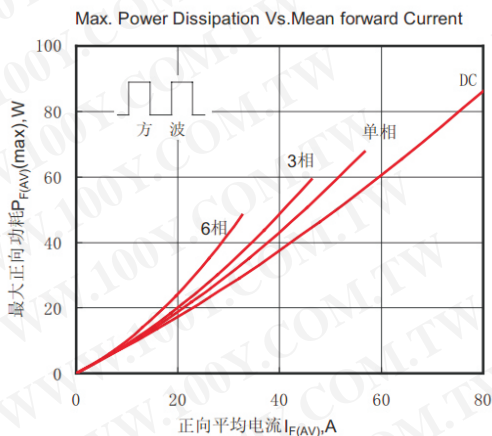


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

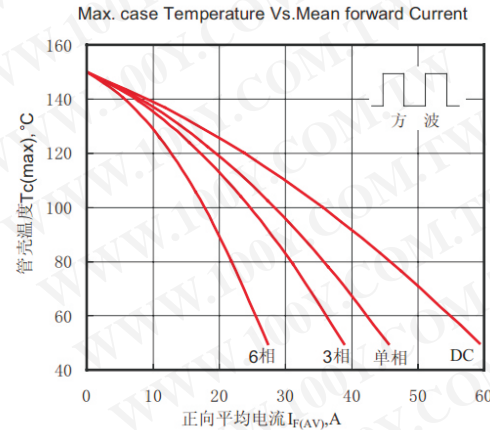


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

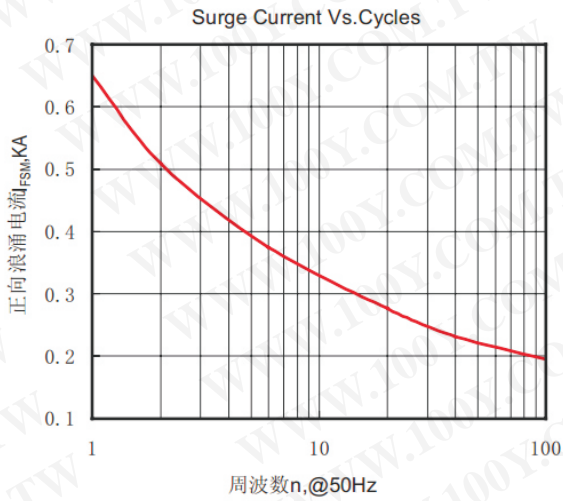


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

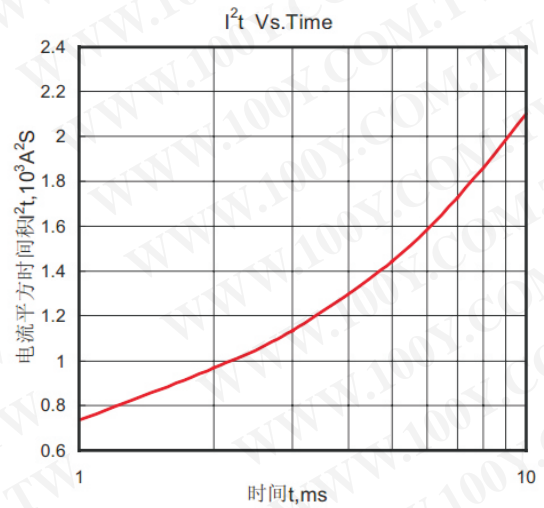
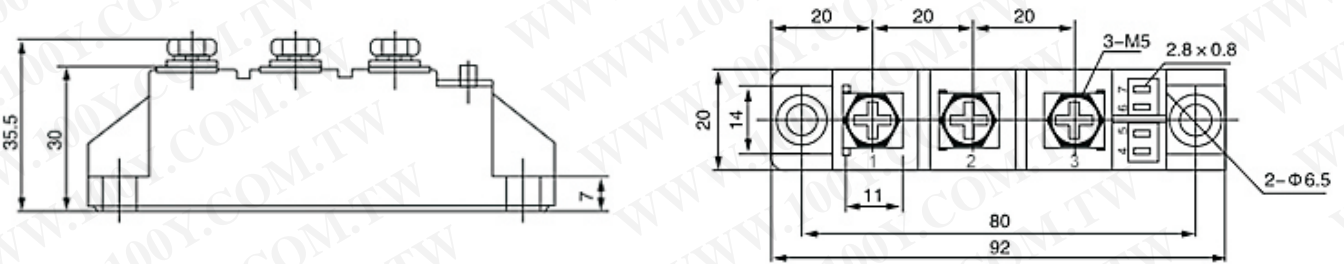


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	300A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$12.5A \times 10^3$
I_{zt}	$797A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			300	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			471	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			20	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			12.5	KA
I_{zt}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			797	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.55	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=900A$	25			1.35	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}=1mA(max)$			2500		V
F_m	安装扭矩(M8)					12	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_l	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

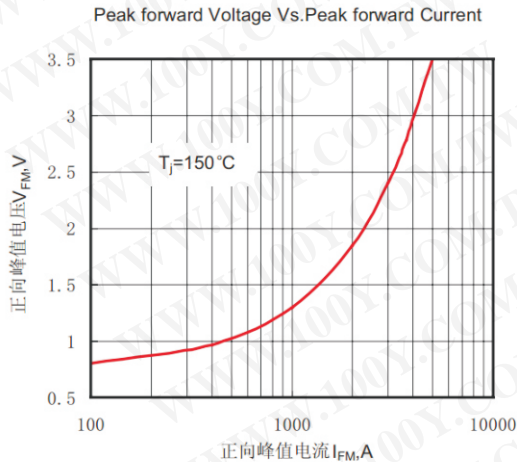


Fig.1 正向伏安特性曲线

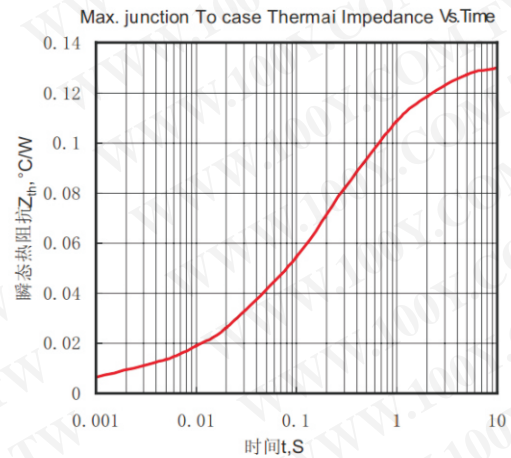


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

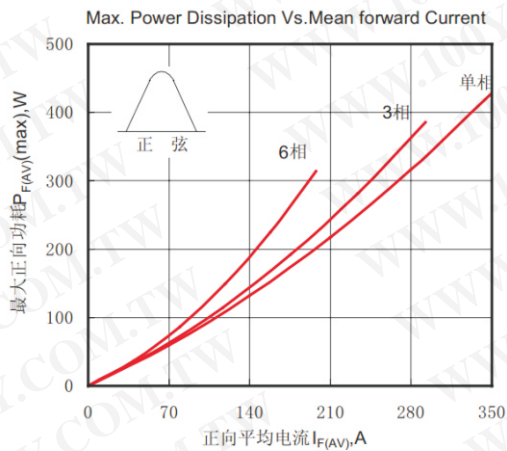


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

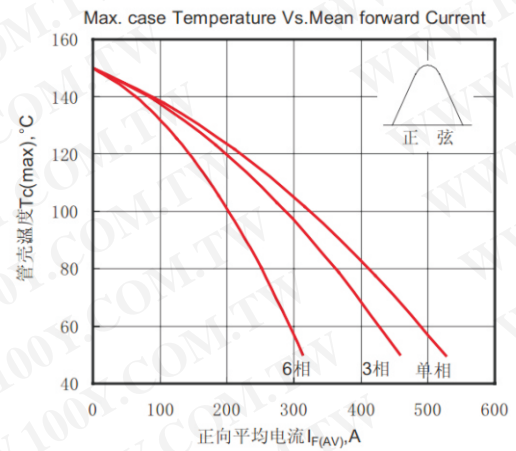


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

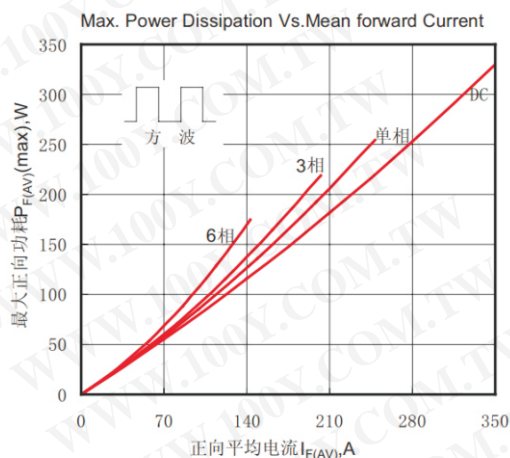


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

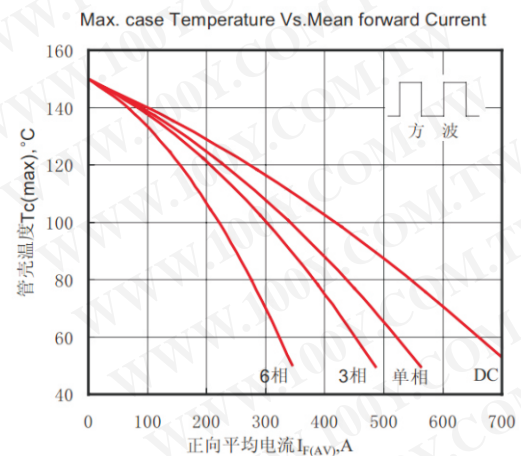


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

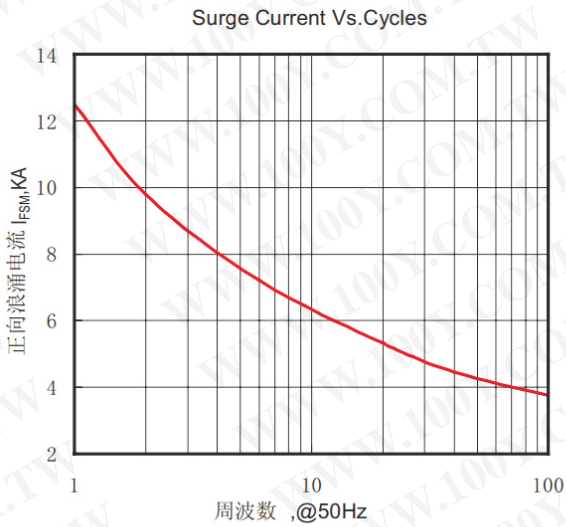


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

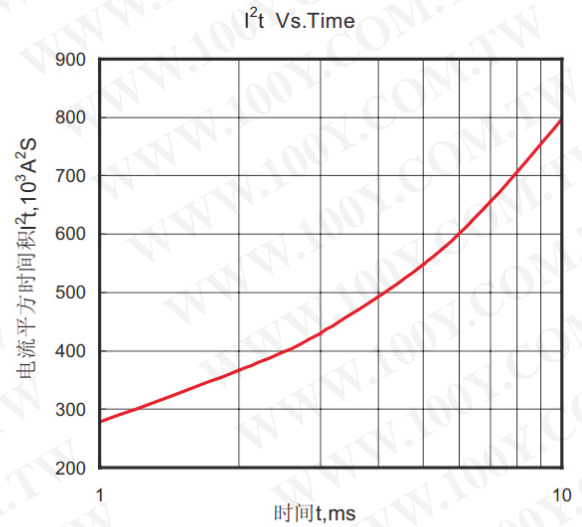
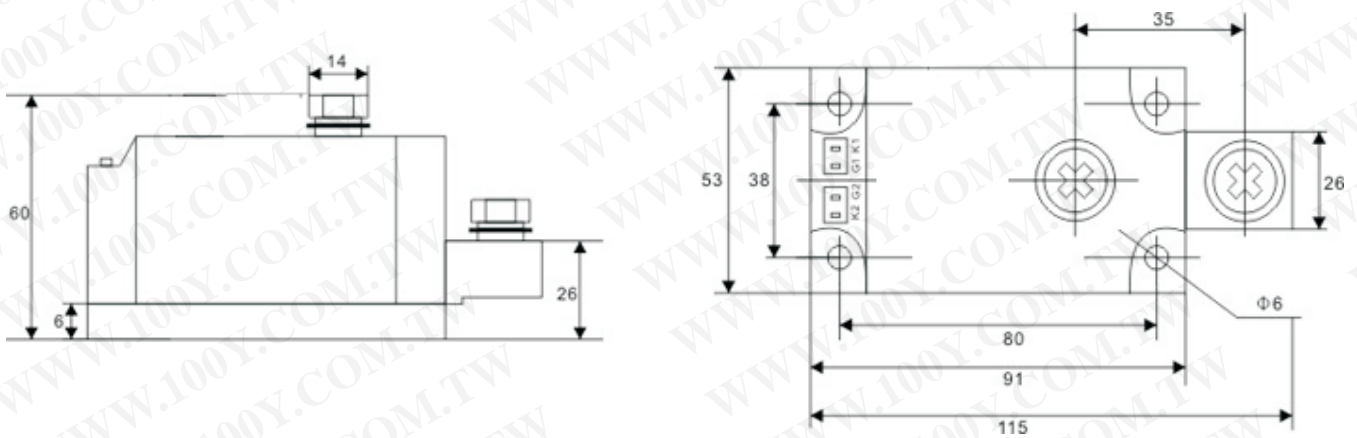


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

- | | | |
|------------|-----------|------------------------|
| 1. 交直流电机控制 | I_{FAV} | 400A |
| 2. 各种整流电源 | V_{RRM} | 1600V |
| 3. 变频器 | I_{FSM} | $15A \times 10^3$ |
| | I_{2t} | $1150A^2S \times 10^3$ |



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^\circ C$	$T_j(^\circ C)$				A
I_{FRMS}	方均根电流		150			400	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			30	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			17.0	KA
I_{2t}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			1470	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.50	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=1200A$	25			1.48	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.100	$^\circ C / W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.04	$^\circ C / W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}: 1mA(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M10)				12		N · m
F_m	安装扭矩(M6)				6		N · m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^\circ C$
W_f	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

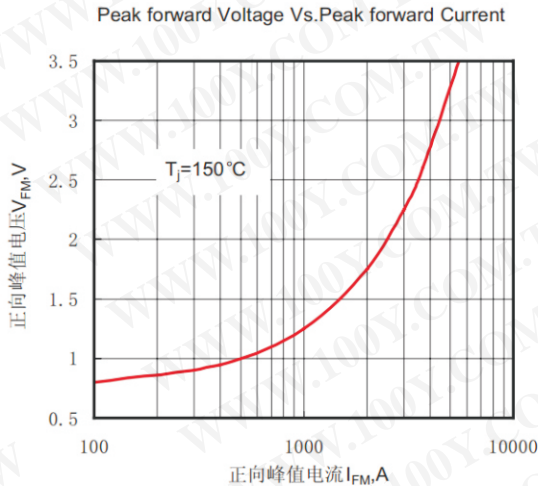


Fig.1 正向伏安特性曲线

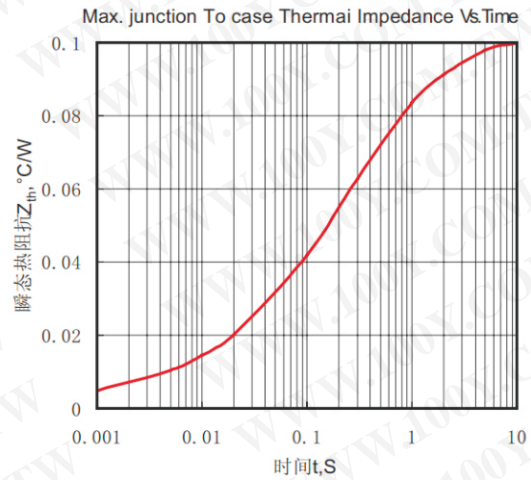


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

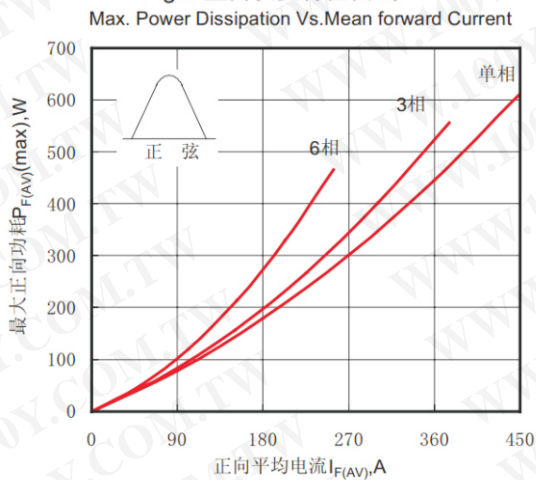


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线。

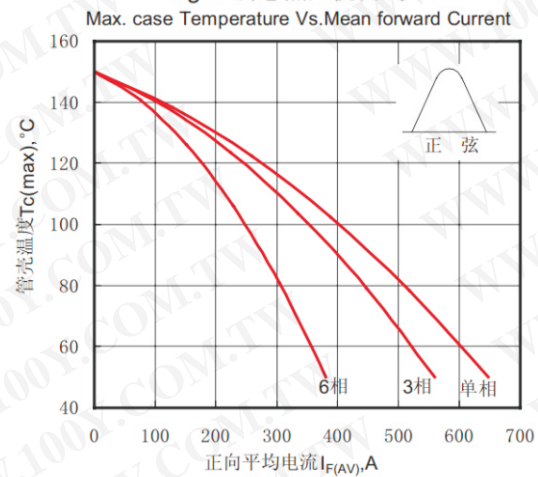


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

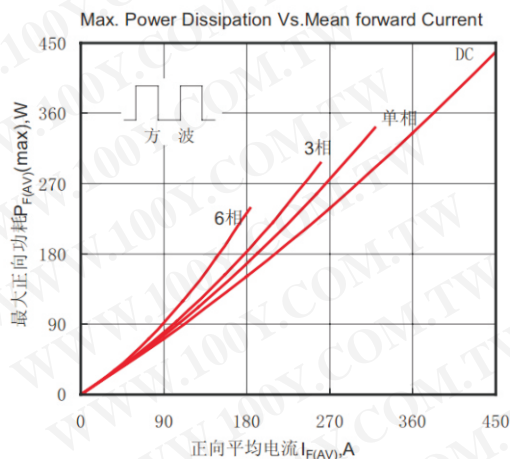


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

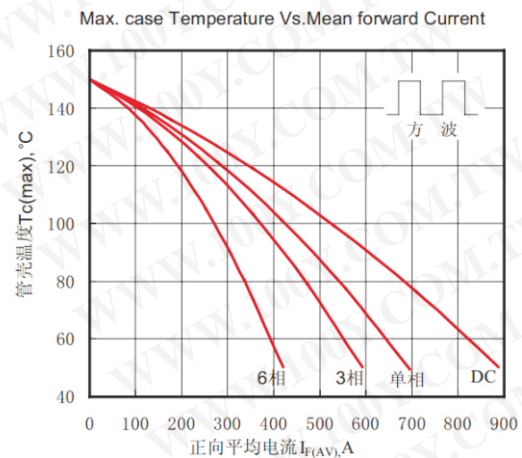


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

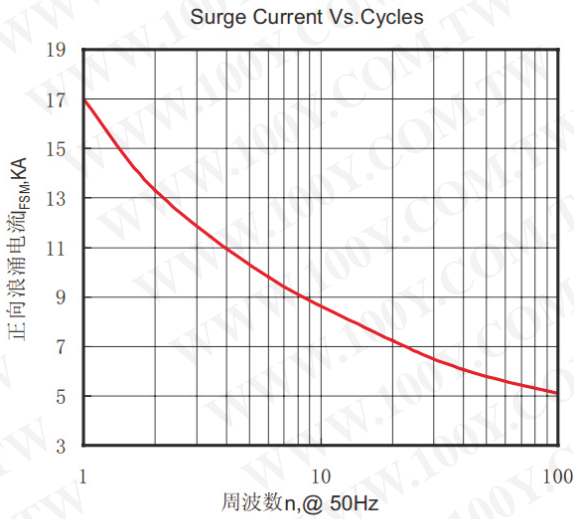


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

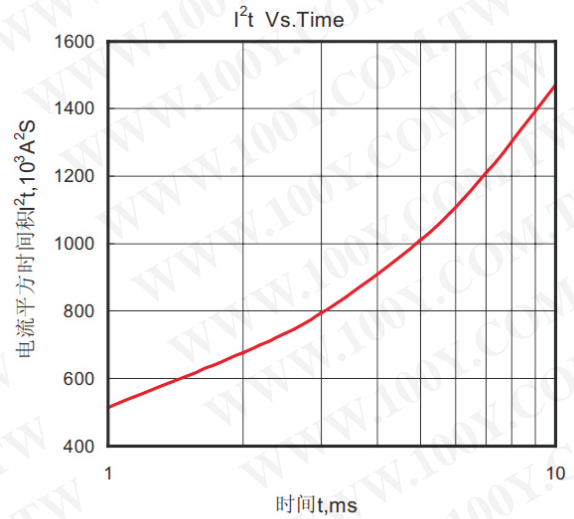
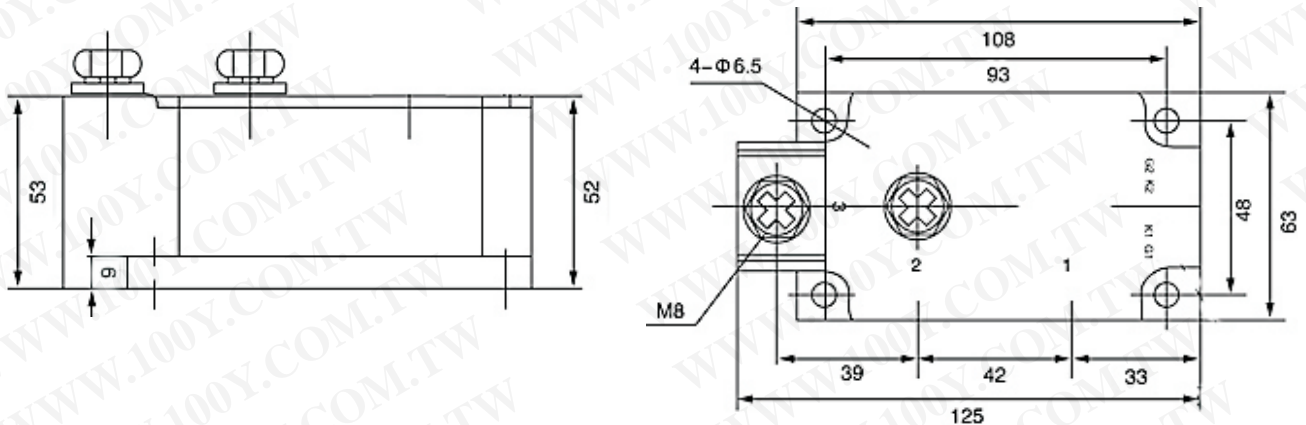


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	500A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$21A \times 10^3$
I_{2t}	$2250A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^\circ C$	$T_j(^\circ C)$				A
I_{FRMS}	方均根电流		150			500	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			40	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			21.0	KA
I_{2t}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			2250	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.32	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=1500A$	25			1.35	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.090	$^\circ C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.024	$^\circ C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}:1mA(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M10)				12		N·m
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^\circ C$
W_f	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

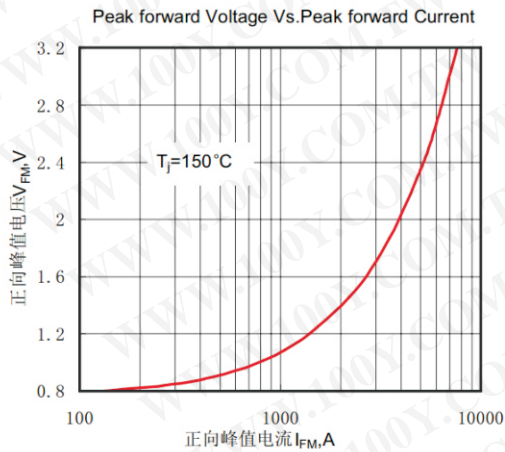


Fig.1 正向伏安特性曲线

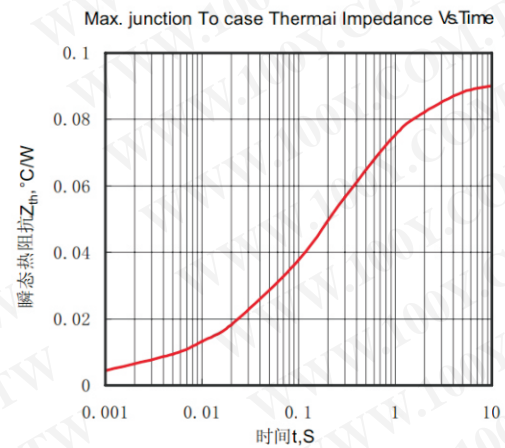


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

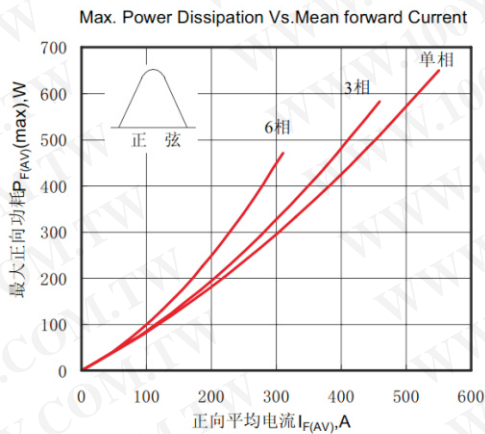


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

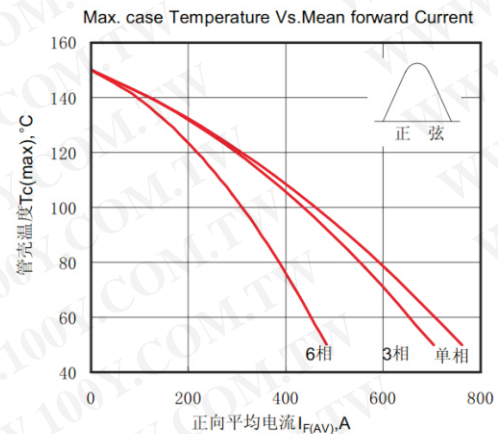


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

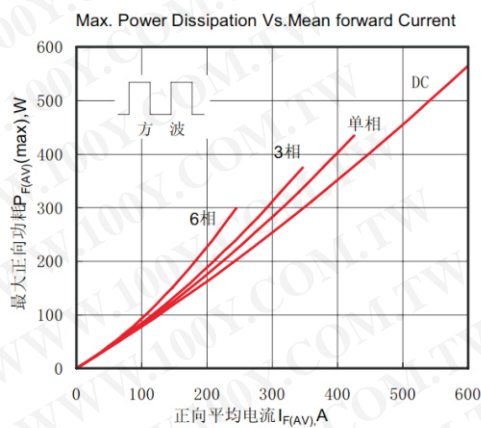


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

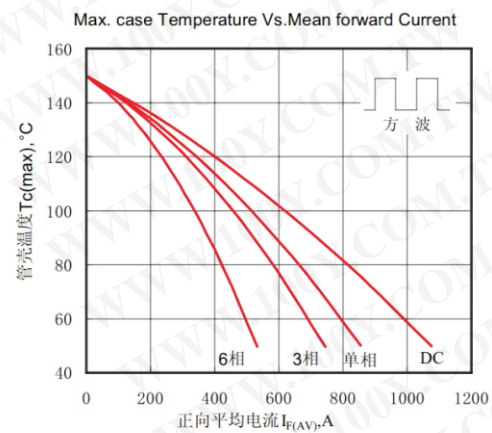


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

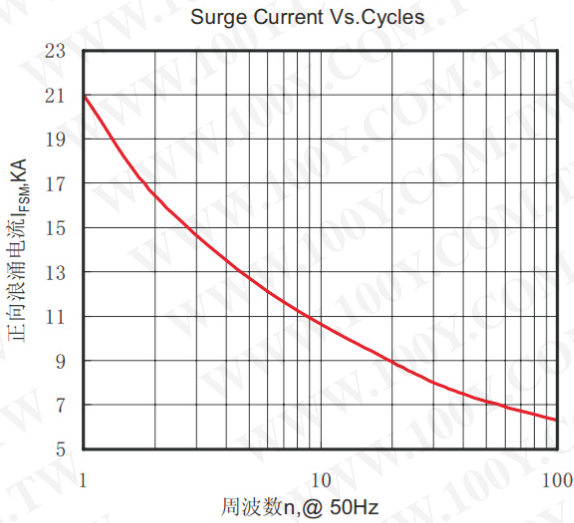


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

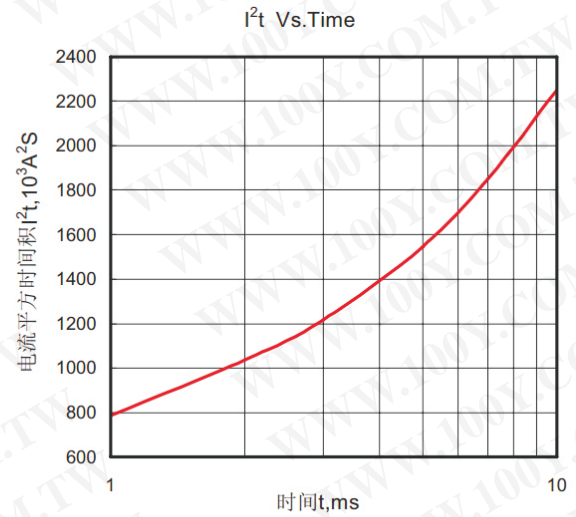
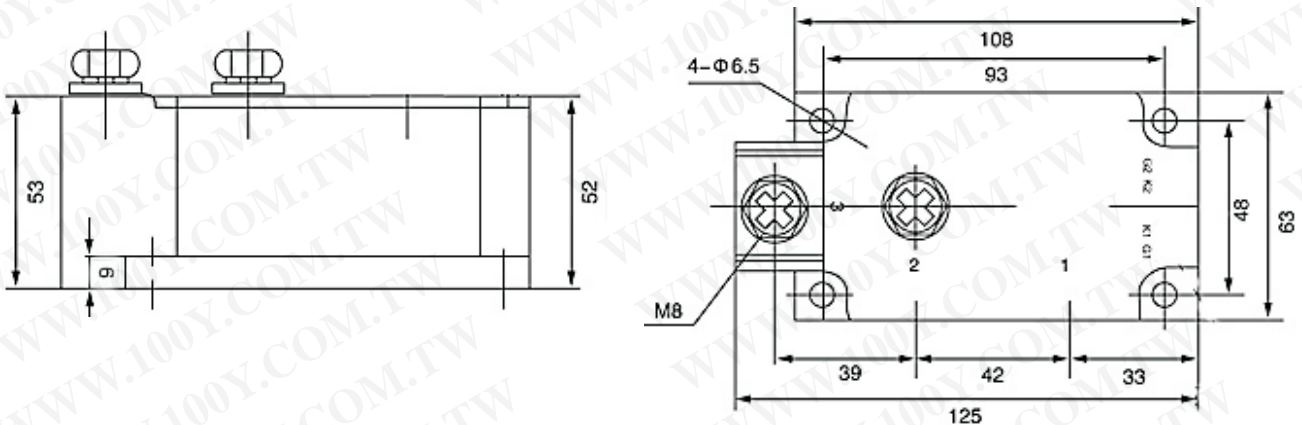


Fig.8 I²t特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	55A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$1.3A \times 10^3$
I_{zt}	$8.6A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			55	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			86	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	1600			V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			1.3	KA
I_{zt}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			8.6	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.80	V
r_f	斜率电阻		150			3.47	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=170A$	25			1.45	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.700	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				0.2	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}=1mA(max)$		2500			V
F_m	安装扭矩(M5)				4		N·m
F_m	安装扭矩(M6)				6		N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

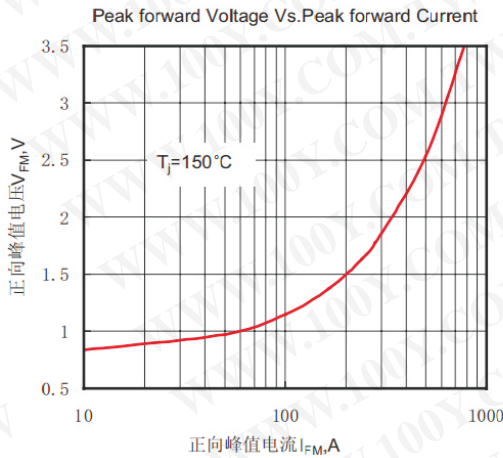


Fig.1 正向伏安特性曲线

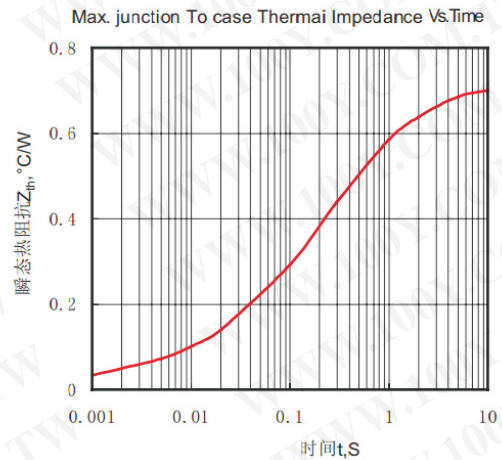


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

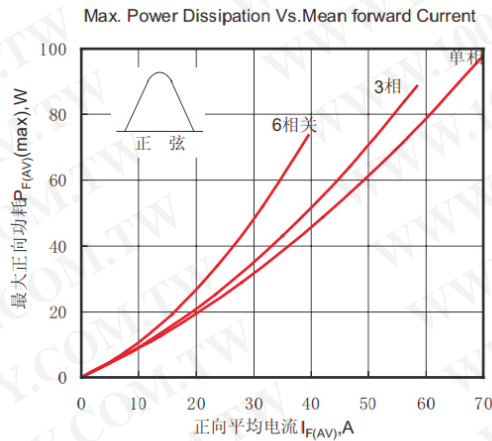


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

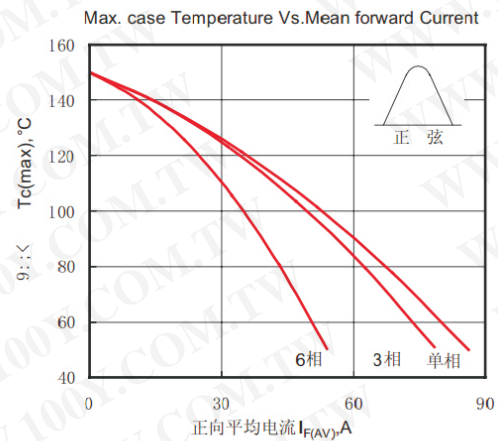


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

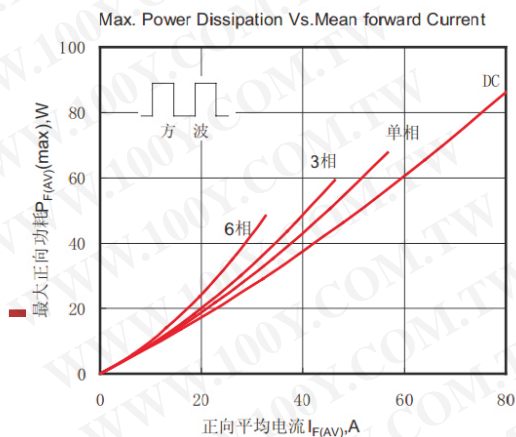


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

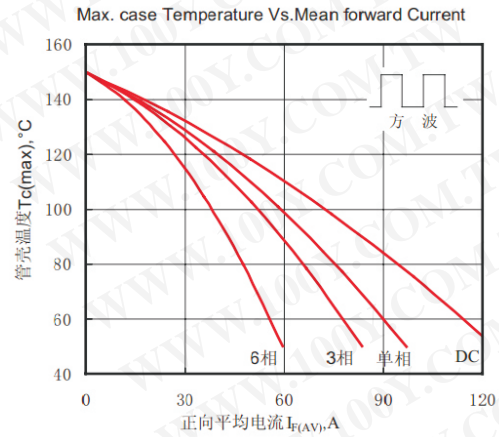


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

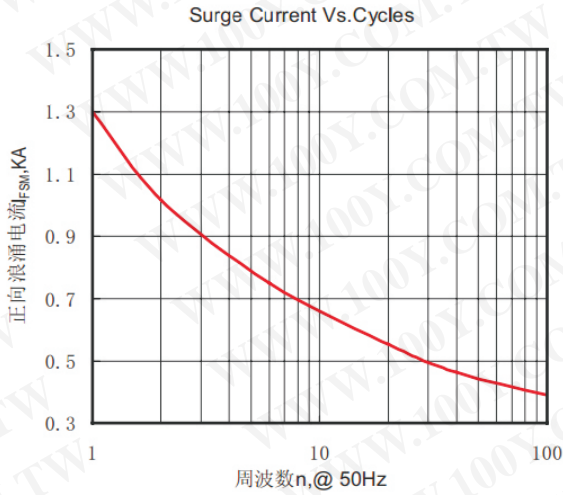


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

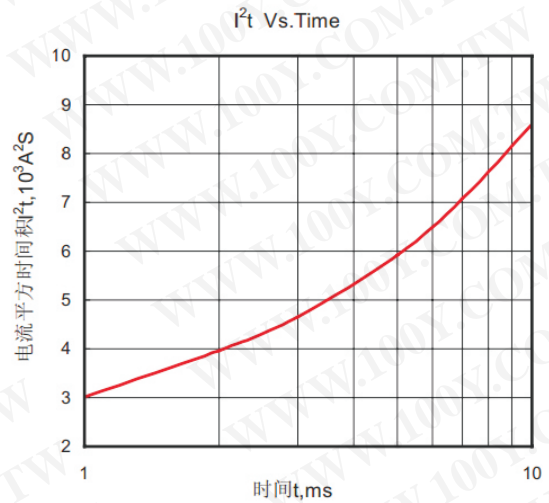
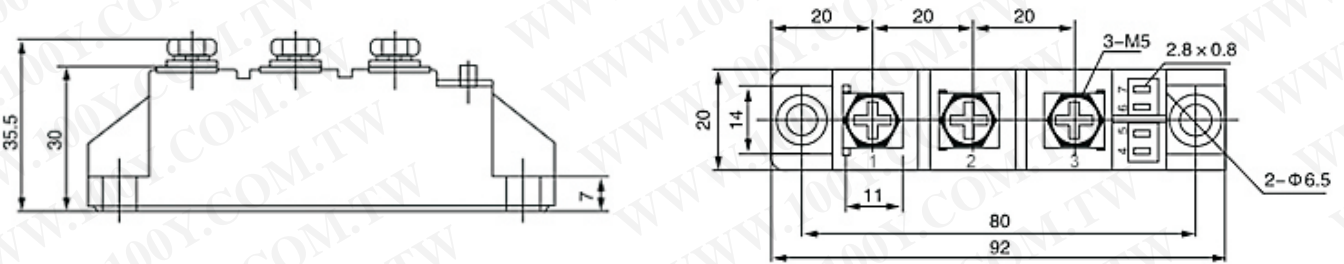


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	600A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$15A \times 10^3$
I_{2t}	$1150A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			600	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			1256	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} $t_p=10ms$, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			45	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			18.0	KA
I_{2t}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			1650	$A^2s \times 10^3$
V_{FO}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.33	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=2400A$	25			1.80	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.080	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热					$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min$, $I_{iso}: 1mA(max)$			2500		V
F_m	安装扭矩(M12)					14	N·m
F_m	安装扭矩(M8)					12	N·m
T_{stg}	贮存温度					-40	$^{\circ}C$
W_l	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

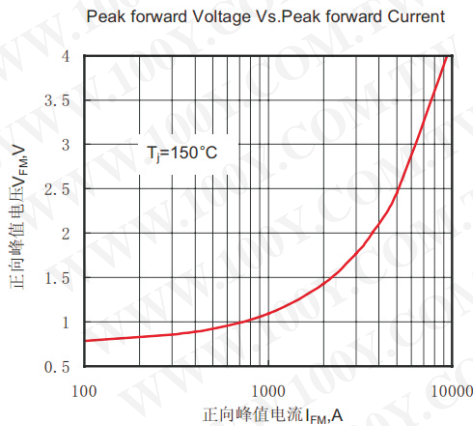


Fig.1 正向伏安特性曲线

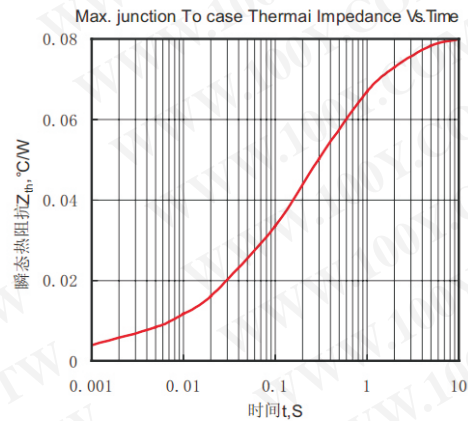


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

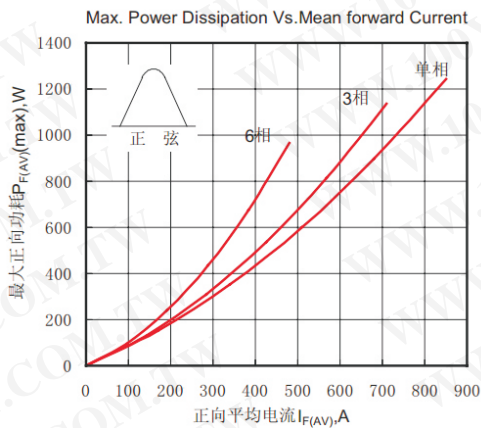


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

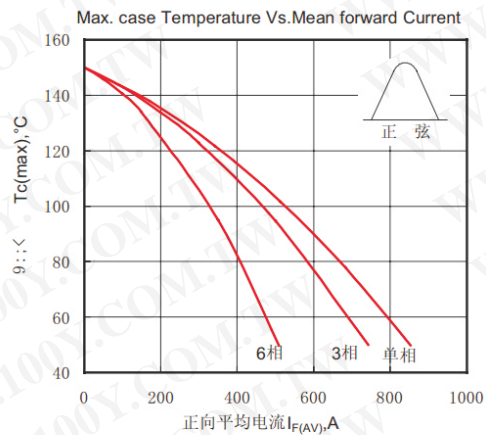


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

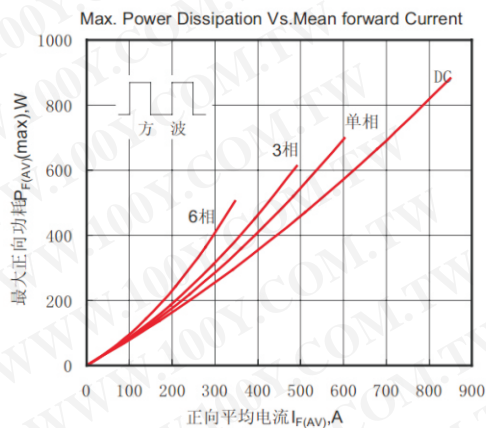


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

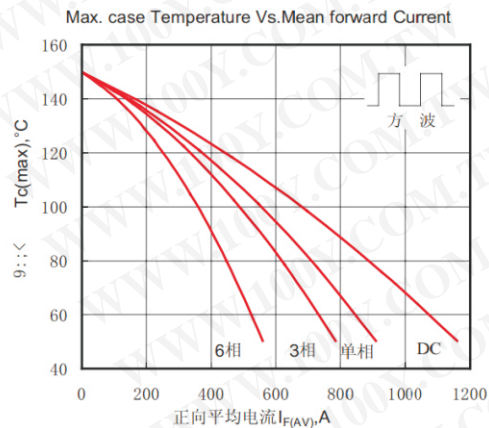


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

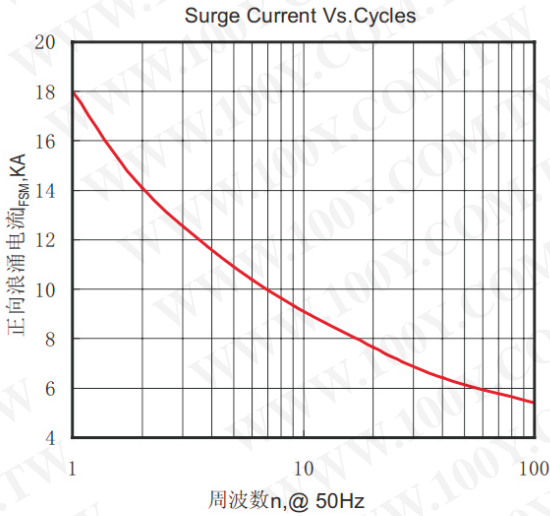


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

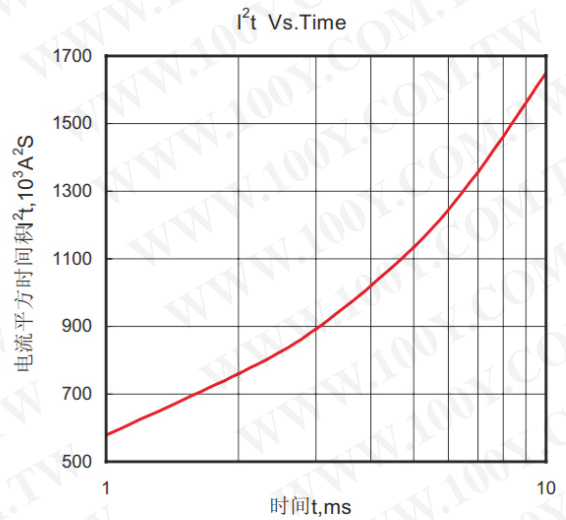
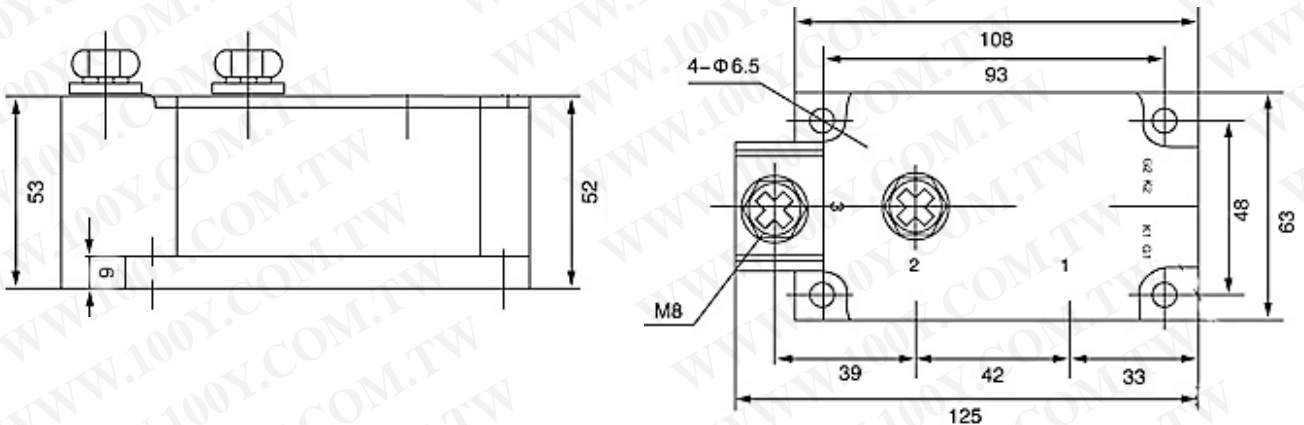


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV} 800A
 V_{RRM} 1600V
 I_{FSM} $15A \times 10^3$
 I_{2t} $1150A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150		800	A	
I_{FRMS}	方均根电流		150		1256	A	
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} t_p=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	1600		V	
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150		45	mA	
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150		18.0	KA	
I_{2t}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150		1650	$A^2s \times 10^3$	
V_{FO}	门槛电压		150		0.75	V	
r_F	斜率电阻		150		0.33	m Ω	
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=2400A$	25		1.80	V	
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热			0.080	$^{\circ}C/W$	
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热				$^{\circ}C/W$	
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}: 1mA(max)$		2500		V	
F_m	安装扭矩(M12)				12	N·m	
F_m	安装扭矩(M8)				8	N·m	
T_{stg}	贮存温度			-40	125	$^{\circ}C$	
W_f	质量					g	
Size	包装盒尺寸					mm	

性能曲线图

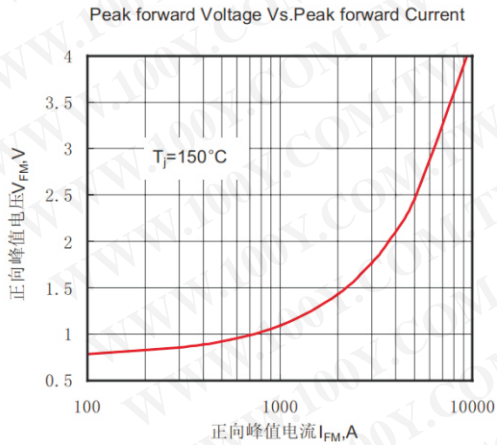


Fig.1 正向伏安特性曲线

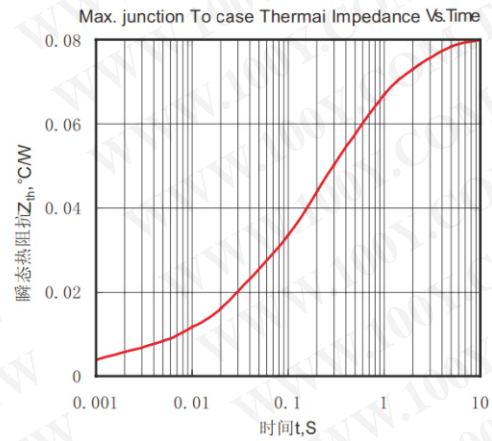


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

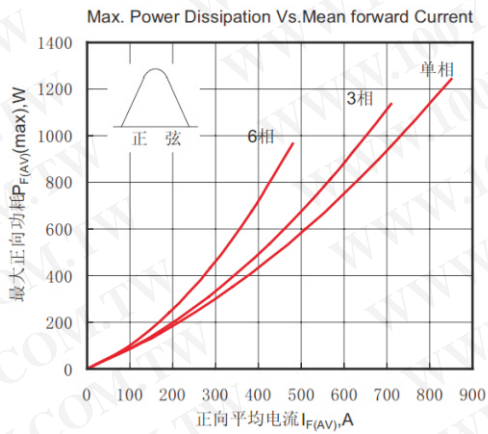


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

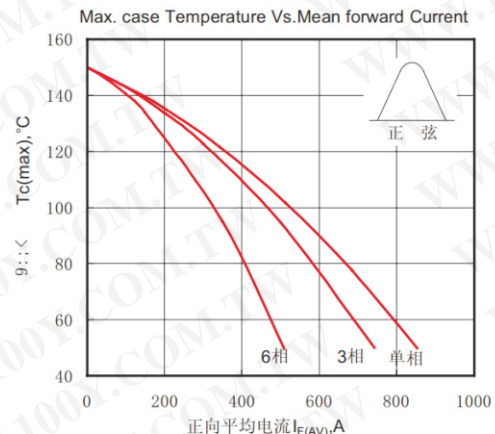


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

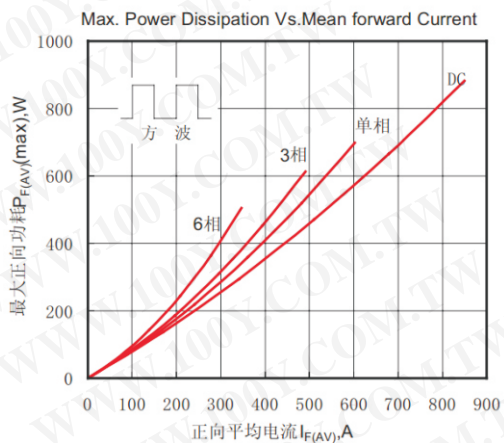


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

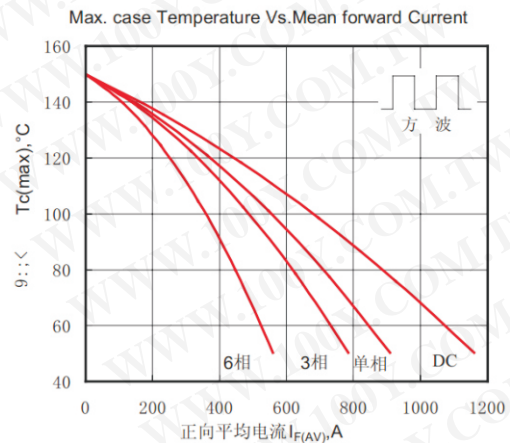


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

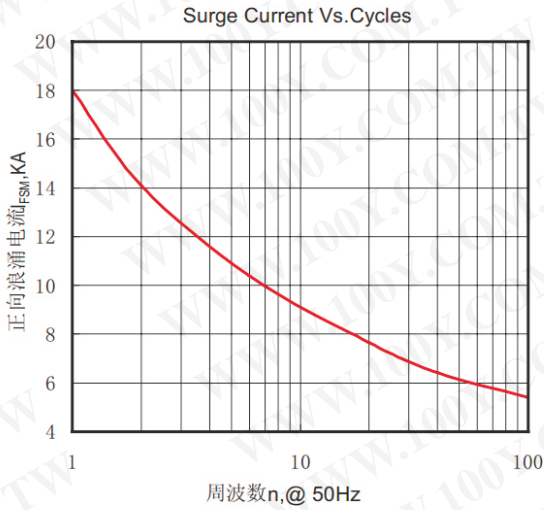


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

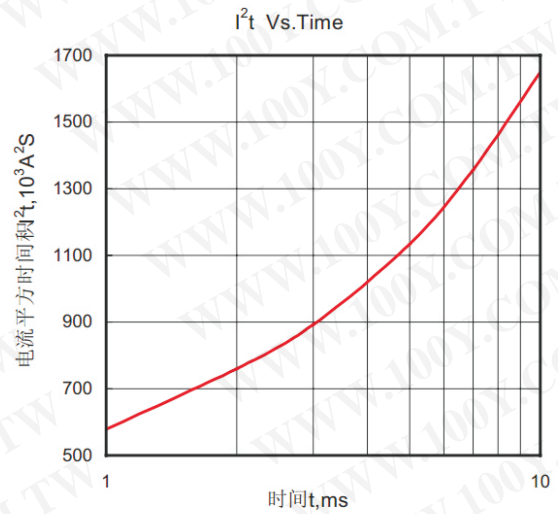
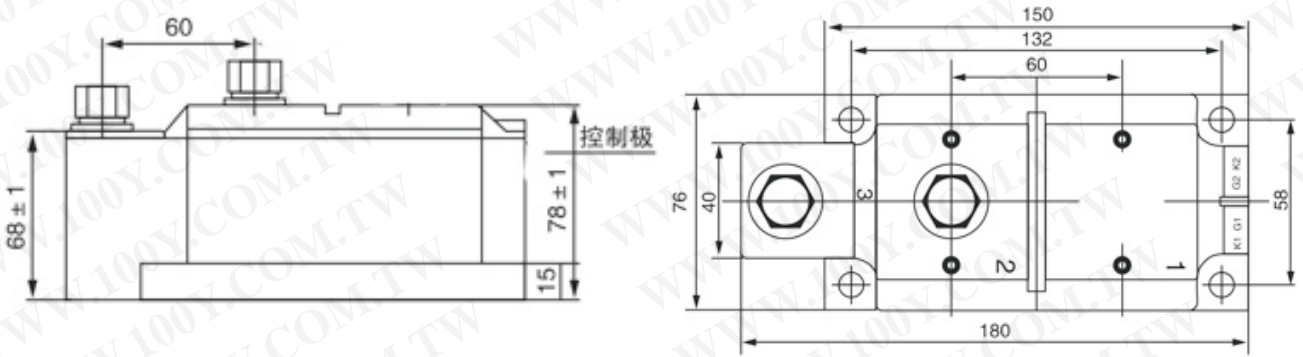


Fig.8 I²t特性曲线

外形尺寸图



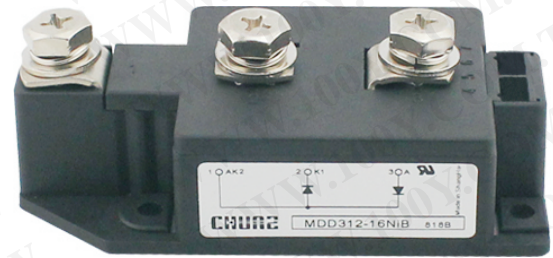
特点

1. 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
2. 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	480A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	10500A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^\circ\text{C}; 180^\circ$ 正弦	$T_j(^\circ\text{C})$			480	A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			520	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM}\&V_{RRM}$ $t_p=10\text{ms}$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM}\&V_{RSM}=V_{DRM}\&V_{RRM}+200\text{V}$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^\circ\text{C}$

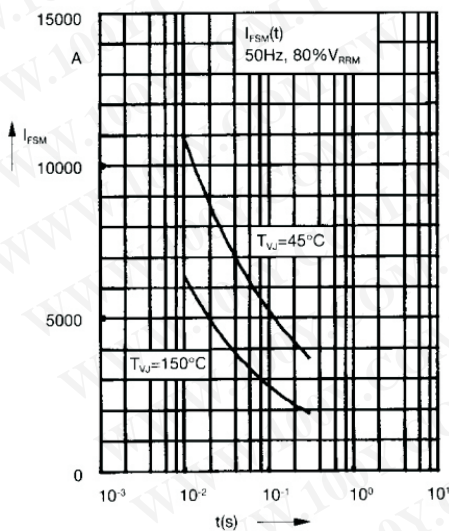


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

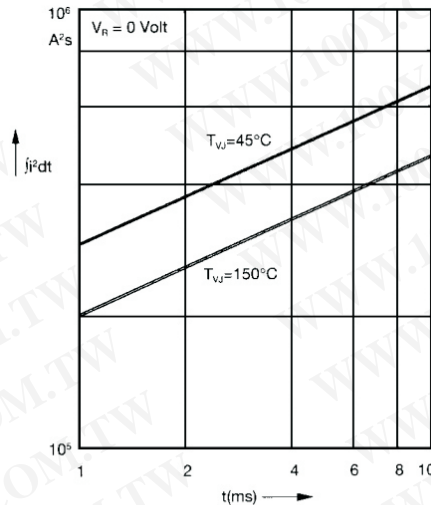


Fig. 2 j^2dt versus time (1-10 ms)

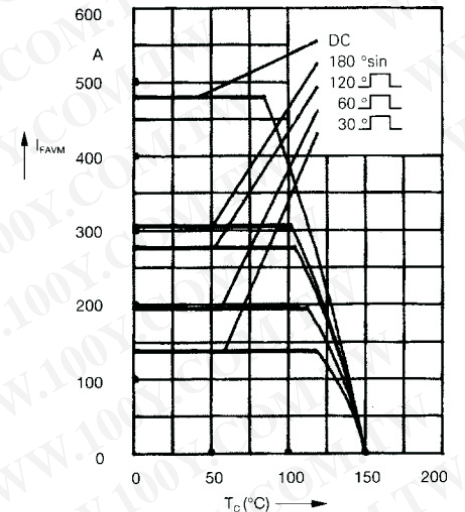


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

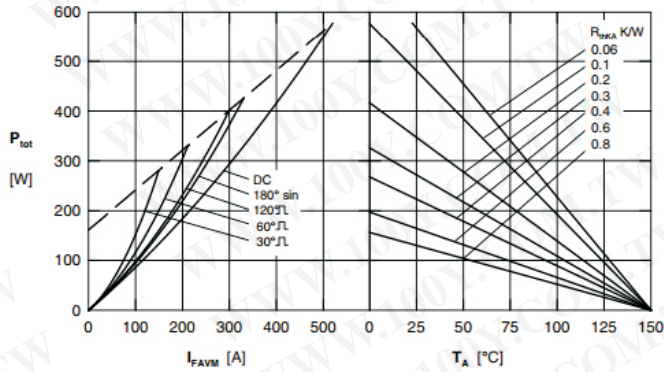


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current & ambient temperature (per diode)

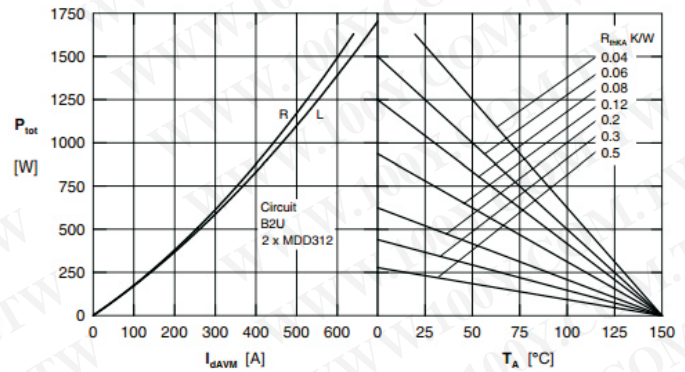
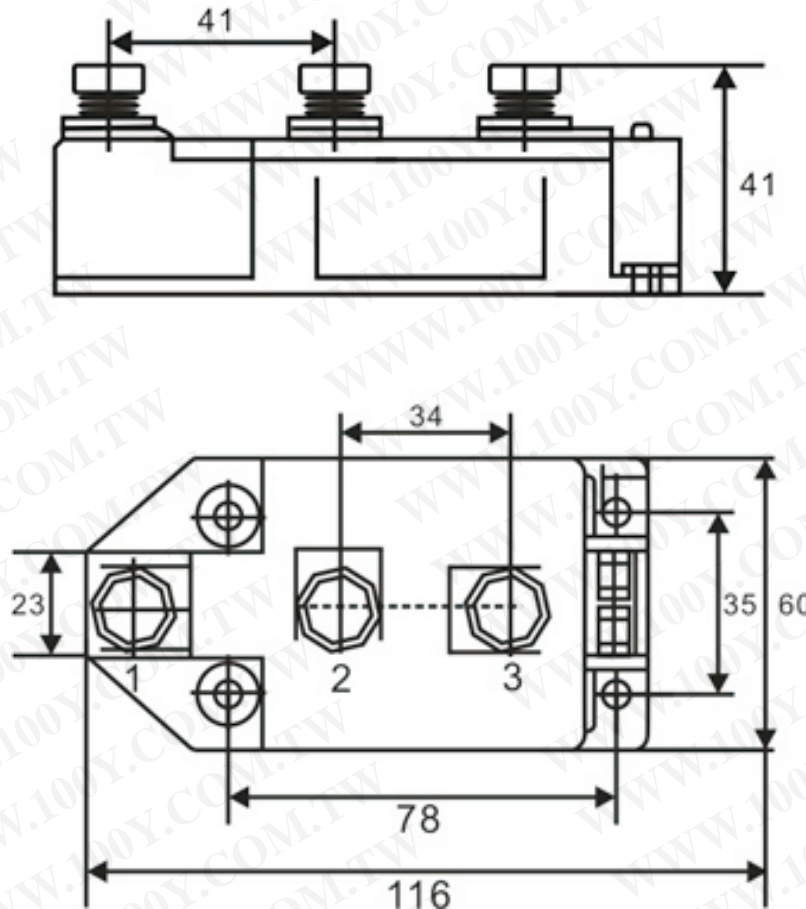


Fig. 6 Single phase rectifier bridge: Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature R = resistive load, L = inductive load



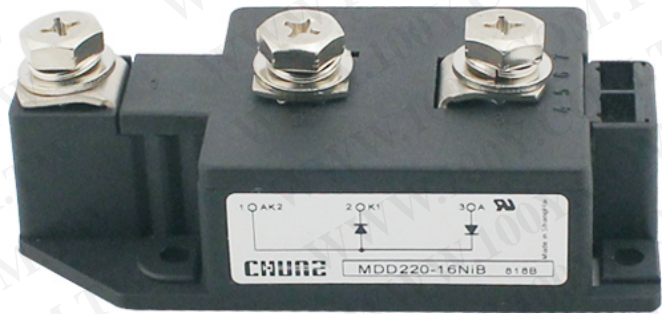
特点

1. 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
2. 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV} 254A
 V_{DRM}/V_{RRM} 1600V
 I_{FSM} 10500A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^{\circ}C; 180^{\circ}$ 正弦	$T_j(^{\circ}C)$			254	A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			350	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$

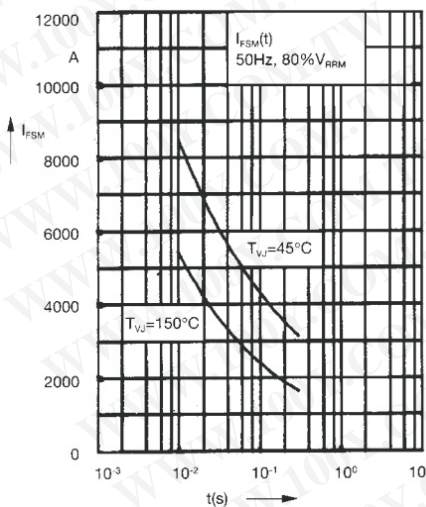


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

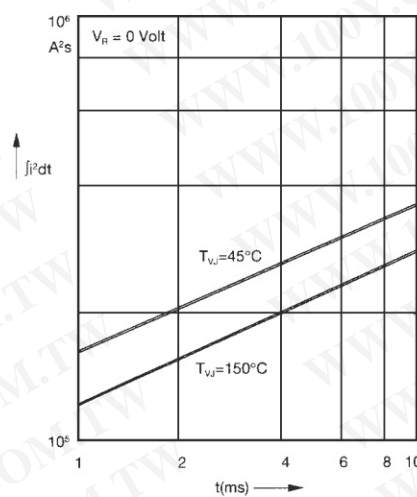


Fig. 2 $\int i^2 dt$ versus time (1-10 ms)

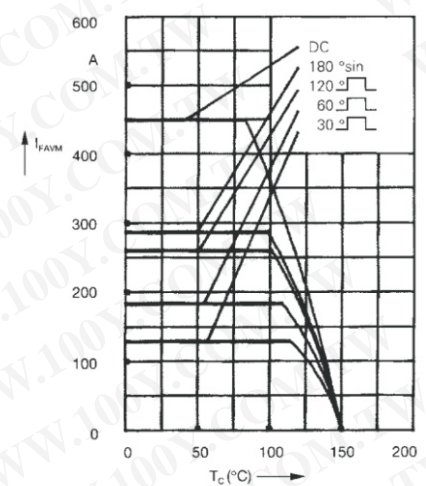


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

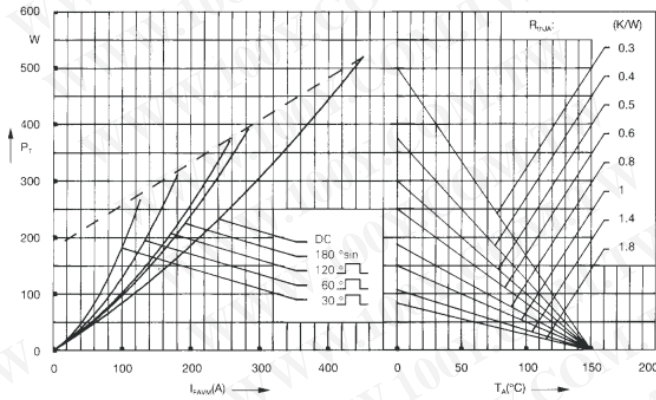


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

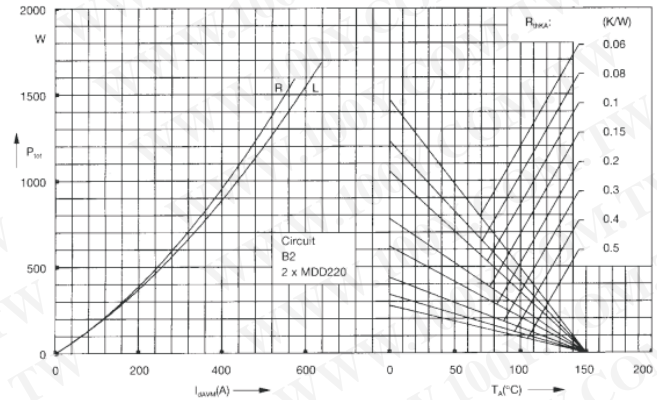
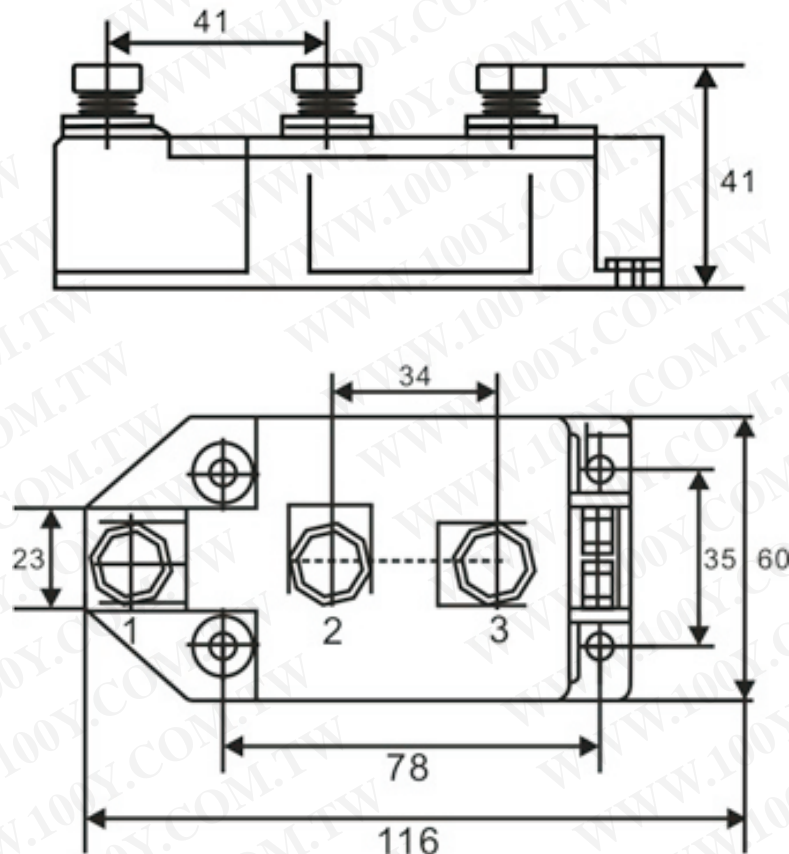


Fig. 4 Single phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature
 R = resistive load
 L = inductive load



特点

1. 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
2. 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	224A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	10500A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^\circ\text{C}; 180^\circ$ 正弦	$T_j(^\circ\text{C})$				A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125				A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM}\&V_{RRM}$ $t_p=10\text{ms}$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM}\&V_{RSM}=V_{DRM}\&V_{RRM}+200\text{V}$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^\circ\text{C}$

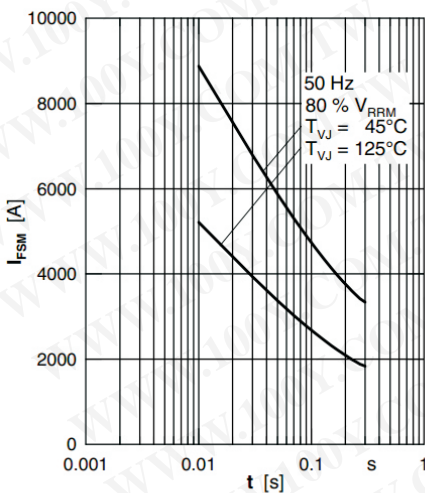


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

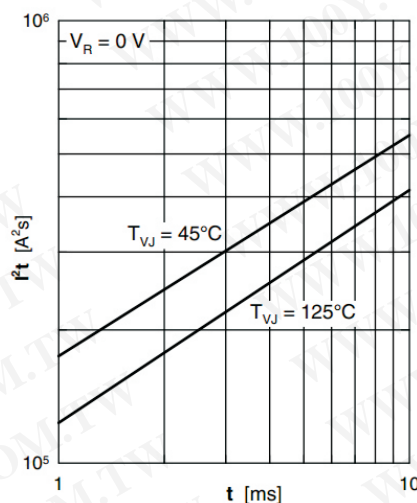


Fig. 2 I^2t versus time (1-10 ms)

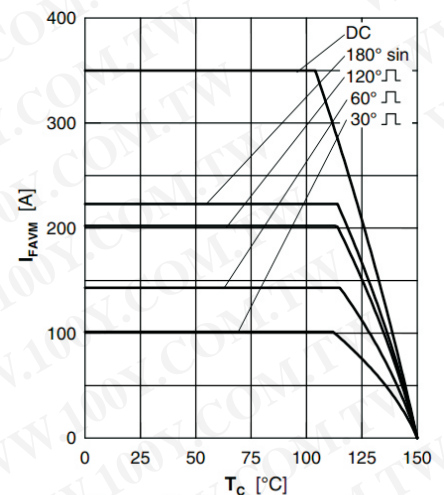


Fig. 3 Maximum forward current at case temperature

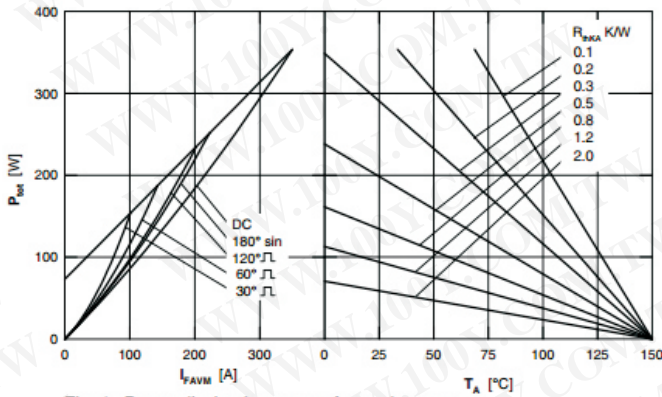


Fig. 4 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

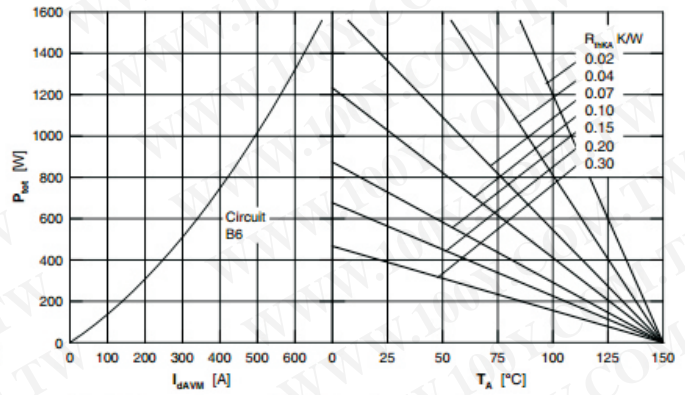
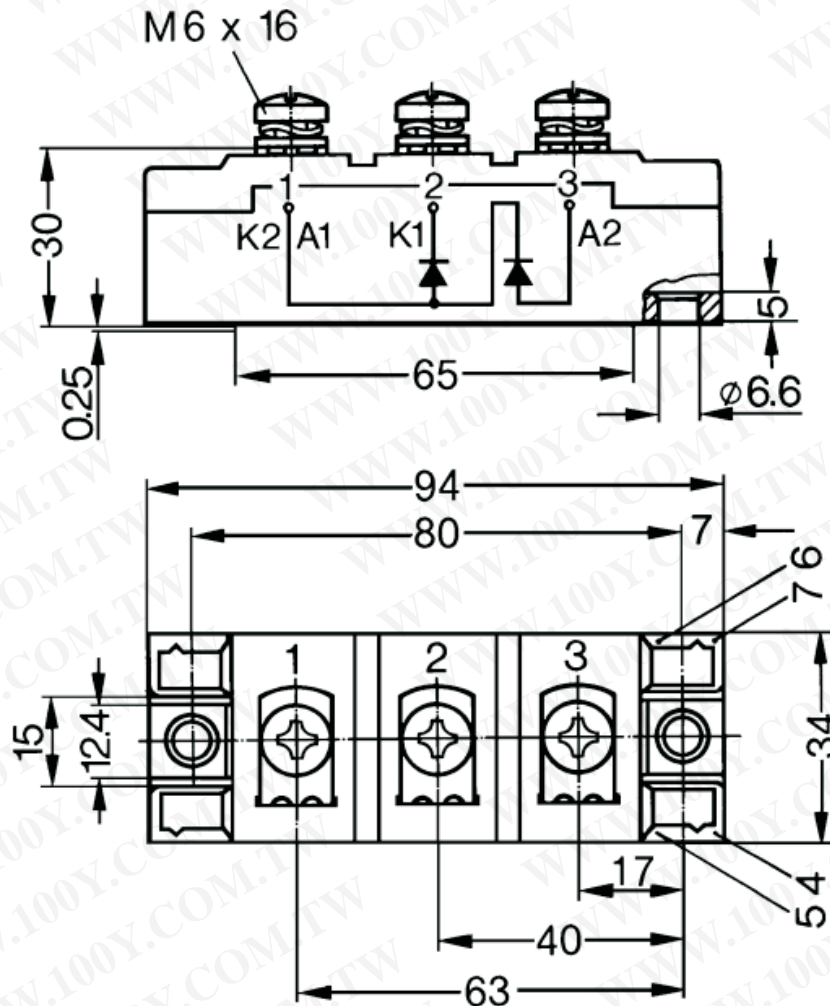


Fig. 6 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAVM}	190A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	6600A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^{\circ}C; 180^{\circ}$ 正弦	$T_j(^{\circ}C)$				A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			190	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$

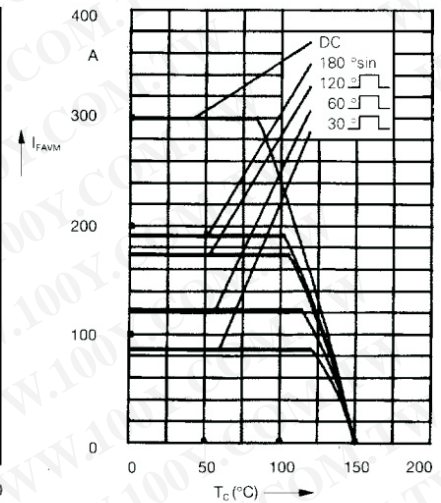
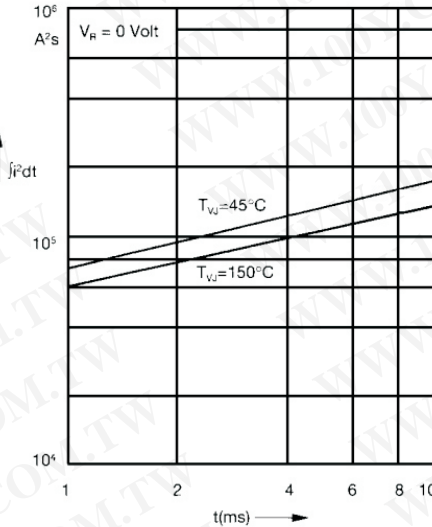
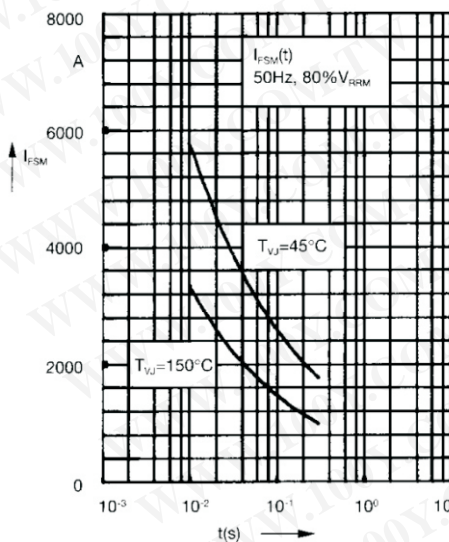


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t : duration

Fig. 2 j^2t versus time (1-10 ms)

Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

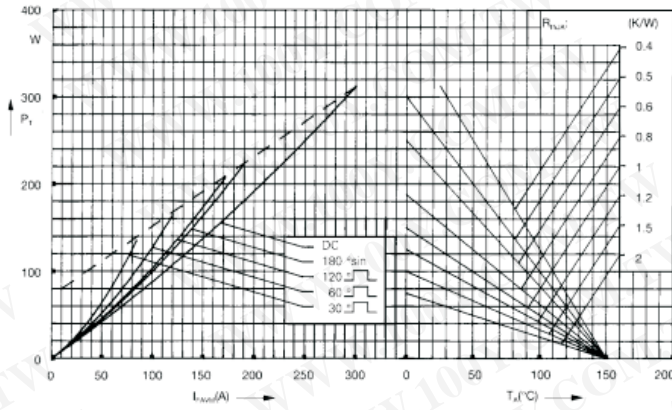


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

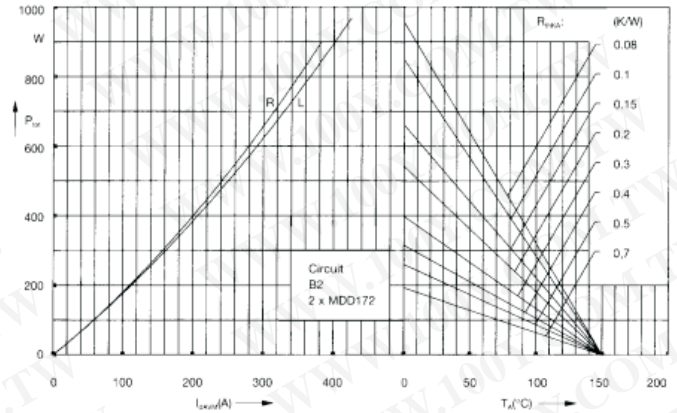
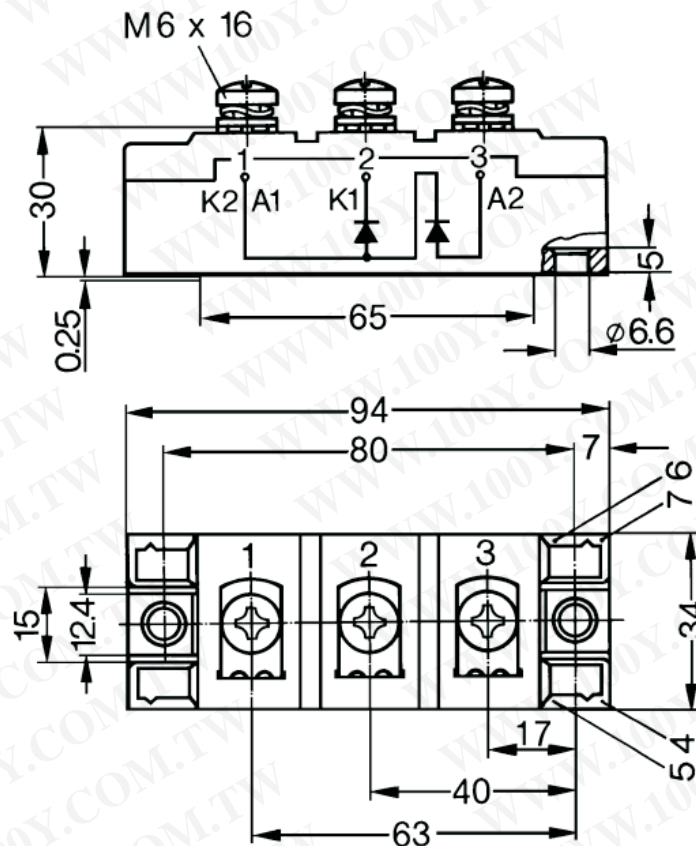


Fig. 4 Single phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature
R = resistive load
L = inductive load



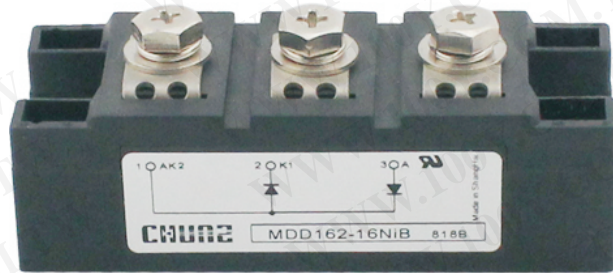
特点

1. 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
2. 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	165A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	4700A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	TC=100°C;180° 正弦	$T_j(°C)$				A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			165	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM}\&V_{RRM}$ tp=10ms	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM}\&V_{RSM}=V_{DRM}\&V_{RRM}+200V$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	°C

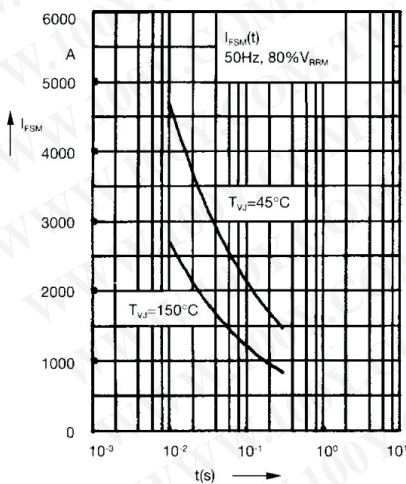


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

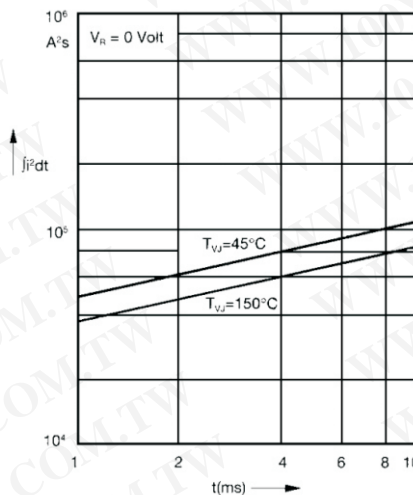


Fig. 2 j^2dt versus time (1-10 ms)

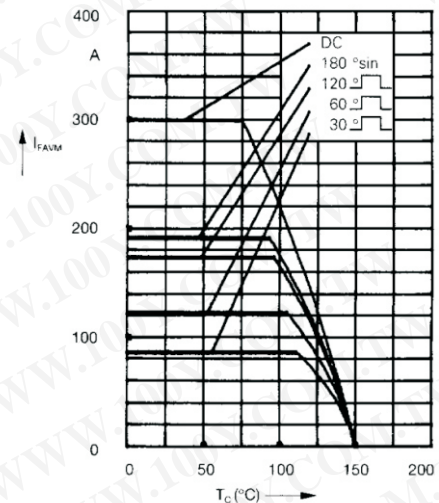


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

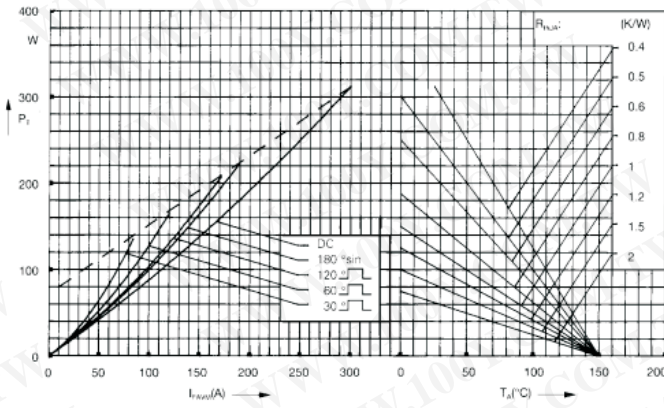


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

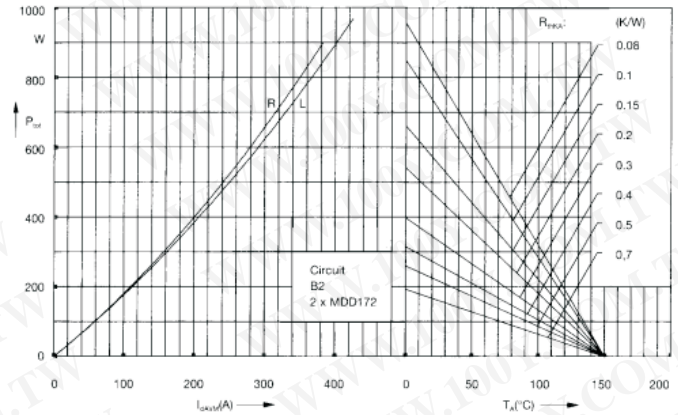
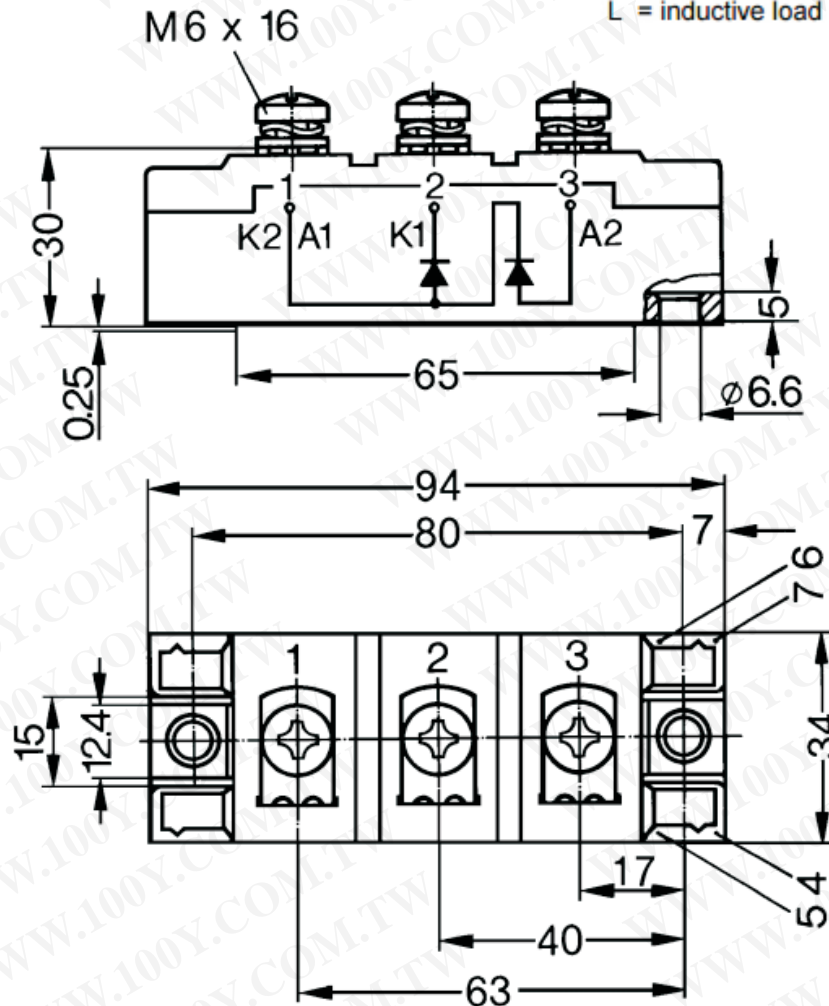


Fig. 4 Single phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature
R = resistive load
L = inductive load



特点

1. 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
2. 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	165A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	4700A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^{\circ}C; 180^{\circ}$ 正弦	125			165	A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			300	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$

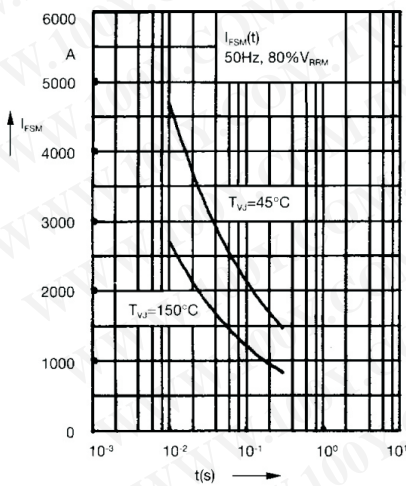


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

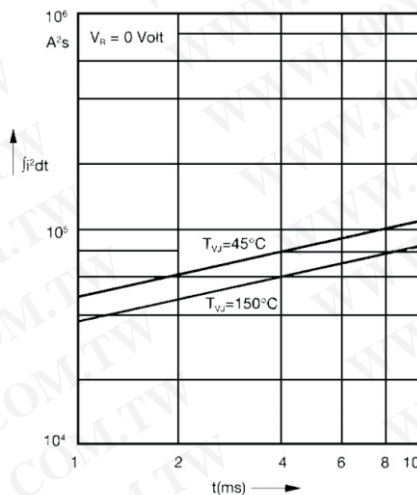


Fig. 2 j^2dt versus time (1-10 ms)

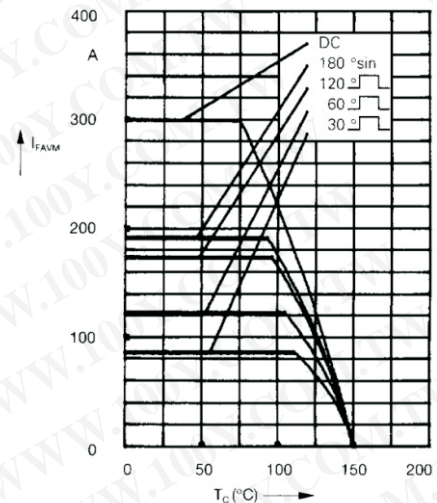


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

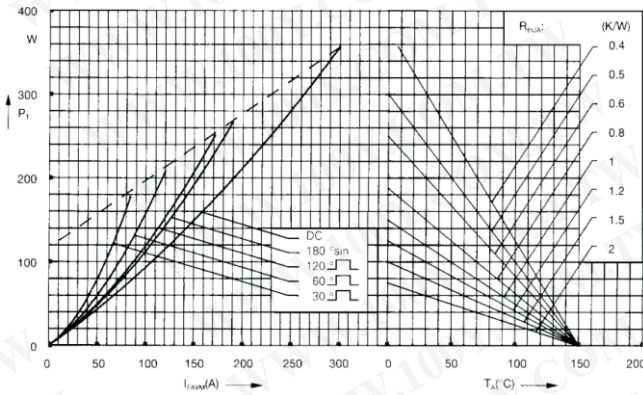


Fig. 5 Three phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct
output current and ambient
temperature

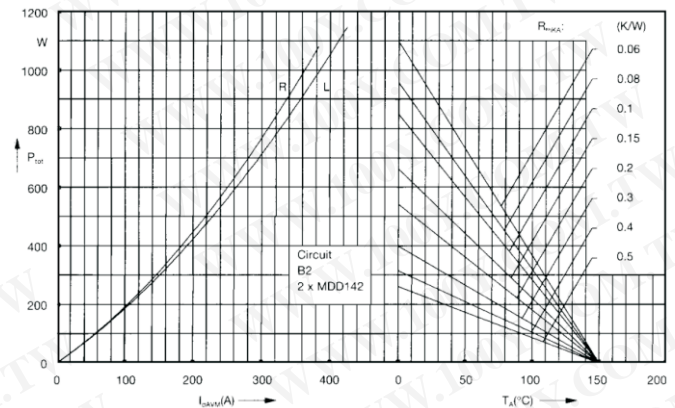
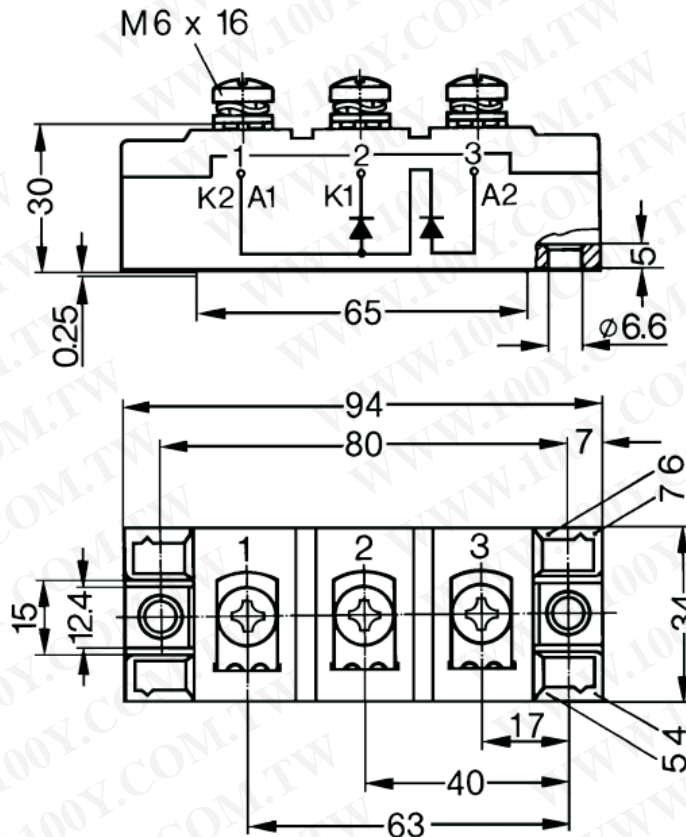


Fig. 4 Single phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct
output current and ambient
temperature
R = resistive load
L = inductive load



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAVM}	109A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	1400A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^{\circ}C; 180^{\circ}$ 正弦	$T_j(^{\circ}C)$			150	A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			109	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$

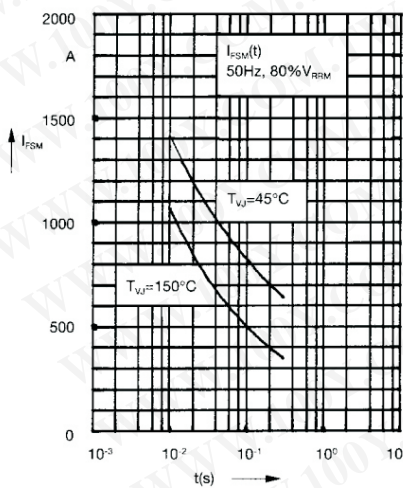


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

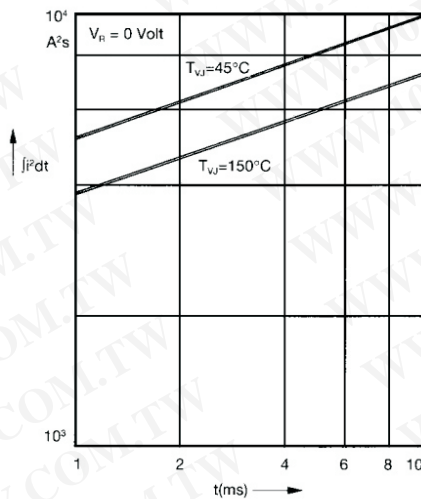


Fig. 2 j^2dt versus time (1-10 ms)

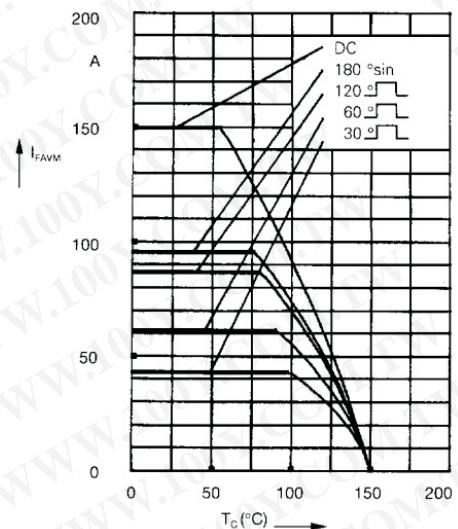


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

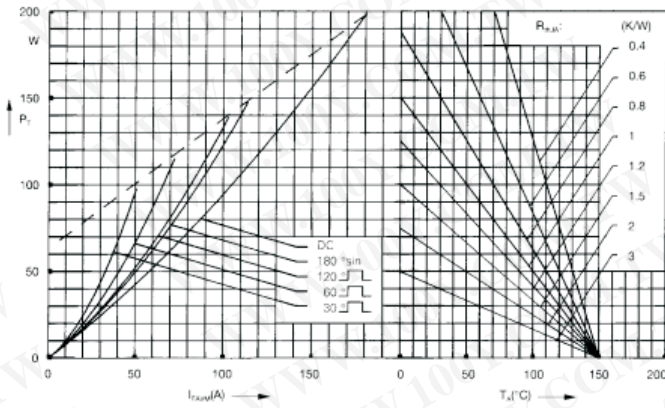


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

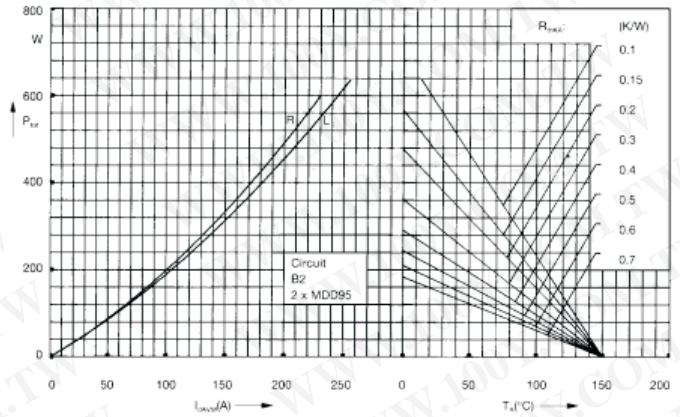
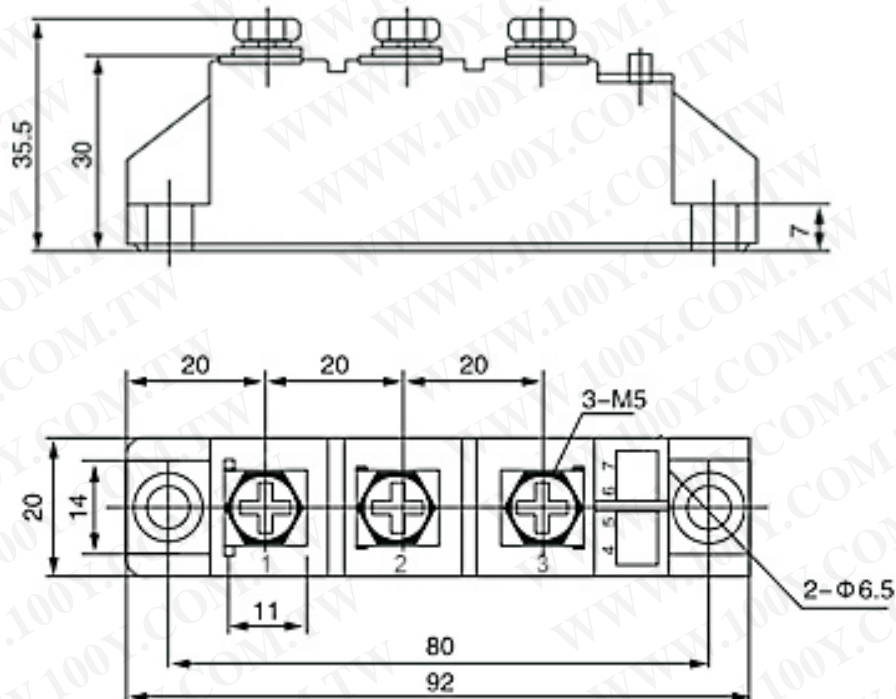


Fig. 4 Single phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature
 R = resistive load
 L = inductive load



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAVM}	87A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	1400A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^{\circ}C; 180^{\circ}$ 正弦	$T_j(^{\circ}C)$			150	A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			87	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$

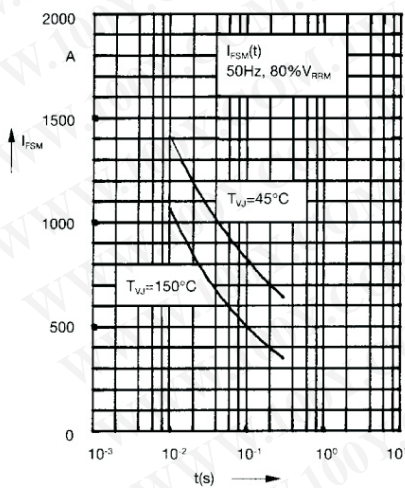


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

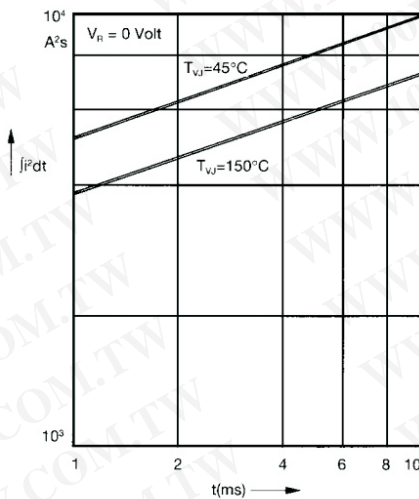


Fig. 2 j^2dt versus time (1-10 ms)

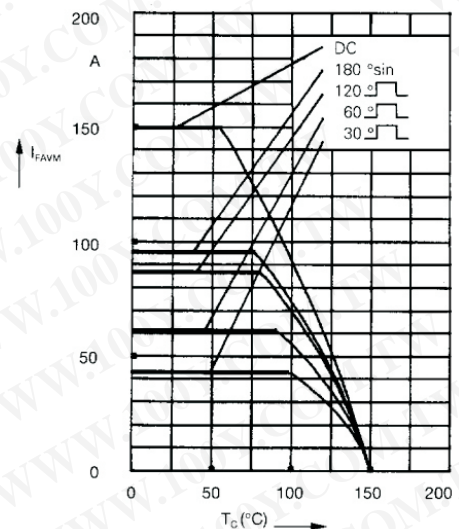


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

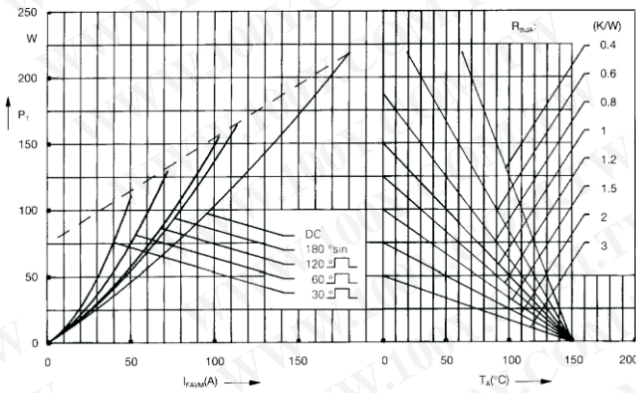


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

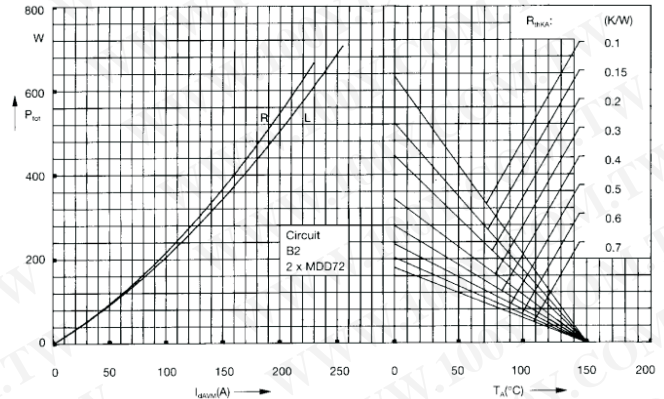
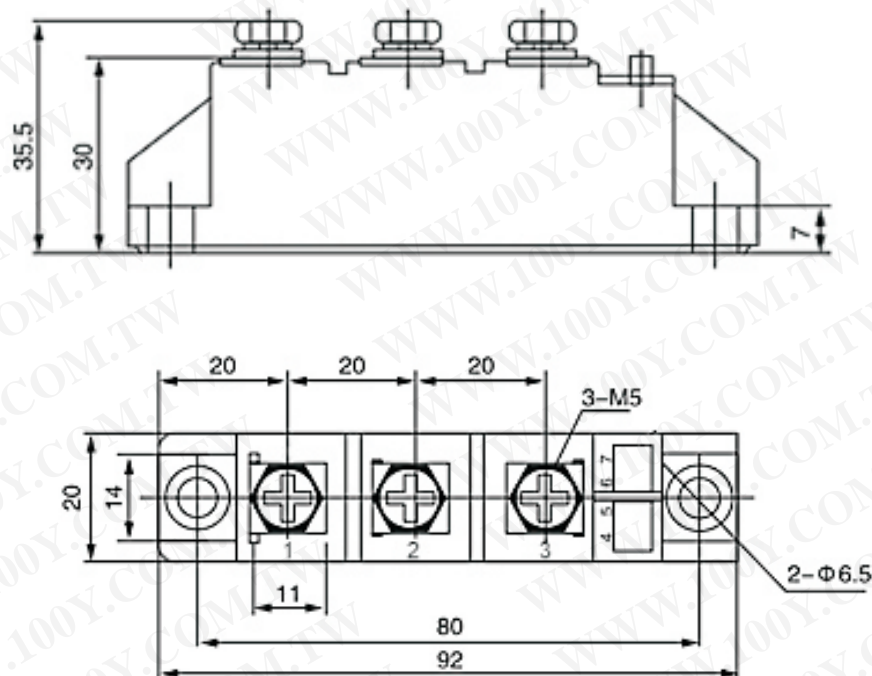


Fig. 4 Single phase rectifier bridge:
Power dissipation versus direct output current and ambient temperature
R = resistive load
L = inductive load



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAVM}	71A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	1400A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^{\circ}\text{C}; 180^{\circ}$ 正弦	$T_j(^{\circ}\text{C})$			150	A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			71	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM}\&V_{RRM}$ $t_p=10\text{ms}$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM}\&V_{RSM}=V_{DRM}\&V_{RRM}+200\text{V}$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}\text{C}$

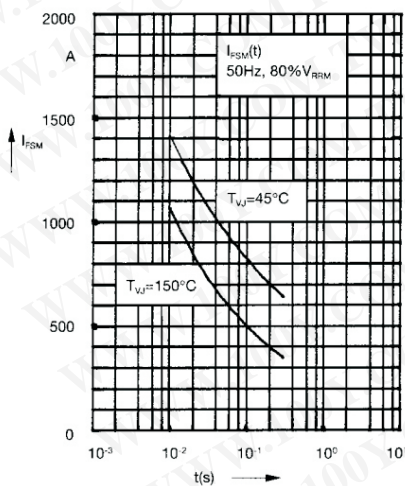


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t : duration

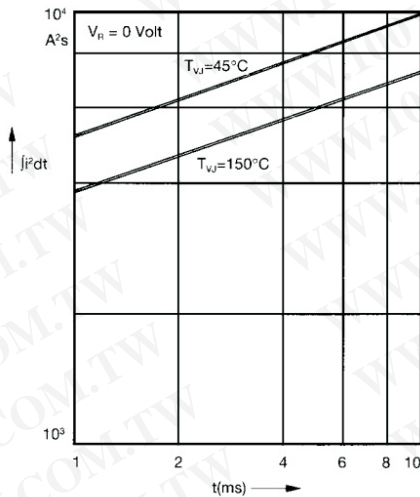


Fig. 2 j^2dt versus time (1-10 ms)

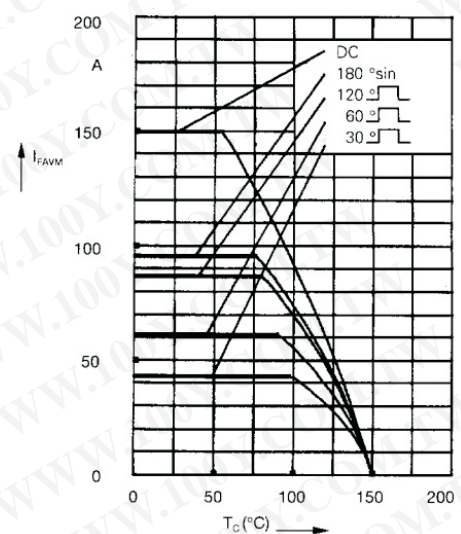


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

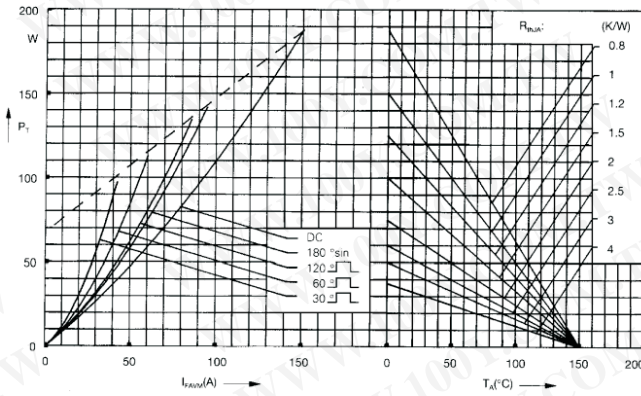


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

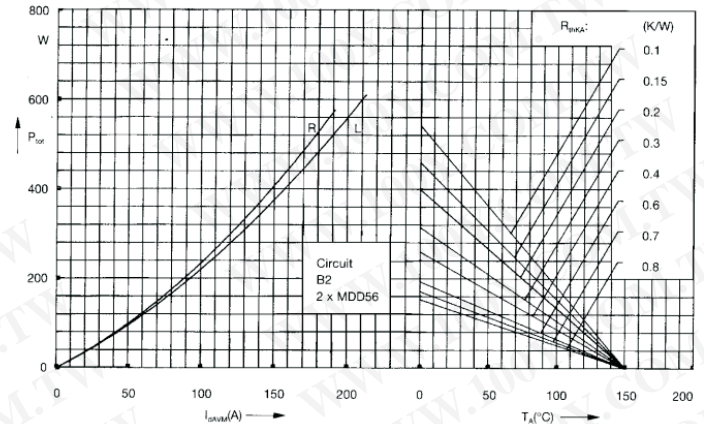
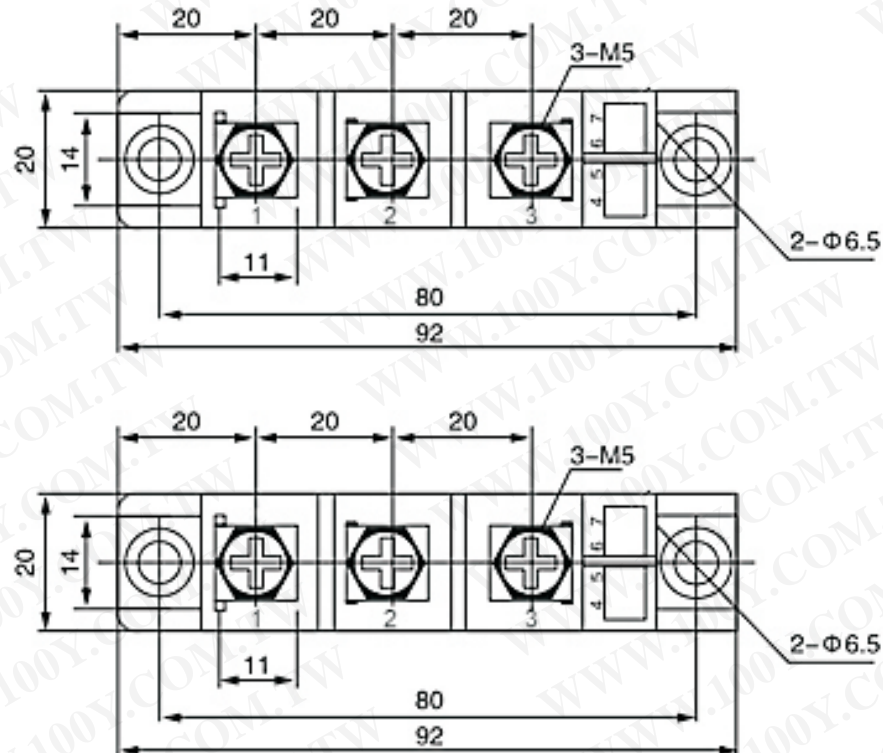


Fig. 4 Single phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature
R = resistive load
L = inductive load



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAVM} 60A
 V_{DRM}/V_{RRM} 1600V
 I_{FSM} 650A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^{\circ}C; 180^{\circ}$ 正弦	125			100	A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			60	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$

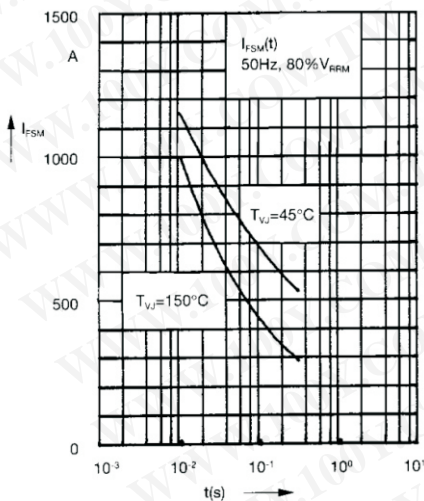


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

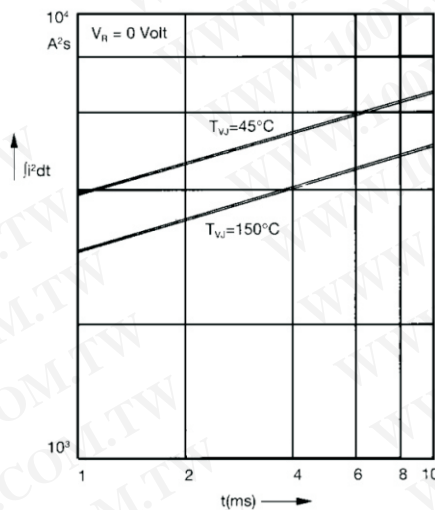


Fig. 2 $\int i^2 dt$ versus time (1-10 ms)

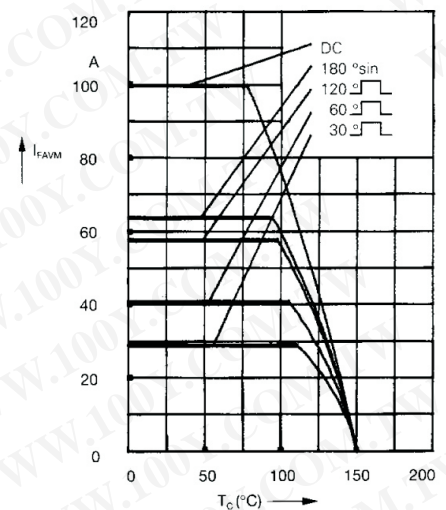


Fig. 2a Maximum forward current at case temperature

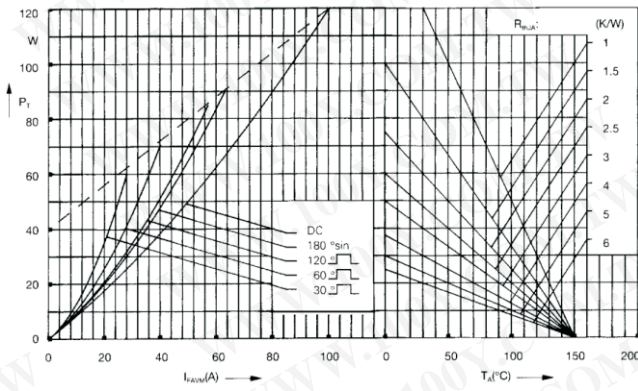


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

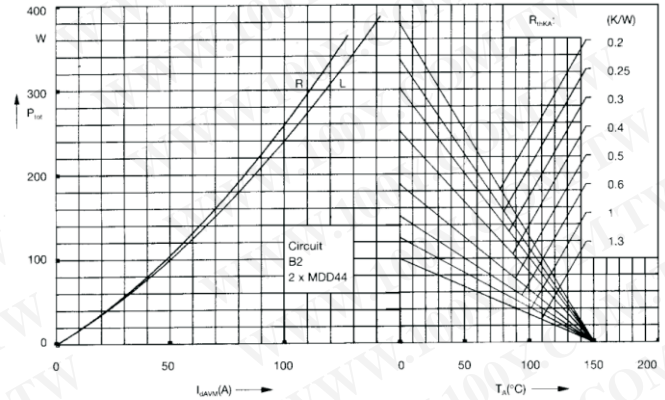
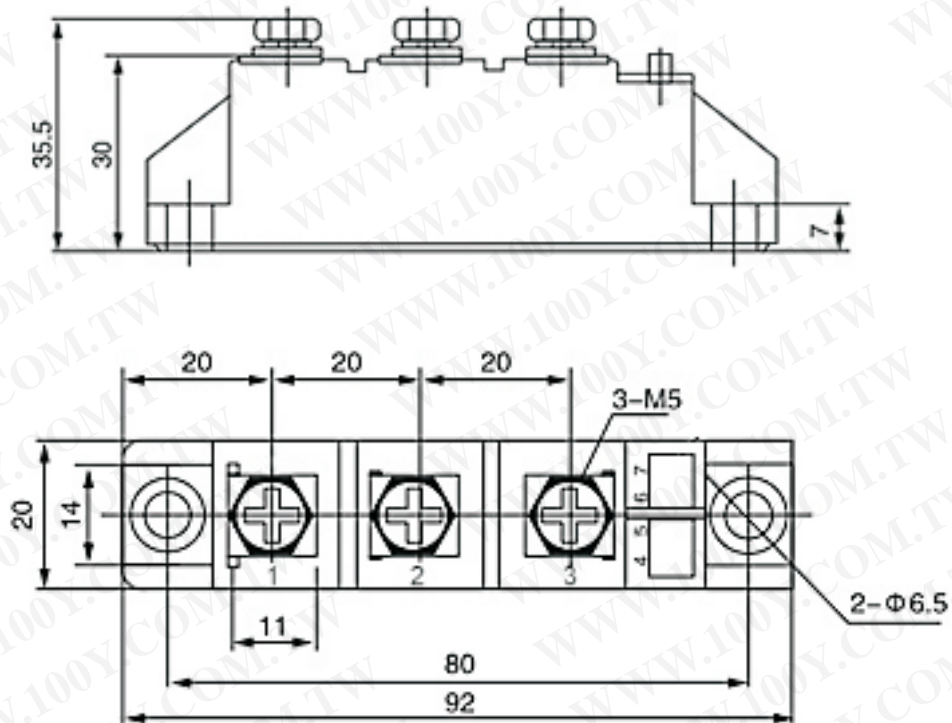


Fig. 4 Single phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature
R = resistive load
L = inductive load



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAVM} 36A
 V_{DRM}/V_{RRM} 1600V
 I_{FSM} 650A



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAVM}	通态平均电流	$T_C=100^{\circ}C; 180^{\circ}$ 正弦	$T_j(^{\circ}C)$			36	A
I_{FRMS}	方均根电流	$T_{VJ}=T_{VJM}$	125			60	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125		1600		V
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$

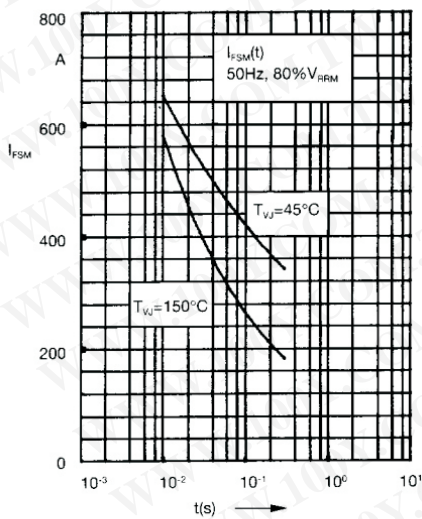


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t: duration

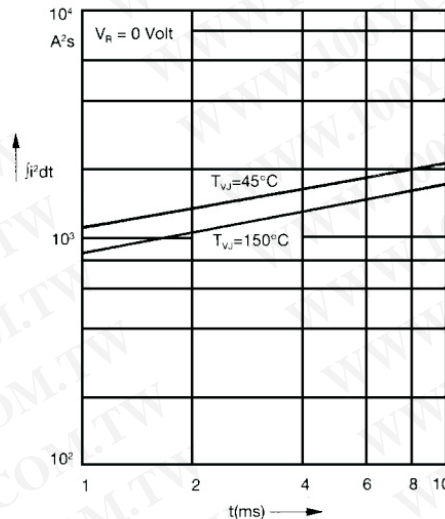
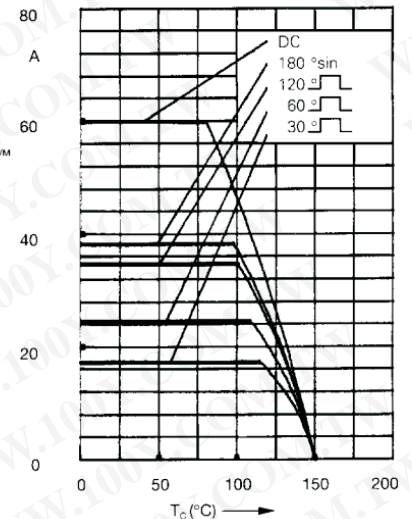


Fig. 2 j^2dt versus time (1-10 ms)



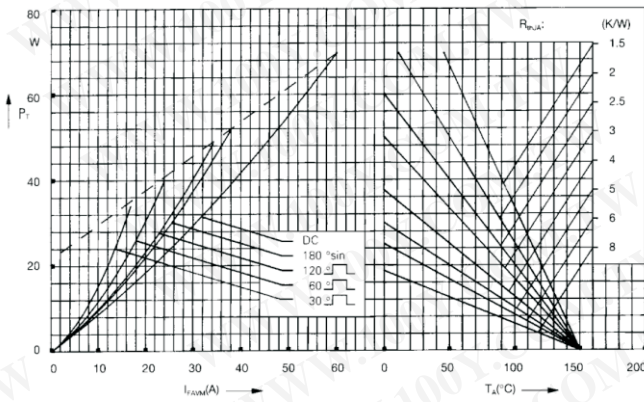


Fig. 3 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)

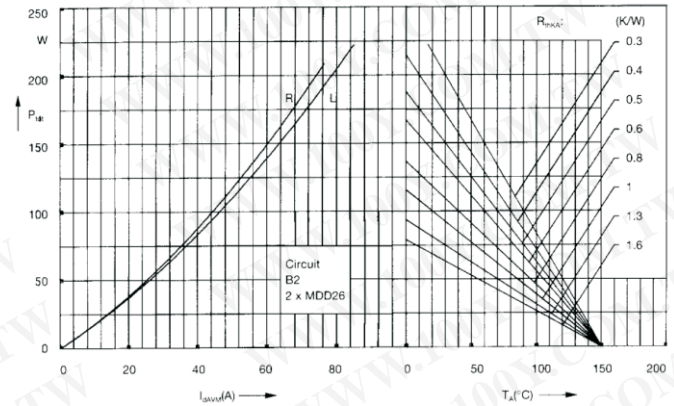
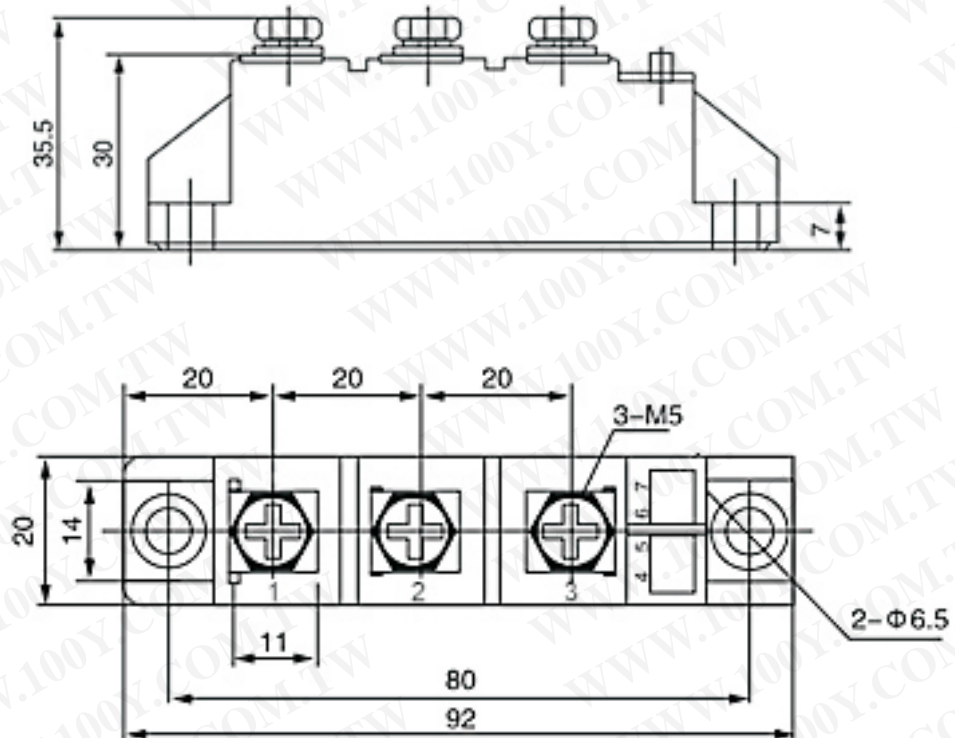


Fig. 4 Single phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature
R = resistive load
L = inductive load



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	1000A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$20A \times 10^3$
I_{Tj}	$2040A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			1000	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			1570	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM} = V_{RRM} + 200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM} = V_{RRM}$	150			50	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	150			20	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	150			2040	$A^2s \times 10^3$
I_{Tj}	门槛电压		150			0.75	V
rF	斜率电阻		150			0.31	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM} = 3000A$	25			1.82	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.080	$^{\circ}C / W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)						$^{\circ}C / W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, liso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M12)					14	N·m
F_m	安装扭矩(M8)					12	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

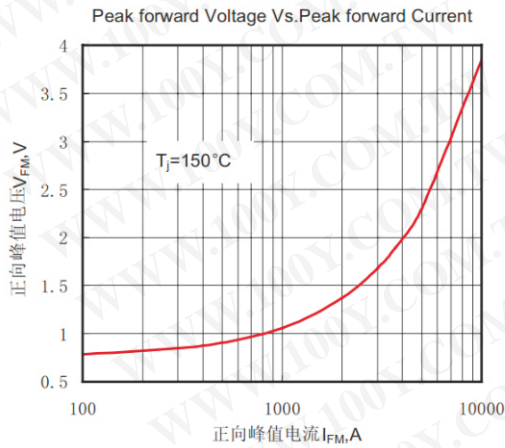


Fig.1 正向伏安特性曲线

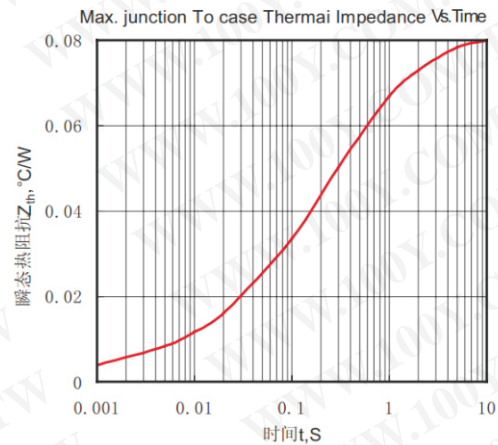


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

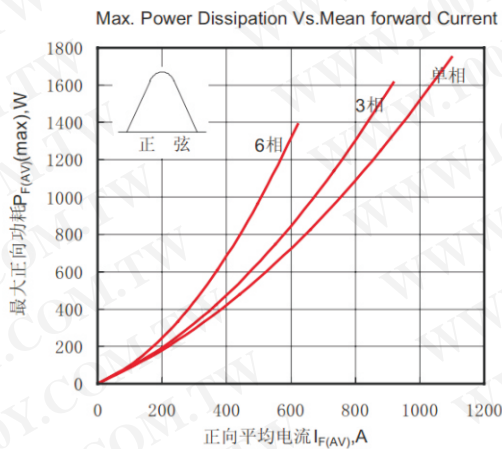


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

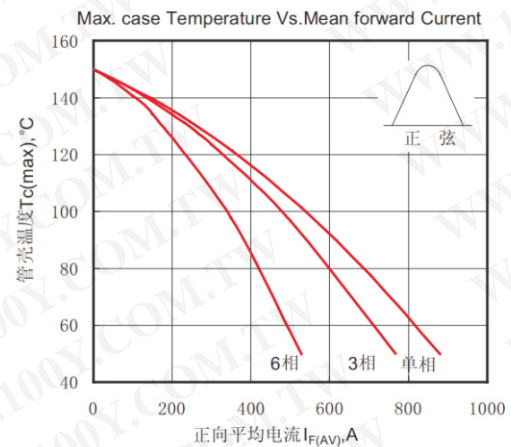


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

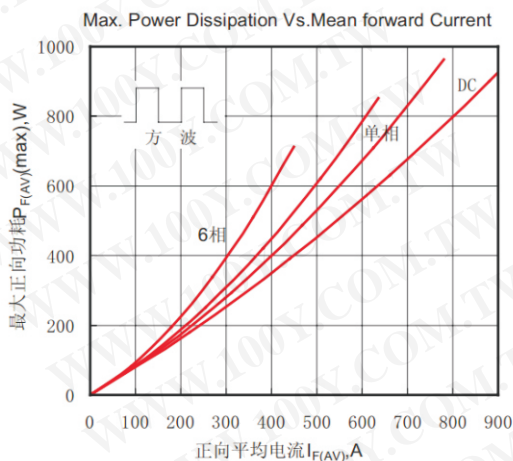


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

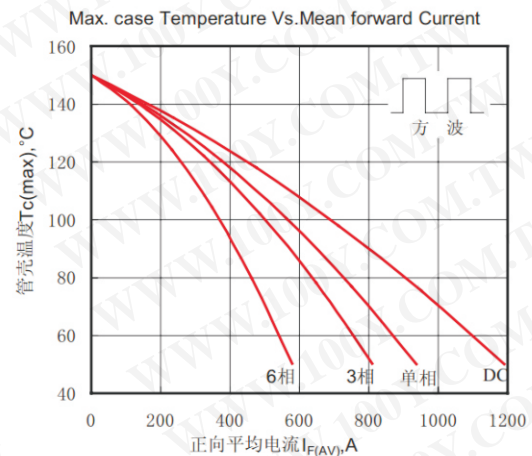


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

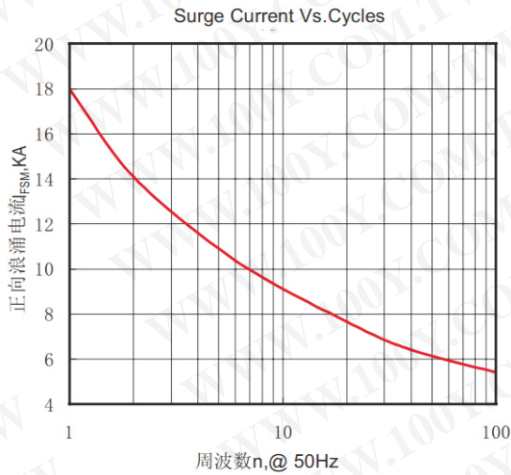


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

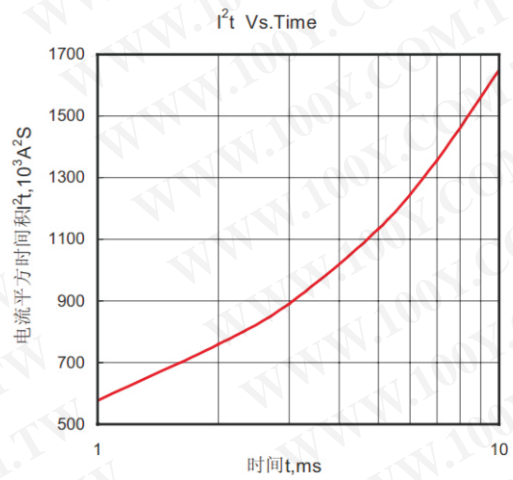
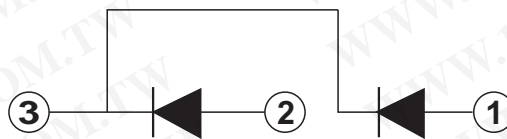
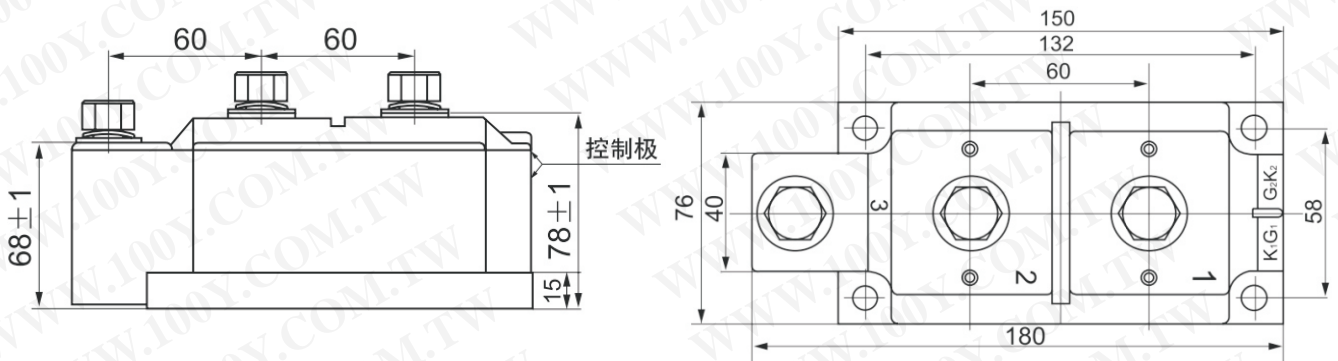


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	800A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$15A \times 10^3$
I_{T1}	$1150A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150		800	A	
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150		1256	A	
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	1600		V	
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150		45	mA	
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150		18.0	KA	
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150		1650	$A^2s \times 10^3$	
I_{T1}	门槛电压		150		0.75	V	
r_F	斜率电阻		150		0.33	m Ω	
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=2400A$	25		1.80	V	
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热			0.080	$^{\circ}C/W$	
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					$^{\circ}C/W$	
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, liso: 1mA(max)		2500		V	
F_m	安装扭矩(M12)				14	N·m	
F_m	安装扭矩(M8)				12	N·m	
T_{stg}	贮存温度			-40	125	$^{\circ}C$	
W_t	质量					g	
Size	包装盒尺寸					mm	

性能曲线图

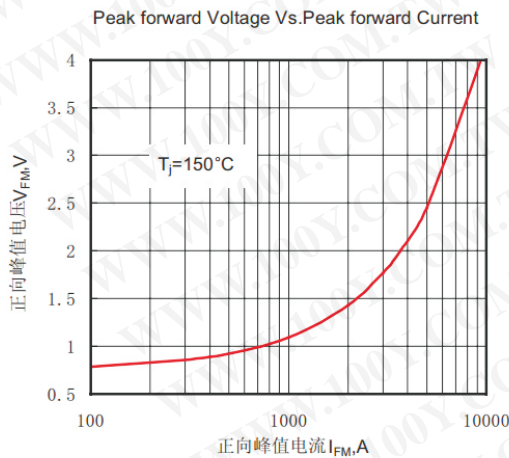


Fig.1 正向伏安特性曲线

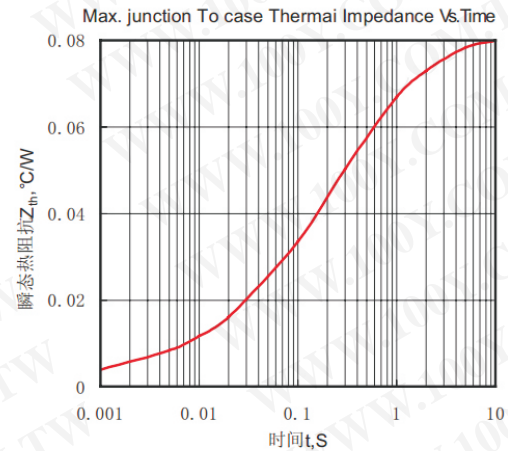


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

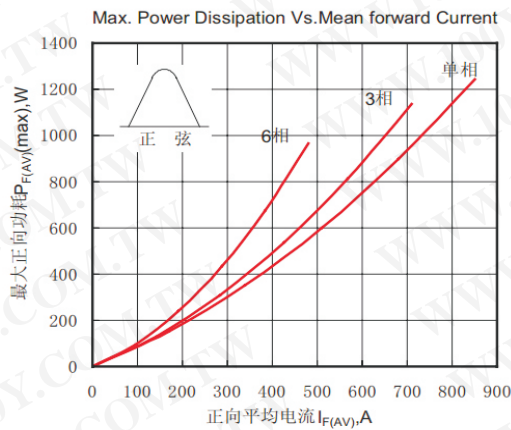


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

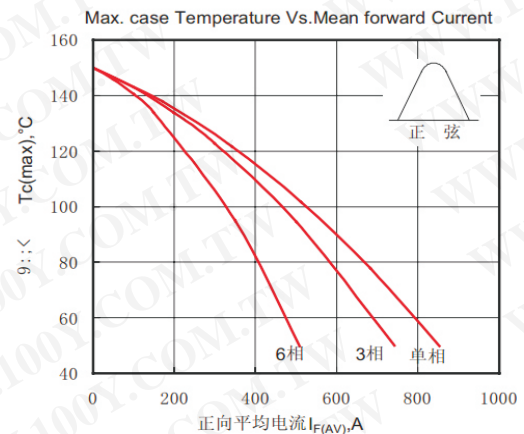


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

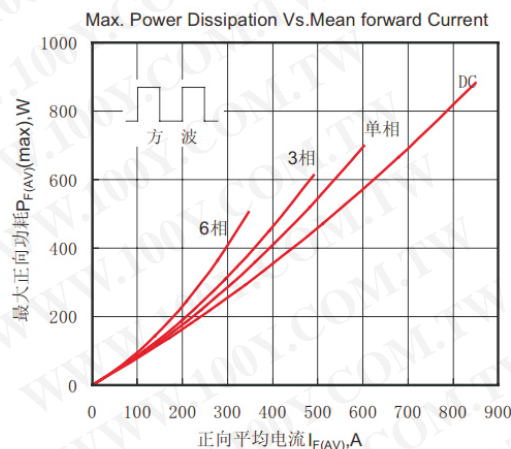


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

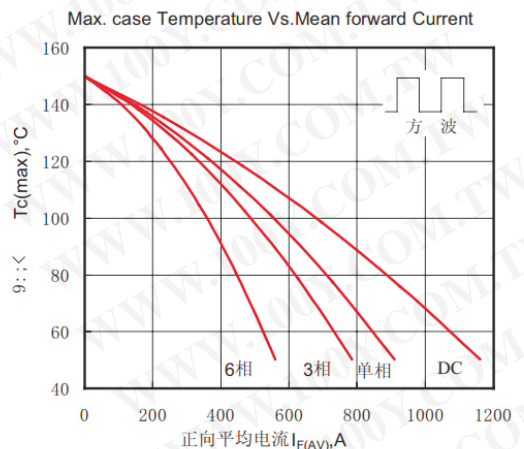


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

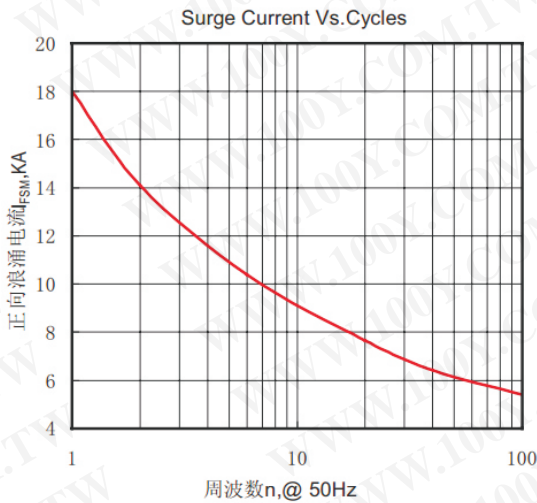


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

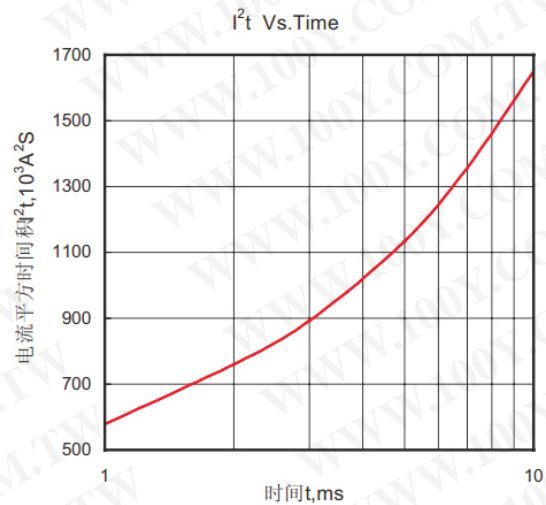
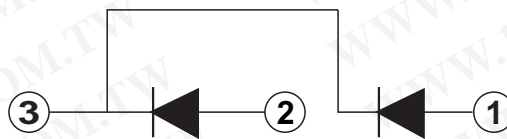
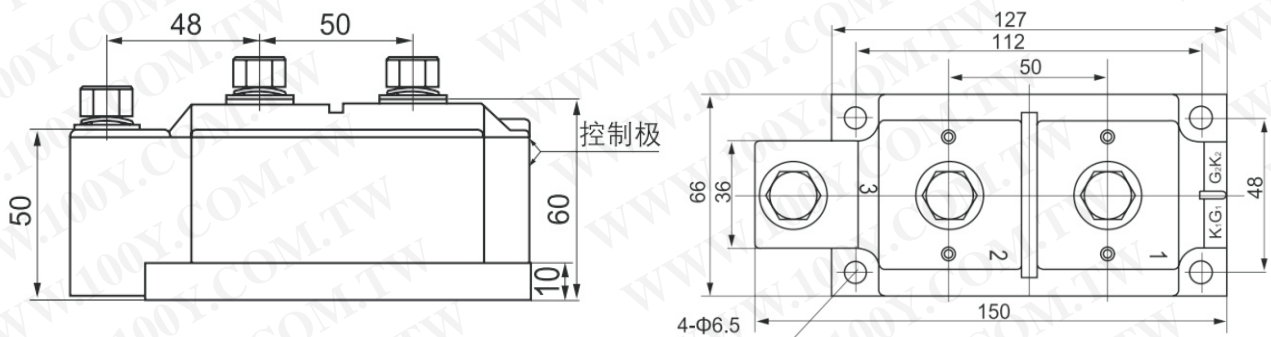


Fig.8 I²t特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

- | | | |
|------------|-------------|------------------------|
| 1. 交直流电机控制 | $I_{F(AV)}$ | 600A |
| 2. 各种整流电源 | V_{RRM} | 1600V |
| 3. 变频器 | I_{FSM} | $15A \times 10^3$ |
| | I_{T1} | $1150A^2S \times 10^3$ |



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			600	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			1256	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			45	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			18.0	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			1650	$A^2s \times 10^3$
I_{T1}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.33	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=2400A$	25			1.80	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.080	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)						$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, Iiso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M12)					14	N·m
F_m	安装扭矩(M8)					12	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

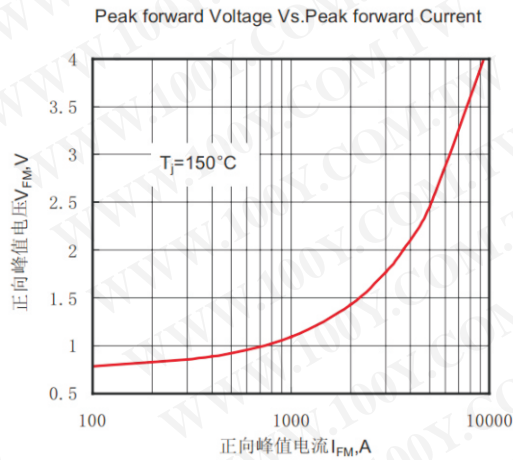


Fig.1 正向伏安特性曲线

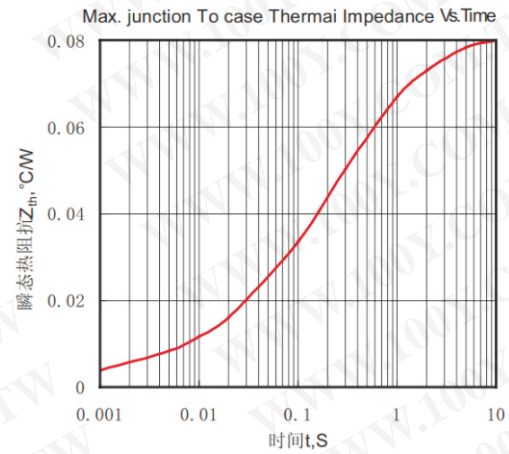


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

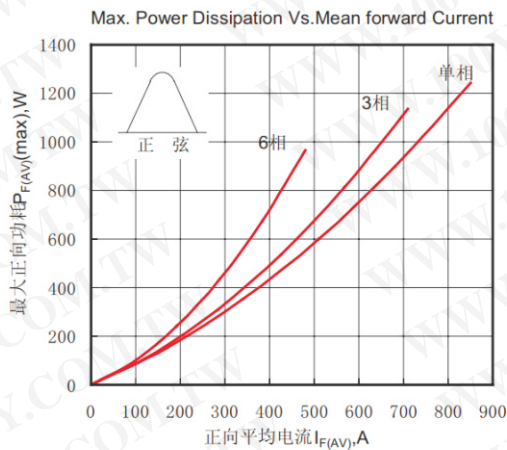


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

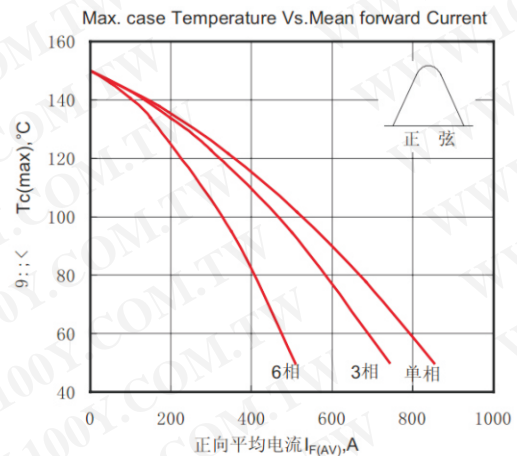


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

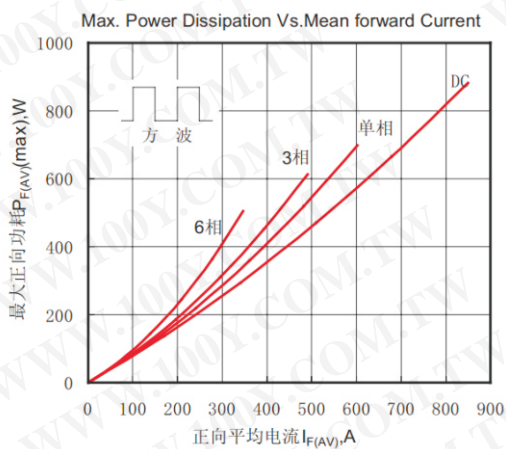


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

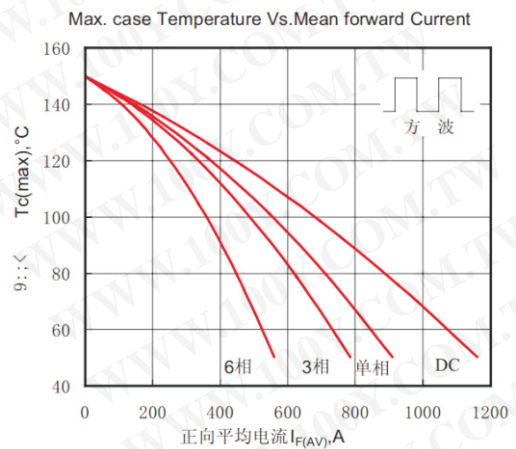


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

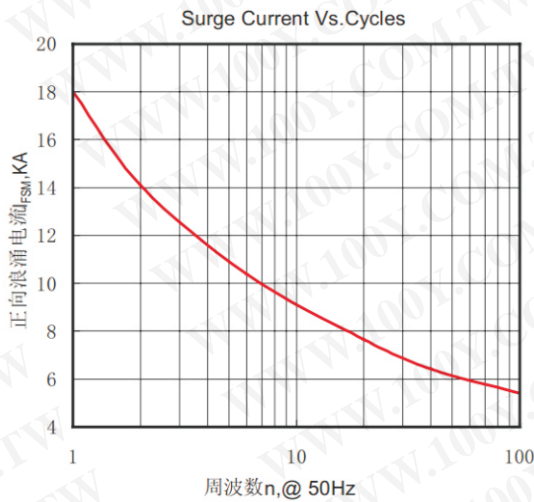


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

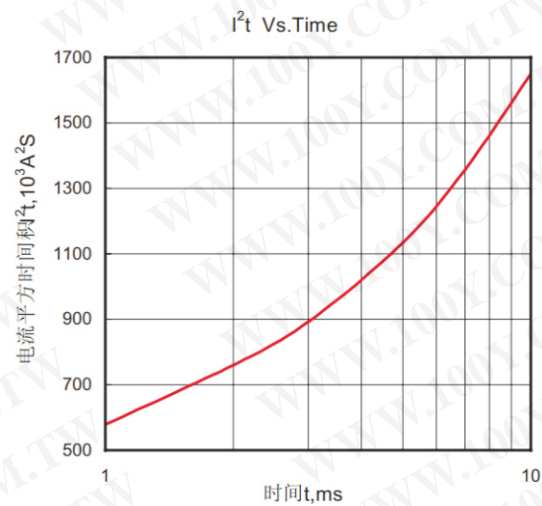
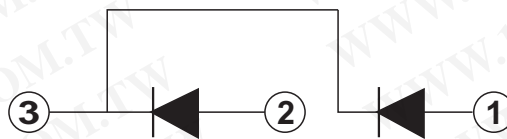
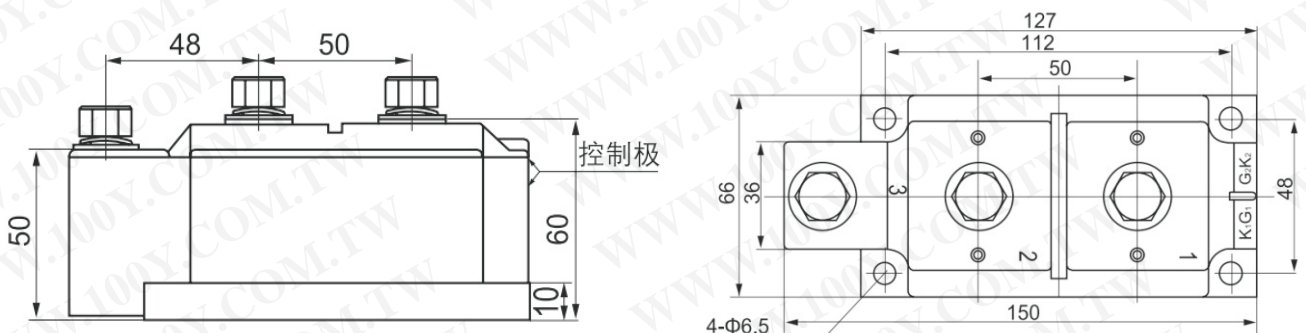


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



性能曲线图

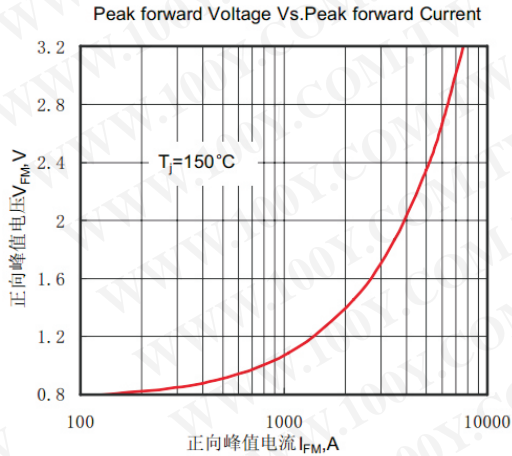


Fig.1 正向伏安特性曲线

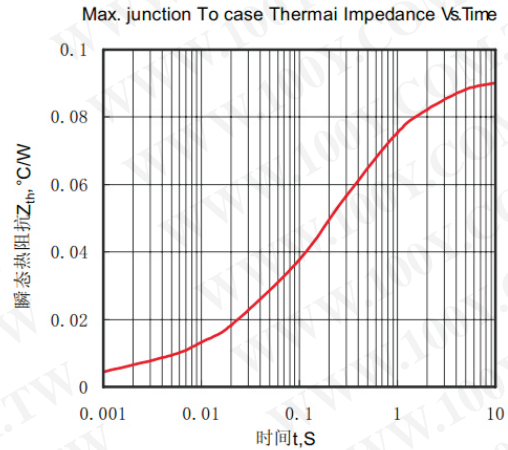


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

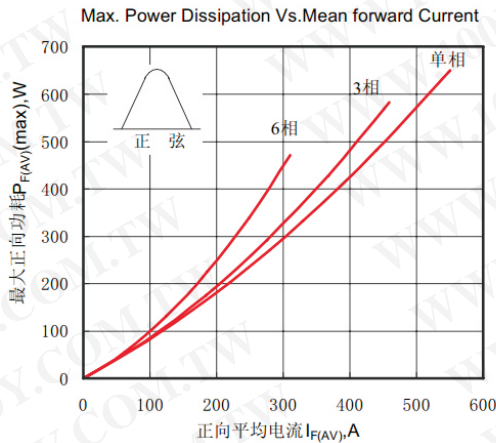


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

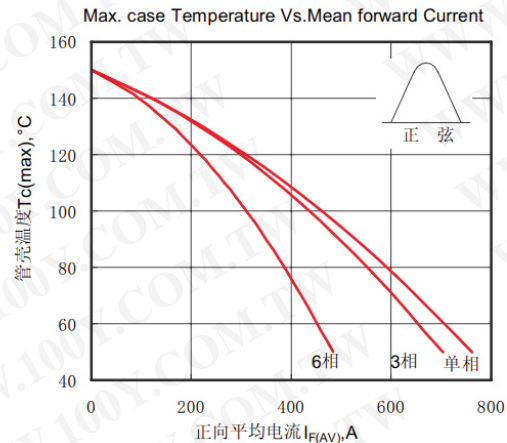


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

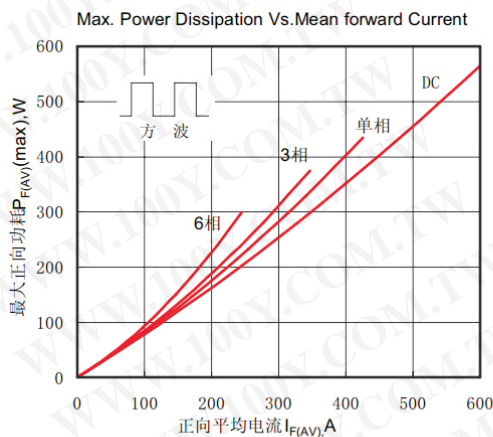


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

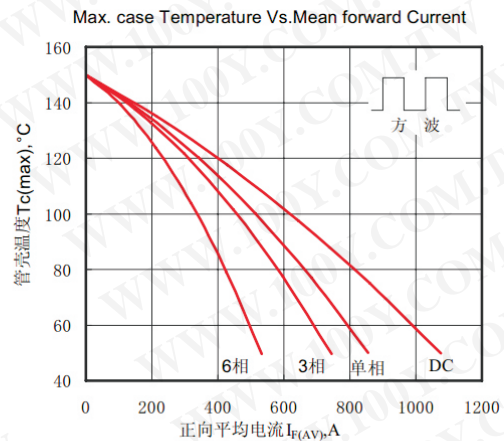


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	500A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$21A \times 10^3$
I^2t	$2250A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			500	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			785	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			40	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			21.0	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			2250	$A^2s \times 10^3$
I^2t	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.32	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=1500A$	25			1.35	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.090	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.024	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, Iiso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M10)					12	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

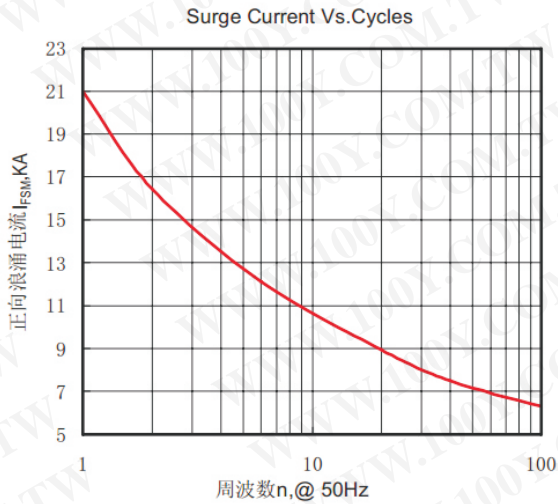


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

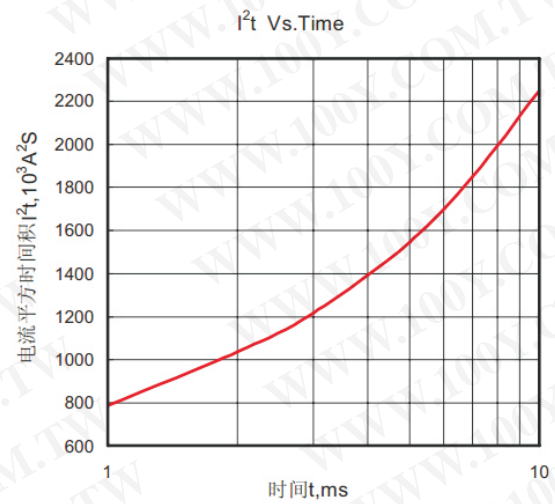
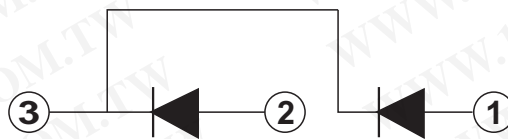
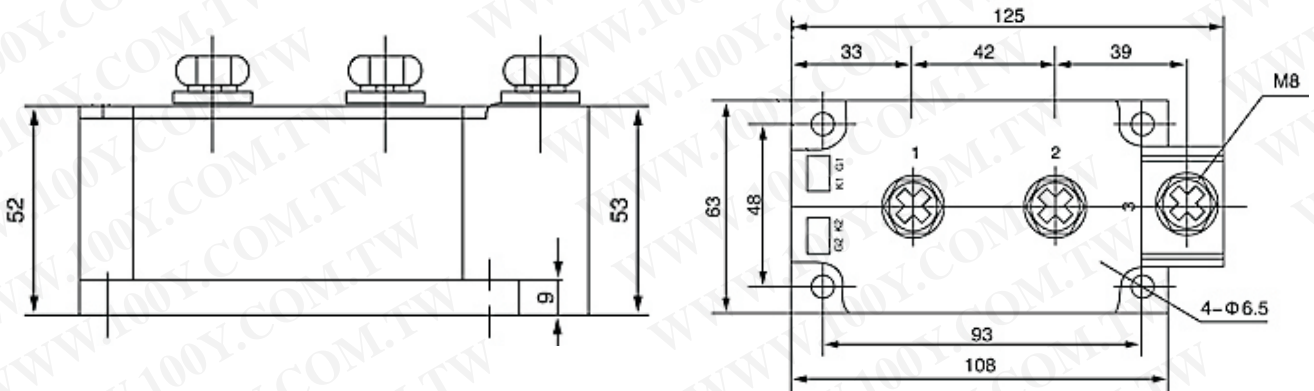


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	400A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$15A \times 10^3$
I_{T1}	$1150A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150		400	A	
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150		628	A	
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150	1600		V	
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150		30	mA	
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150		17.0	KA	
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150		1470	$A^2s \times 10^3$	
I_{T1}	门槛电压		150		0.75	V	
r_F	斜率电阻		150		0.50	m Ω	
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=1200A$	25		1.48	V	
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热			0.100	$^{\circ}C/W$	
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)				0.04	$^{\circ}C/W$	
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, Iiso: 1mA(max)		2500		V	
F_m	安装扭矩(M10)				12	N·m	
F_m	安装扭矩(M6)				6	N·m	
T_{stg}	贮存温度			-40	125	$^{\circ}C$	
W_t	质量					g	
Size	包装盒尺寸					mm	

性能曲线图

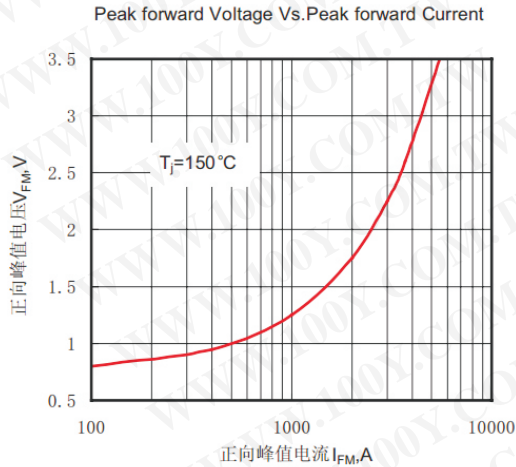


Fig.1 正向伏安特性曲线

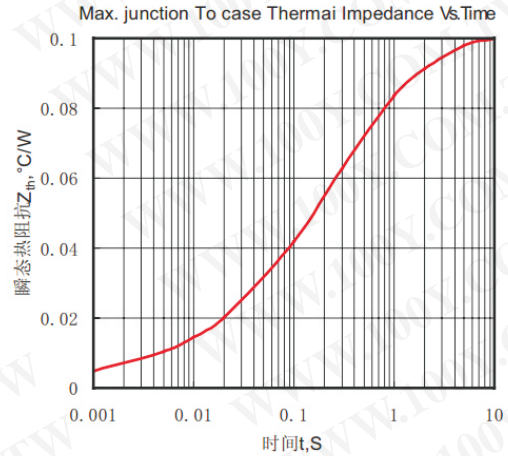


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

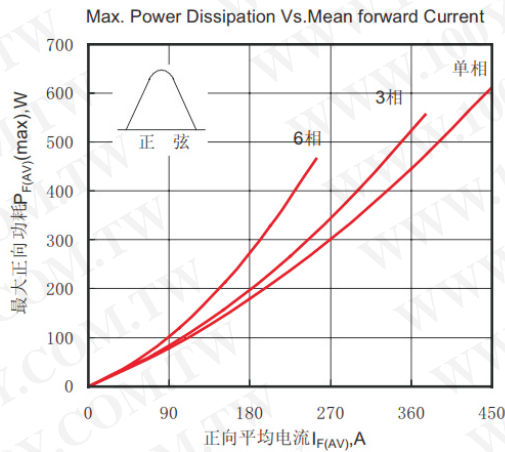


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线-

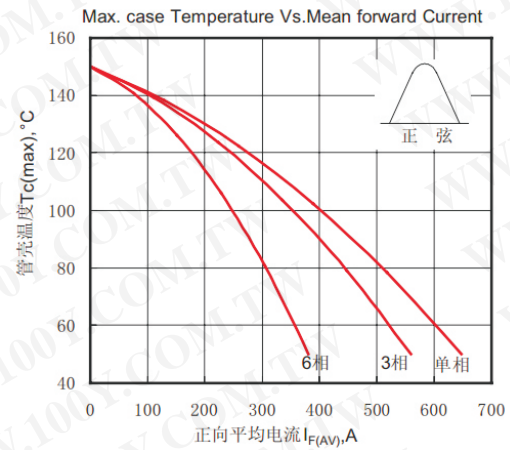


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

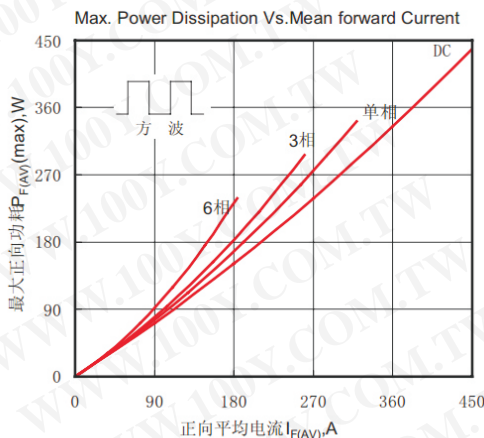


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

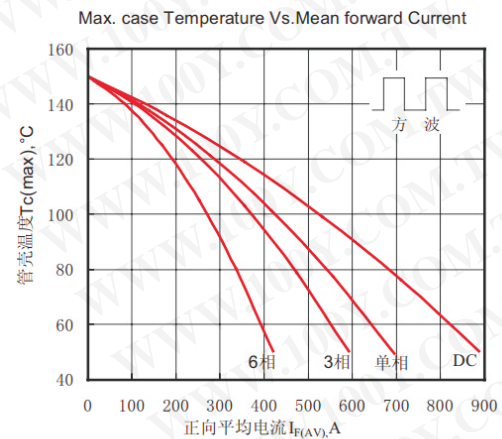


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

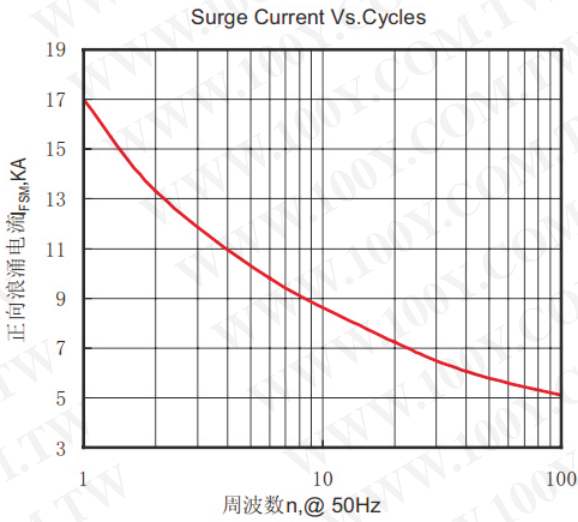


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

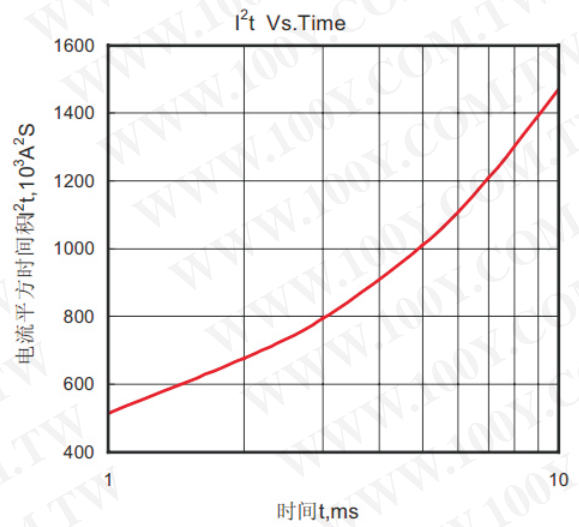
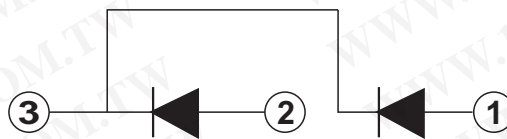
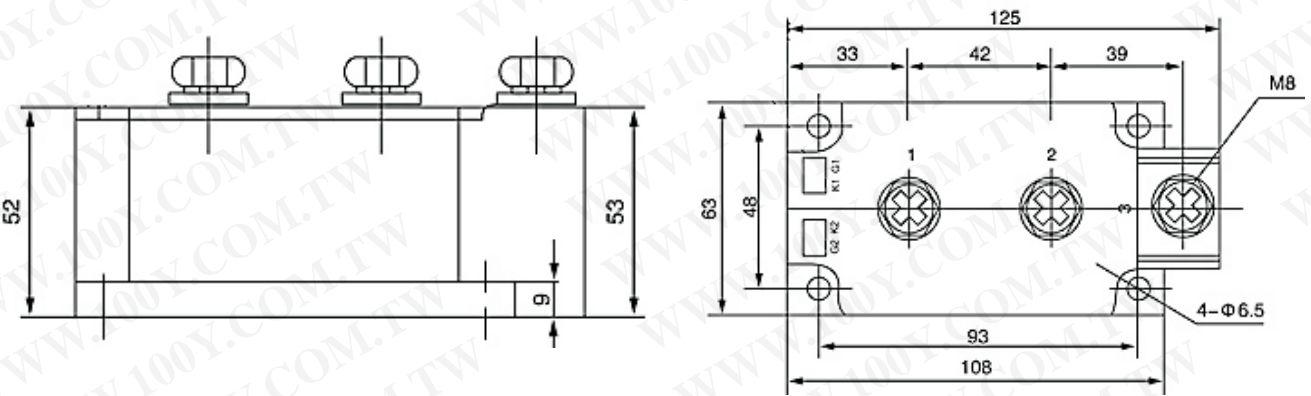


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	300A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$12.5A \times 10^3$
I_{Tj}	$797A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			300	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			471	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			20	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			12.5	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			797	$A^2s \times 10^3$
I_{Tj}	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.55	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=900A$	25			1.35	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.04	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, Iiso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M8)					12	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

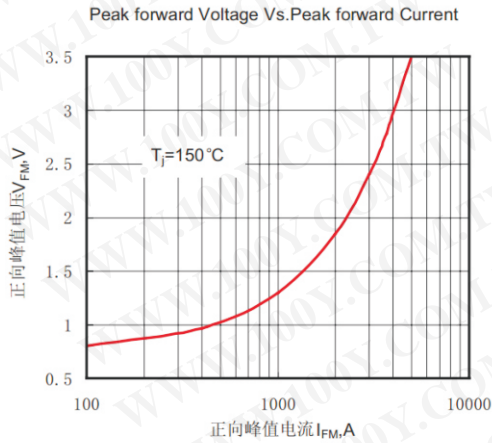


Fig.1 正向伏安特性曲线

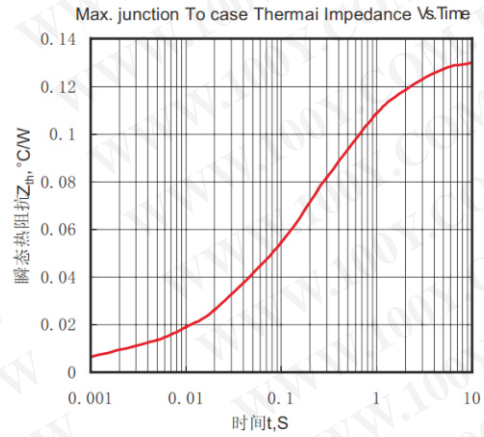


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

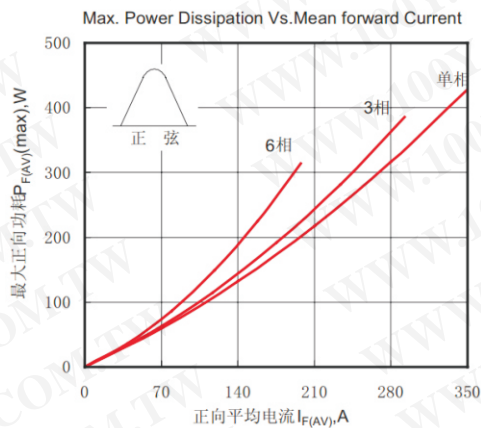


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

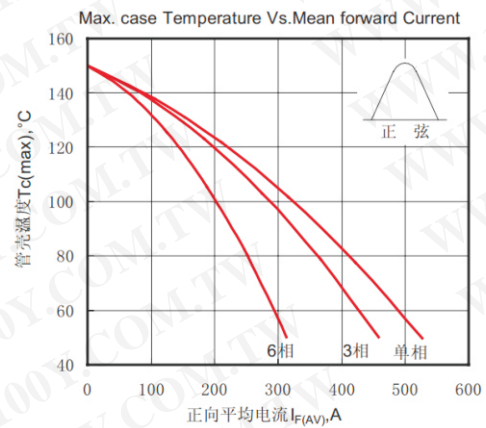


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

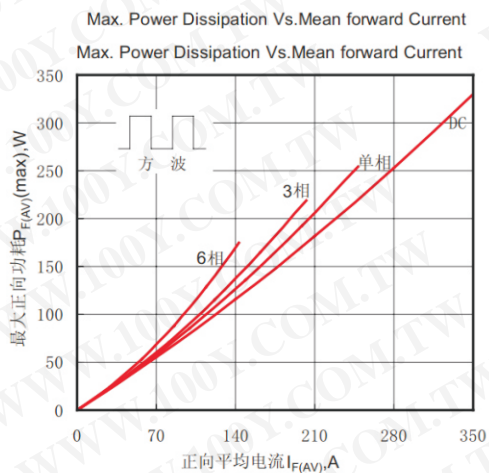


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

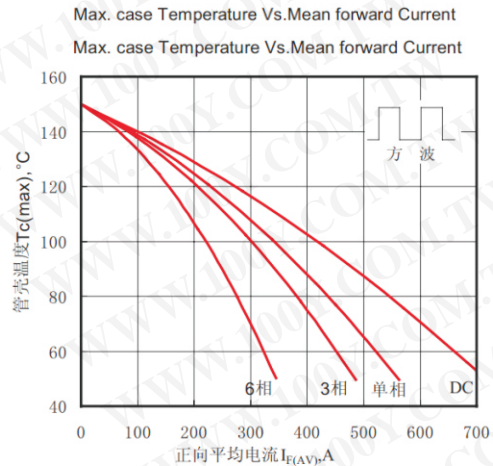


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

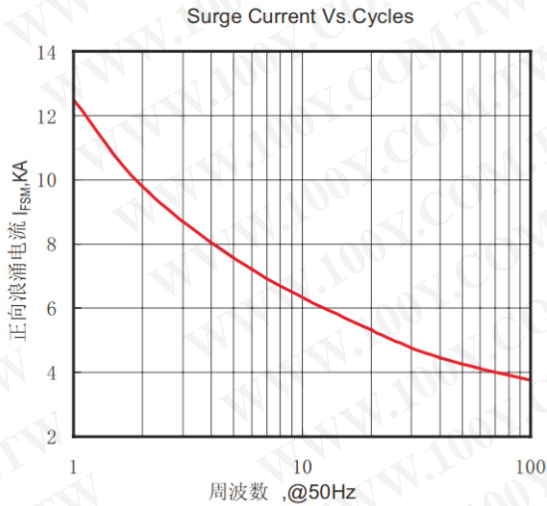


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

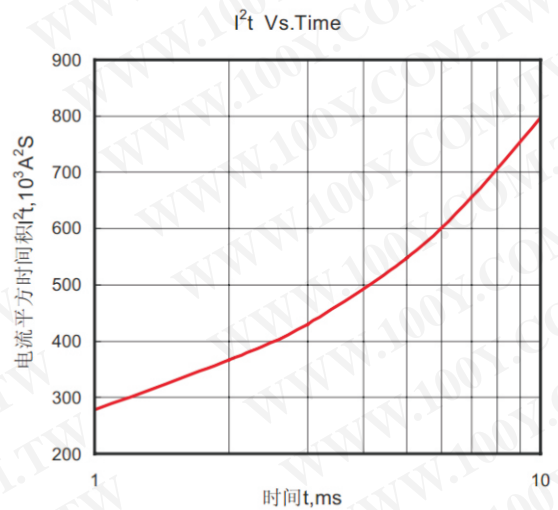
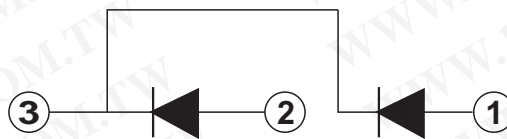
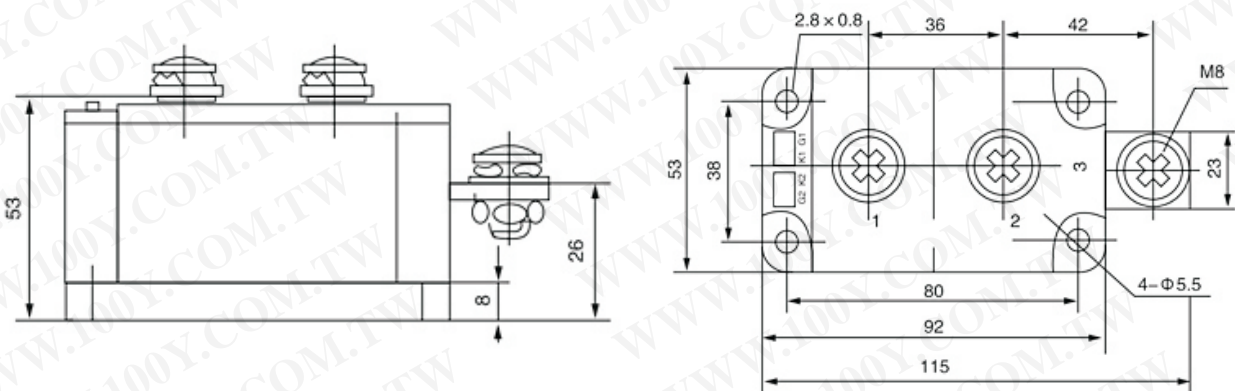


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	250A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$11A \times 10^3$
I_{Tj}	$617A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			250	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			393	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			20	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			11.0	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			617	$A^2s \times 10^3$
I_{Tj}	门槛电压		150			0.75	V
rF	斜率电阻		150			0.76	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=750A$	25			1.43	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.140	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.04	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, liso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M8)					12	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

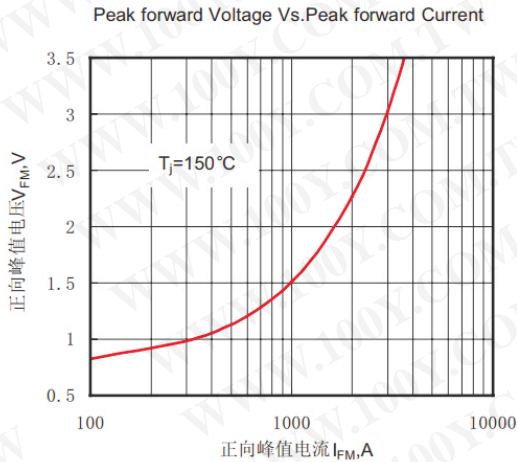


Fig.1 正向伏安特性曲线

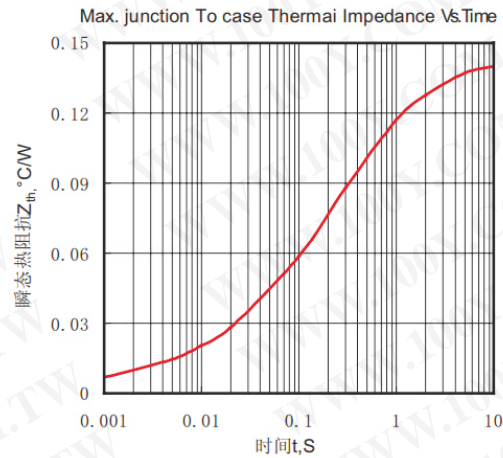


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

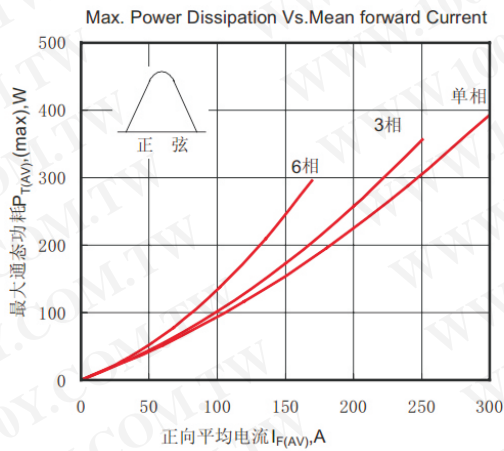


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

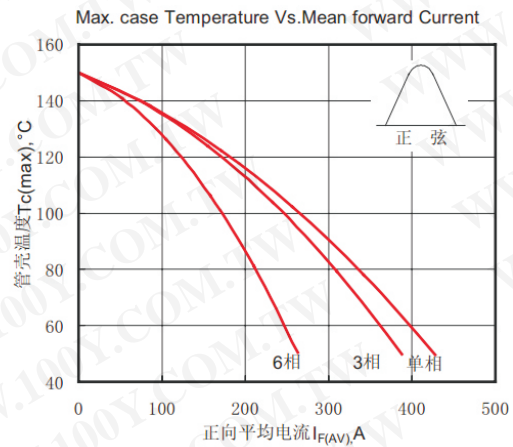


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

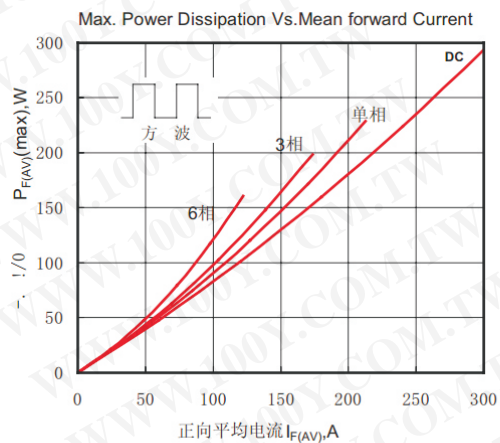


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

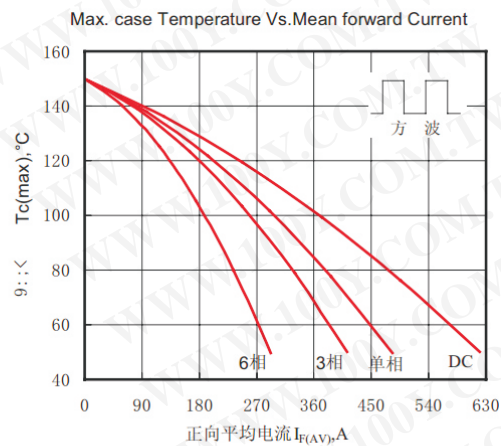


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

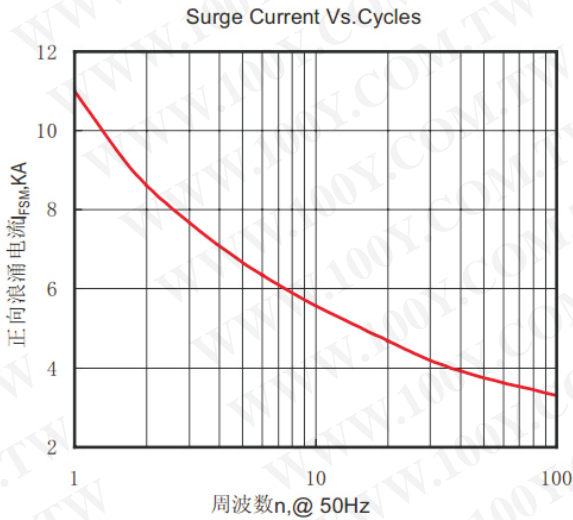


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

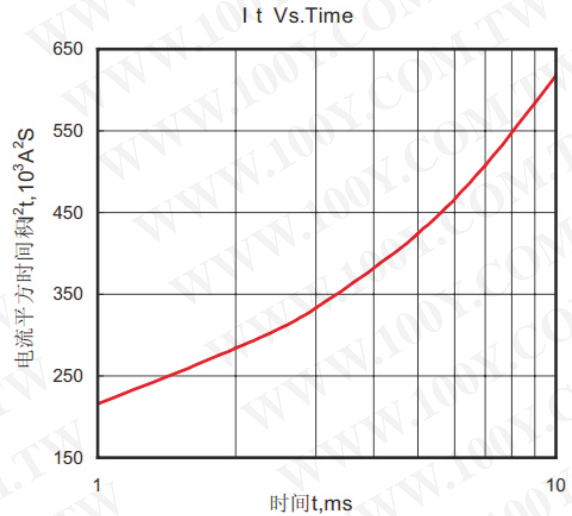
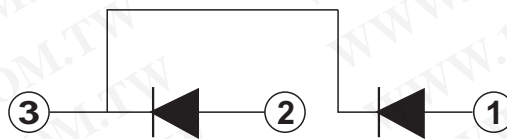
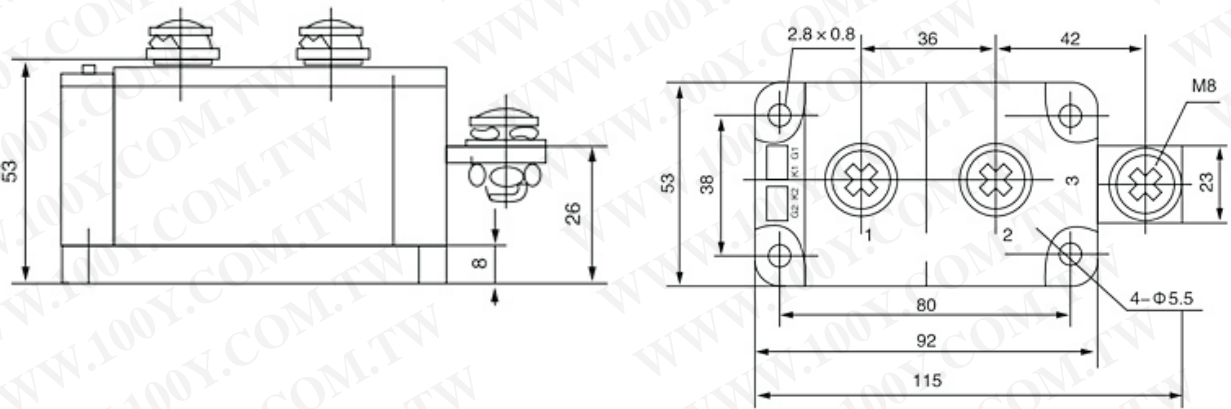


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小, 重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	200A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$8A \times 10^3$
I_{T1}	$326A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			200	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			314	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			12	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			8.00	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			326	$A^2s \times 10^3$
I_{T1}	门槛电压		150			0.75	V
rF	斜率电阻		150			0.88	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=600A$	25			1.38	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.210	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.08	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, Iiso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度					-40	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

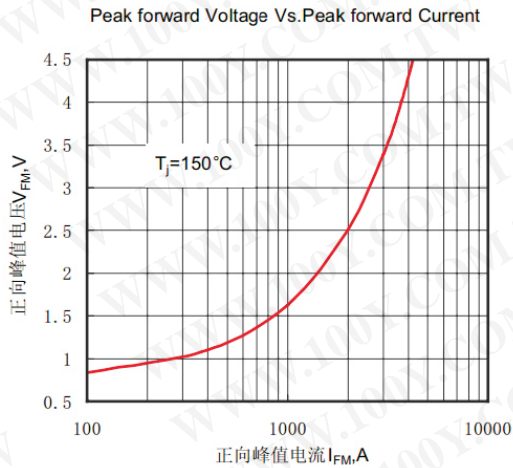


Fig.1 正向伏安特性曲线

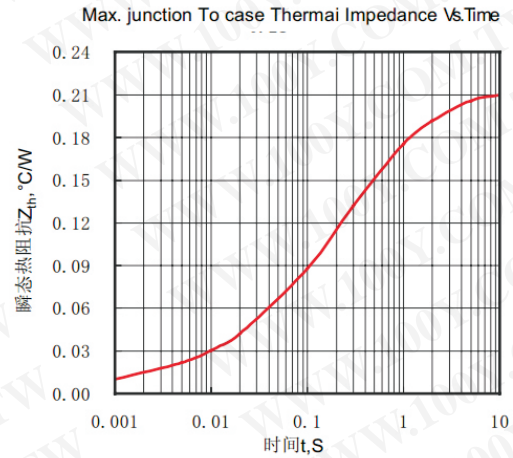


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

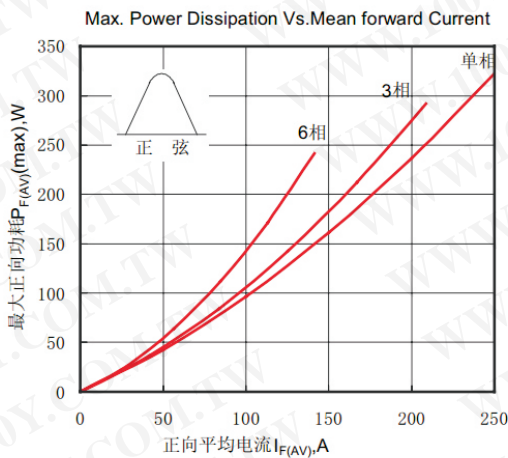


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

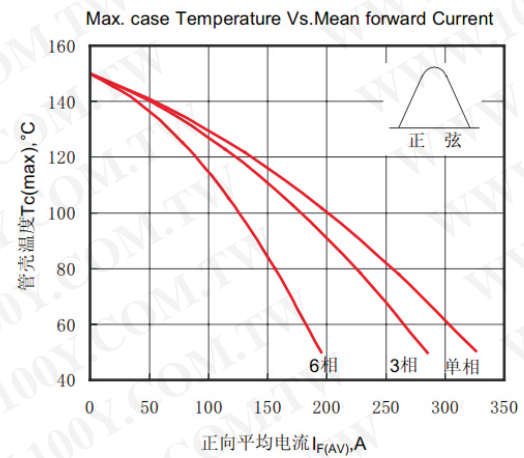


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

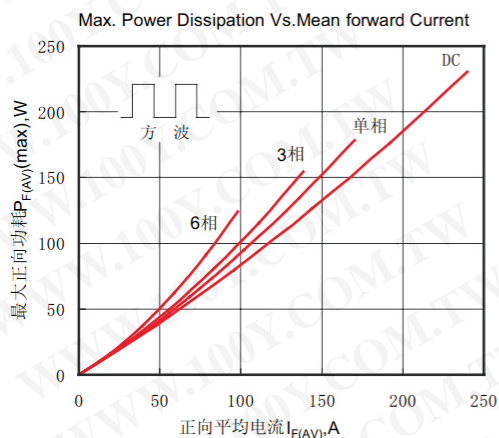


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

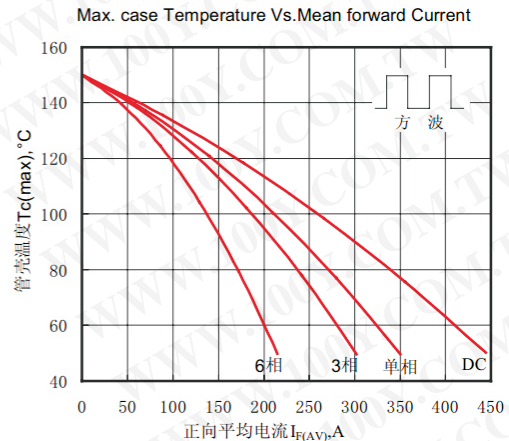


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

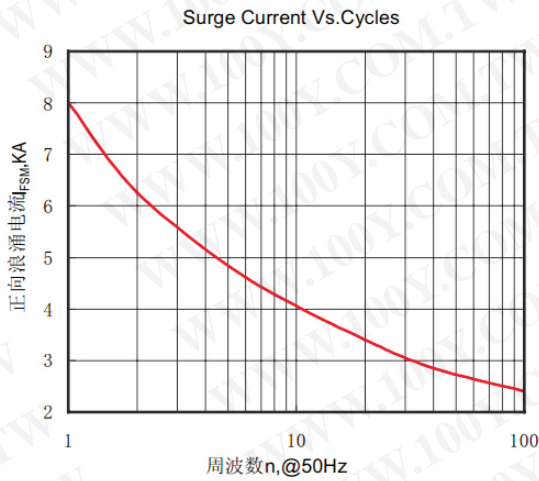


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

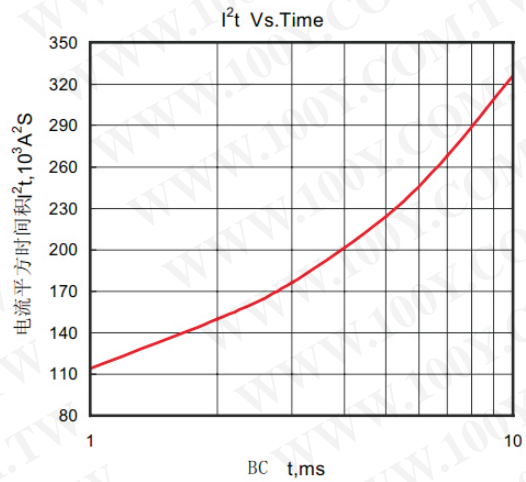
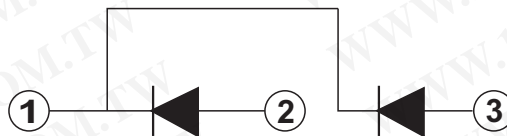
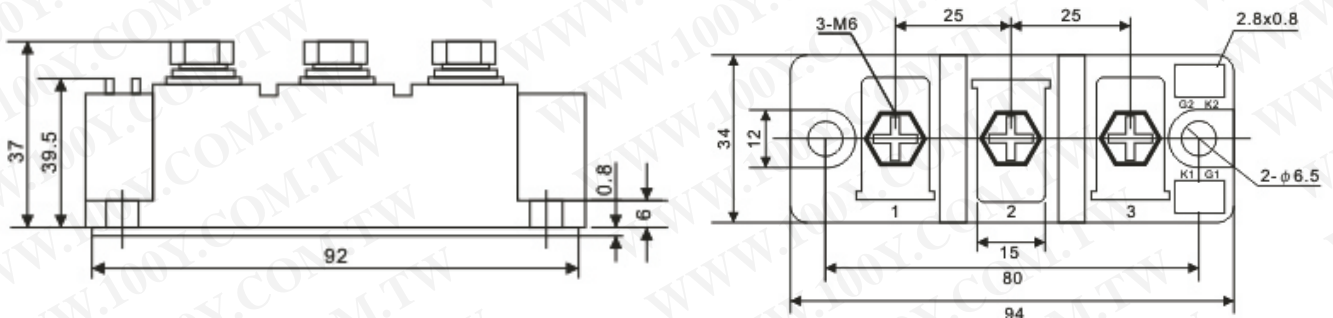


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	160A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$5.4A \times 10^3$
I_{Tj}	$146A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			160	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			251	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			20	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			5.40	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			146	$A^2s \times 10^3$
I_{Tj}	门槛电压		150			0.8	V
rF	斜率电阻		150			1.69	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=480A$	25			1.70	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.710	$^{\circ}C / W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.08	$^{\circ}C / W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, liso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M6)					6	N · m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N · m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

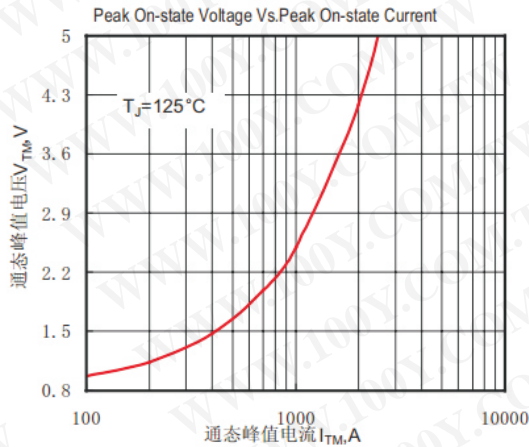


Fig.1 通态伏安特性曲线

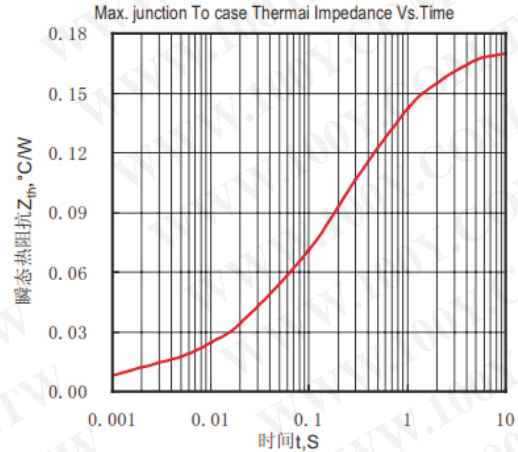


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

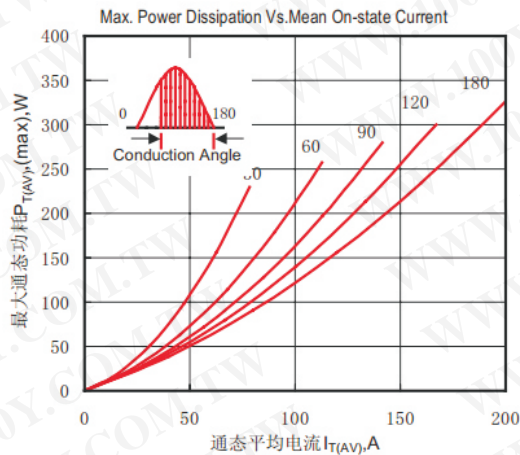


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

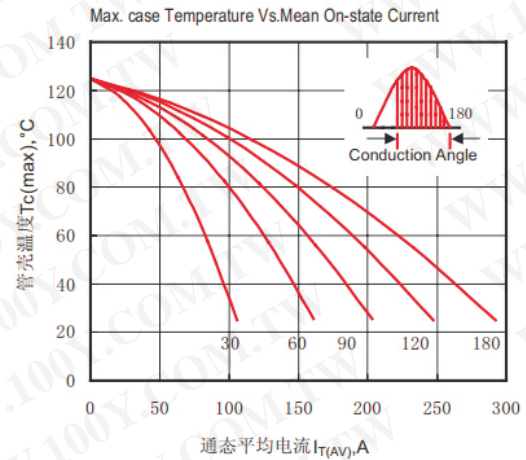


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

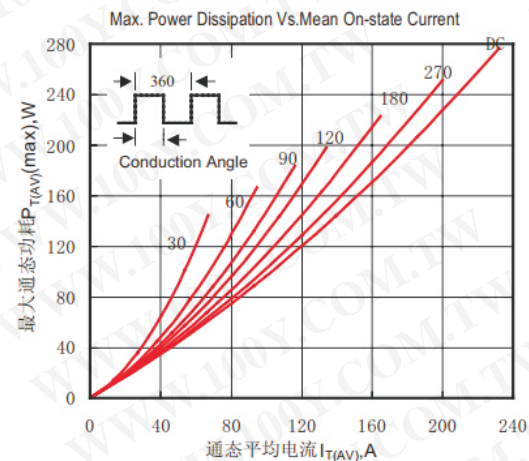


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

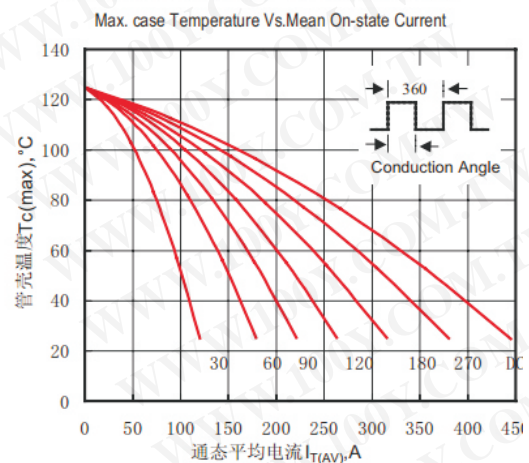


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

性能曲线图

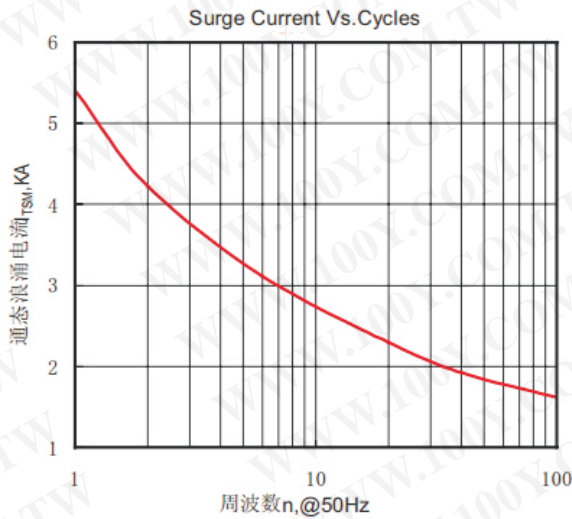


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

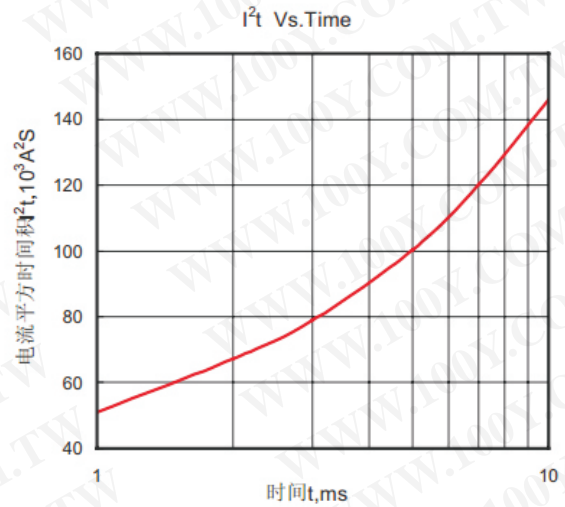
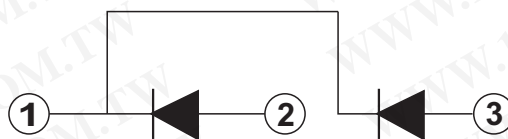
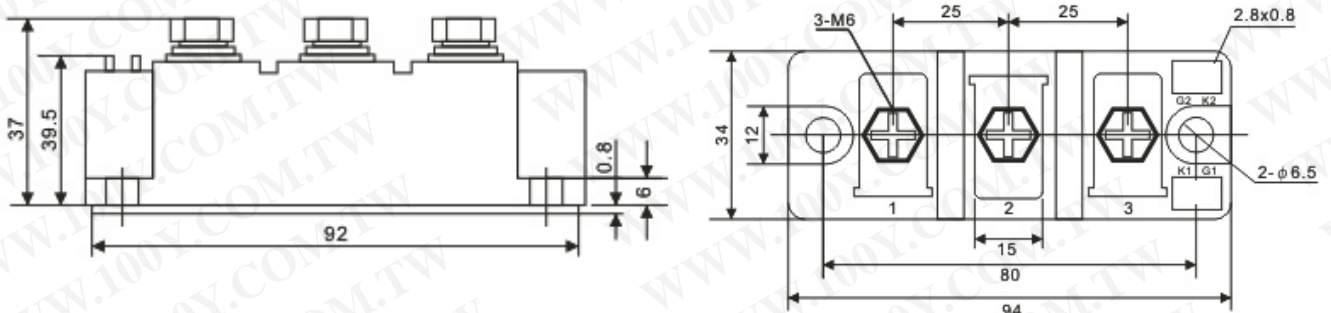


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	135A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$3.9A \times 10^3$
I^2t	$77.5A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			135	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			212	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM} = V_{RRM} + 200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM} = V_{RRM}$	150			12	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	150			3.90	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	150			77.5	$A^2s \times 10^3$
I^2t	门槛电压		150			0.80	V
rF	斜率电阻		150			1.18	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM} = 390A$	25			1.38	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.310	$^{\circ}C / W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.08	$^{\circ}C / W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, liso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度					-40	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

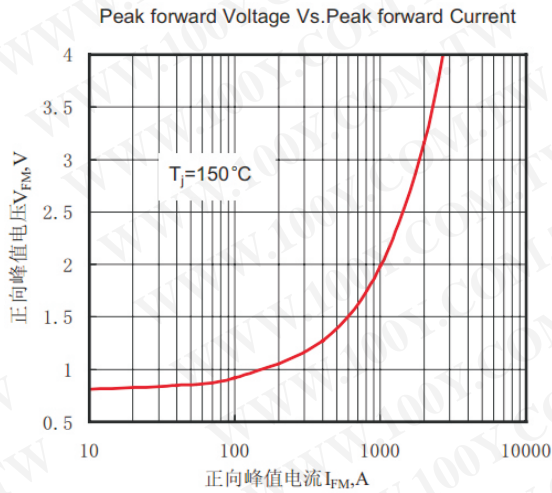


Fig.1 正向伏安特性曲线

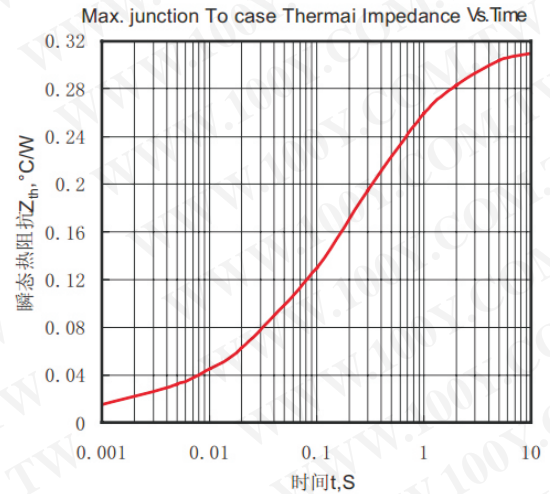


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

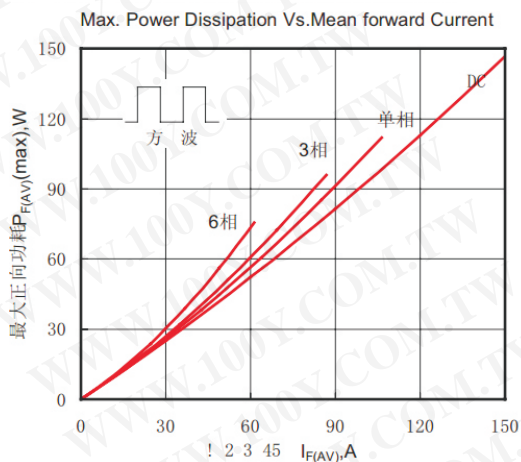
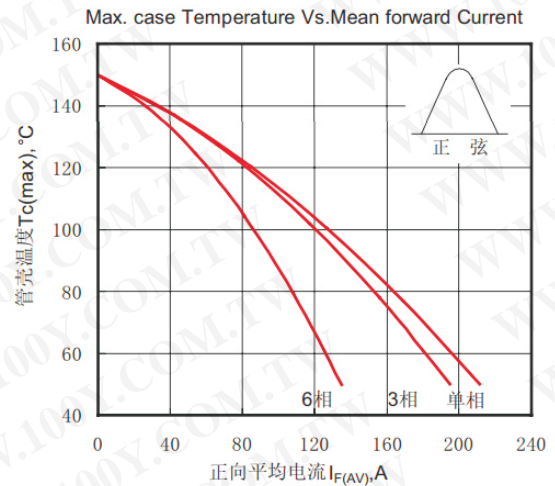
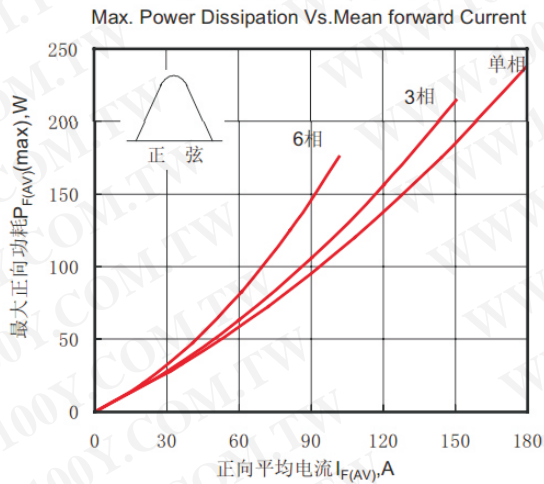


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

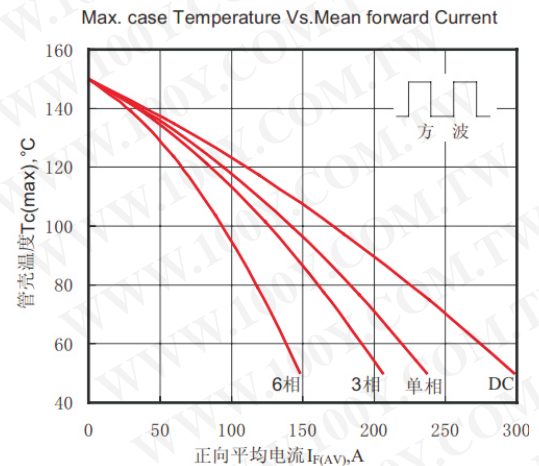


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

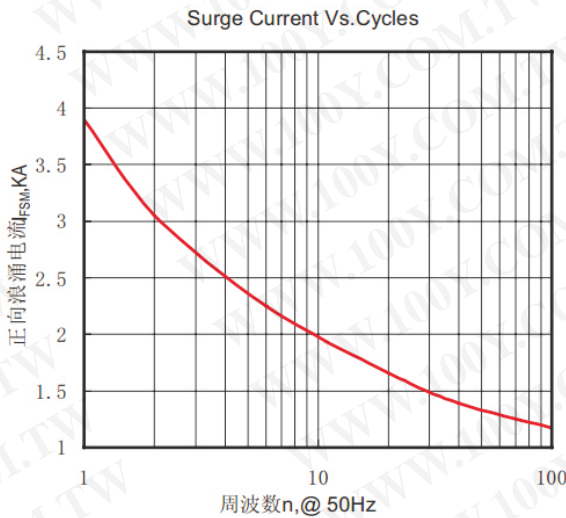


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

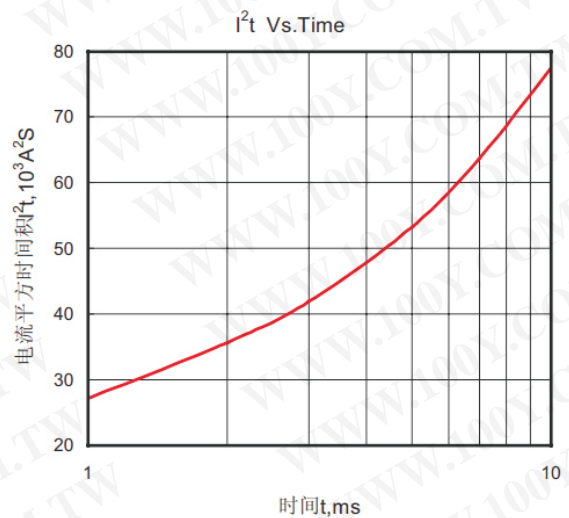
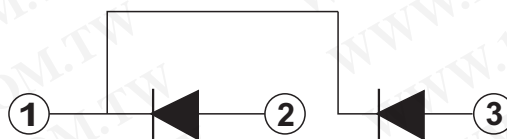
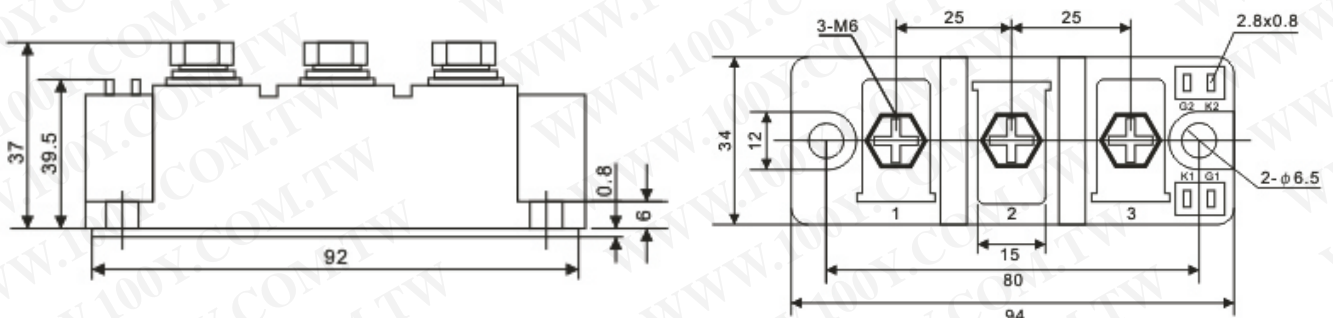


Fig.8 I²t特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	110A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$2.6A \times 10^3$
I^2t	$34.4A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			110	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			173	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM} = V_{RRM} + 200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM} = V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	150			2.60	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R = 0.6V_{RRM}$	150			34.4	$A^2s \times 10^3$
I^2t	门槛电压		150			0.80	V
rF	斜率电阻		150			1.74	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM} = 330A$	25			1.45	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.350	$^{\circ}C / W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.15	$^{\circ}C / W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, liso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M5)					4	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

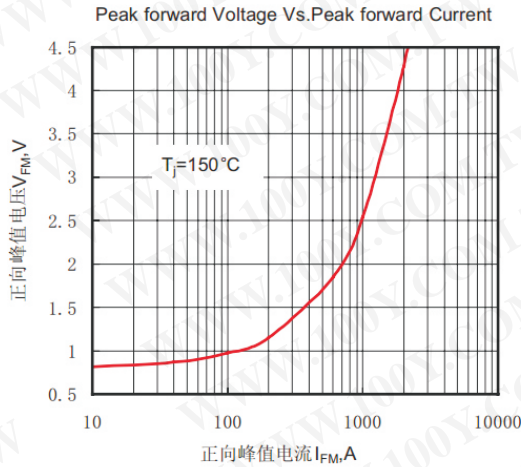


Fig.1 正向伏安特性曲线

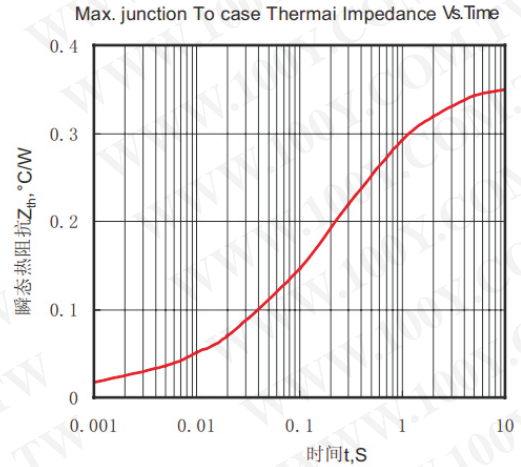


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

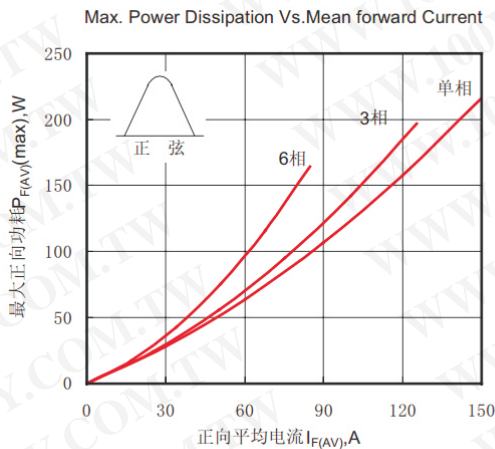


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

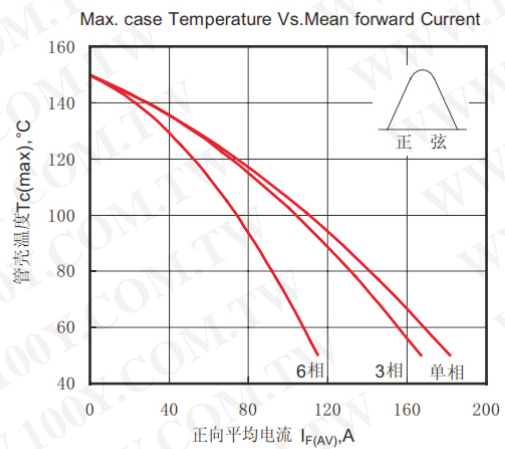


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

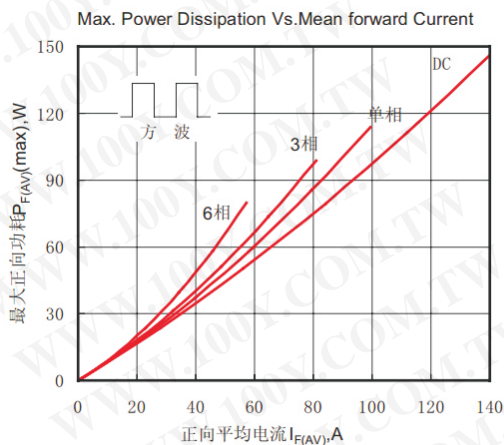


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

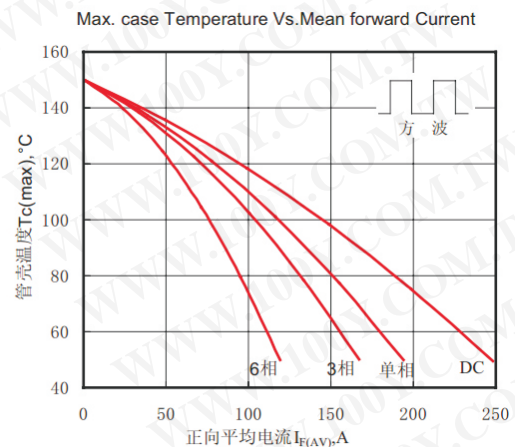


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

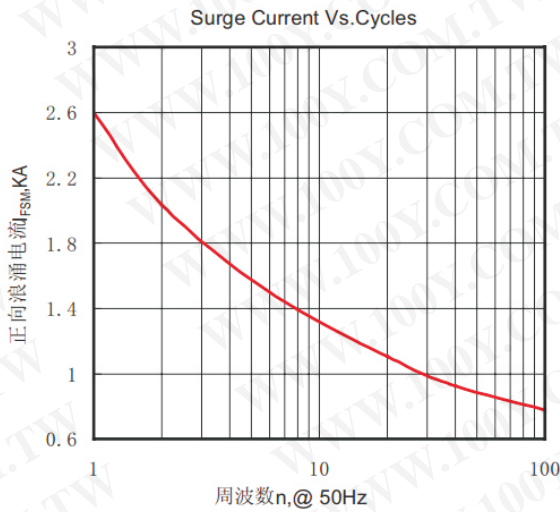


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

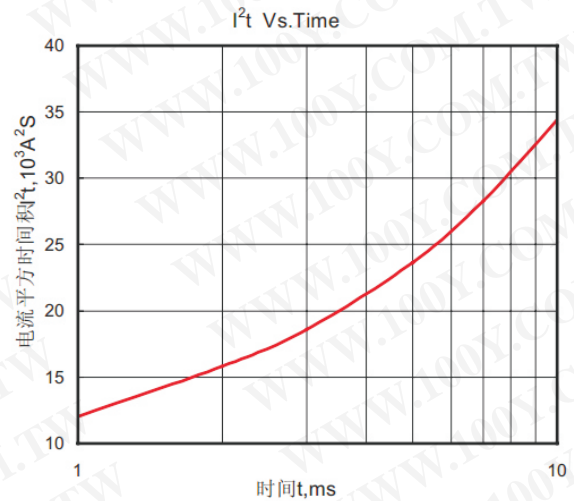
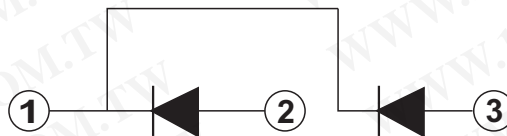
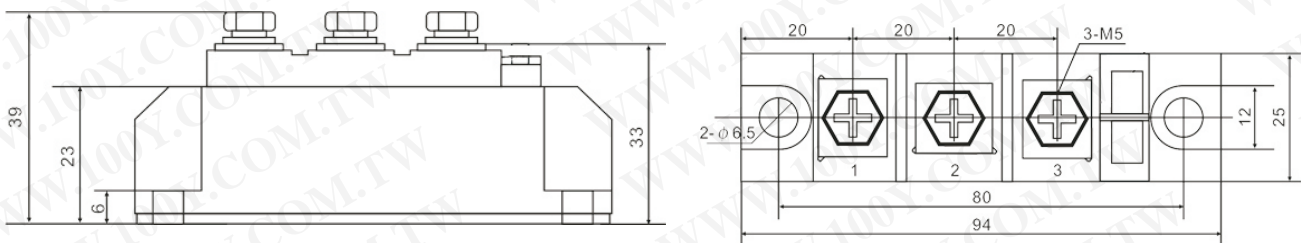


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	90A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$1.8A \times 10^3$
I_{Tj}	$16.5A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			90	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			110	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			1.80	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			16.5	$A^2s \times 10^3$
I_{Tj}	门槛电压		150			0.80	V
rF	斜率电阻		150			2.50	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=270A$	25			1.40	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.570	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.2	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, liso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M5)					4	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

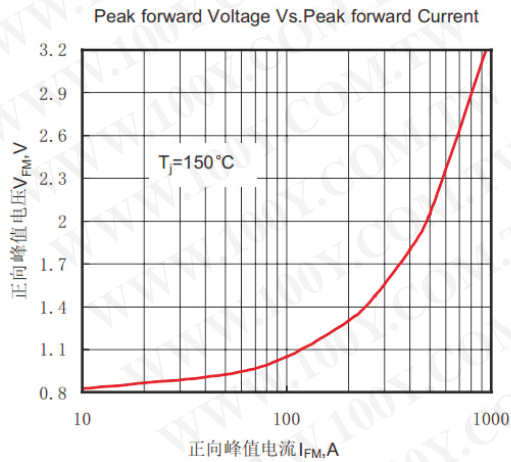


Fig.1 正向伏安特性曲线

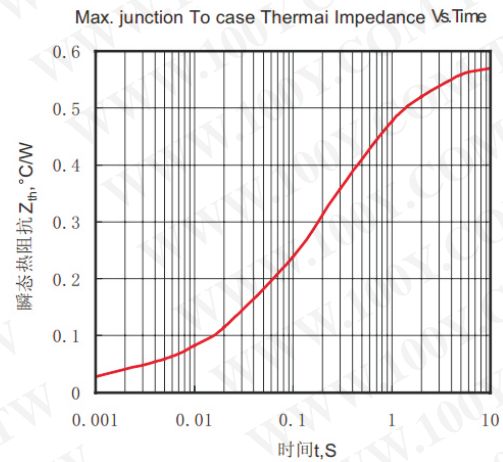


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

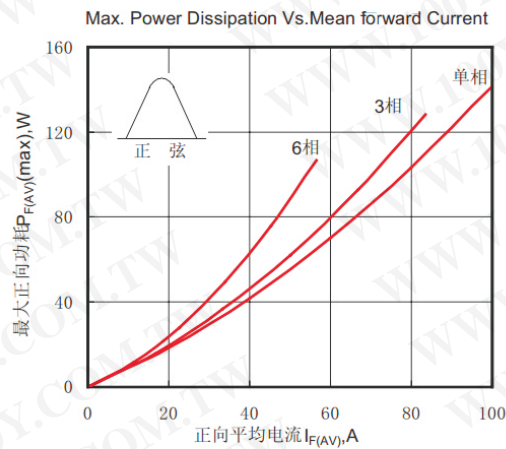


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

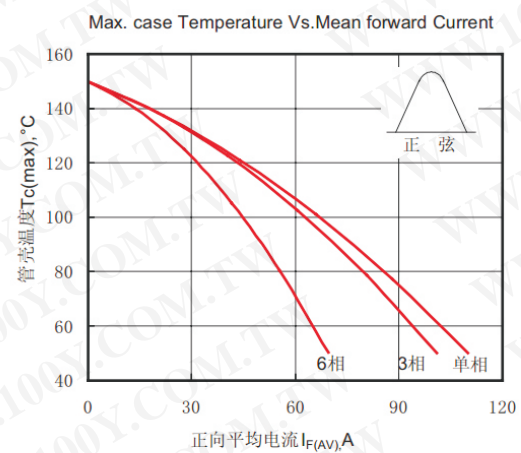


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

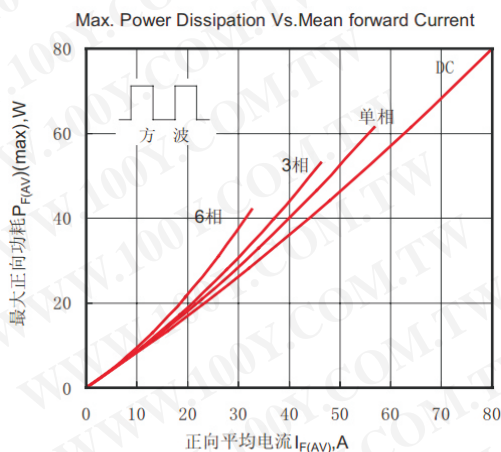


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

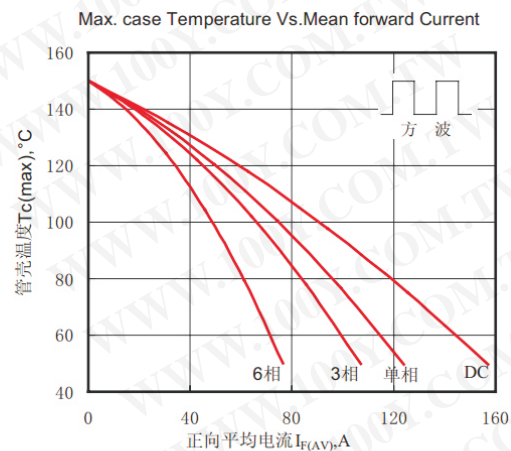


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

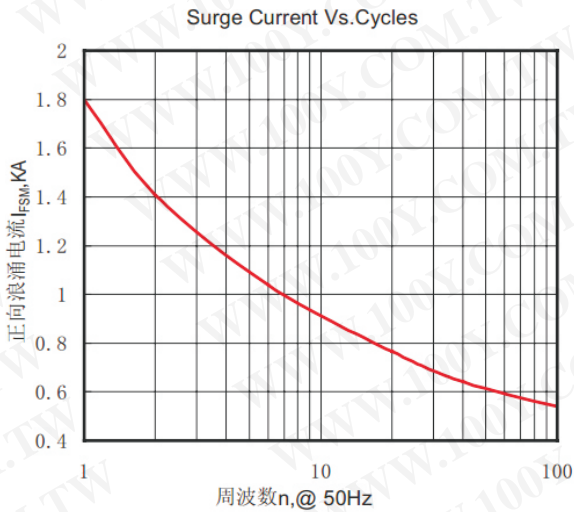


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

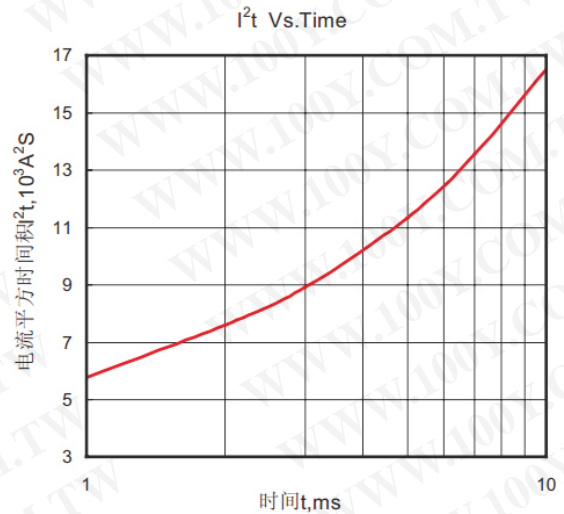
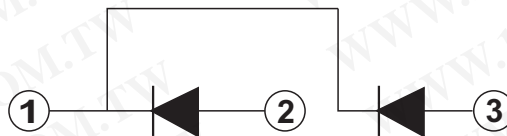
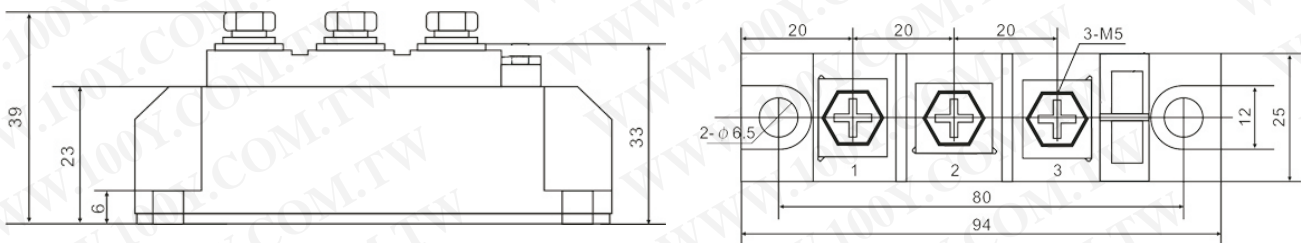


Fig.8 I²t特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{F(AV)}$	70A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$1.8A \times 10^3$
I^2t	$16.5A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			70	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			110	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			1.80	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			16.5	$A^2s \times 10^3$
I^2t	门槛电压		150			0.80	V
r_F	斜率电阻		150			2.50	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=210A$	25			1.40	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.570	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.2	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, Iiso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M5)					4	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

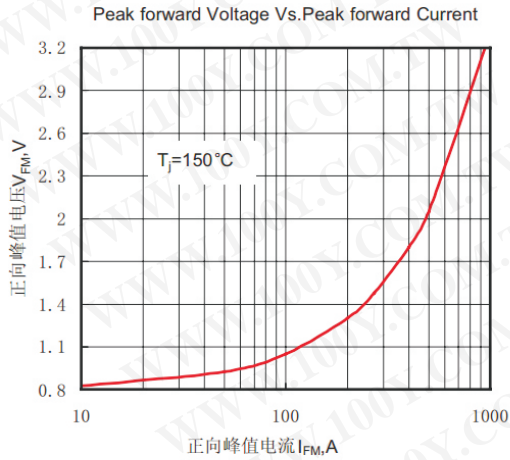


Fig.1 正向伏安特性曲线

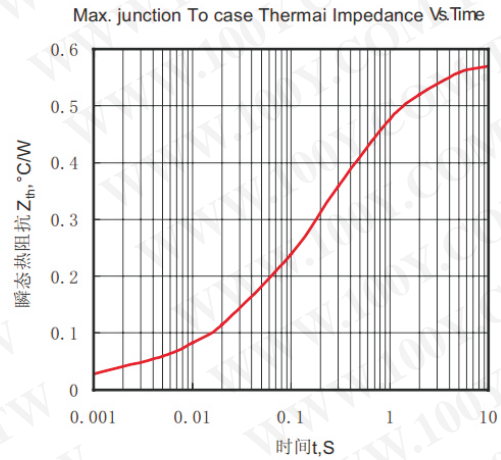


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

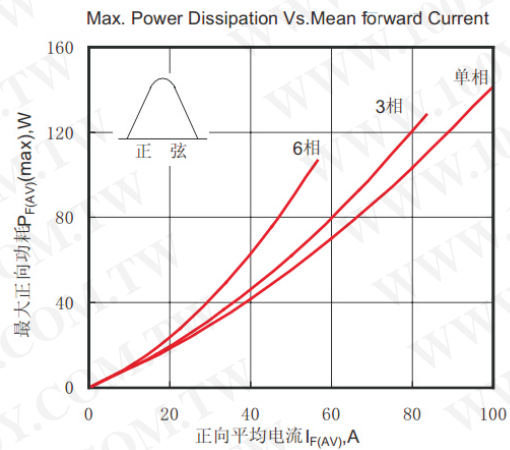


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

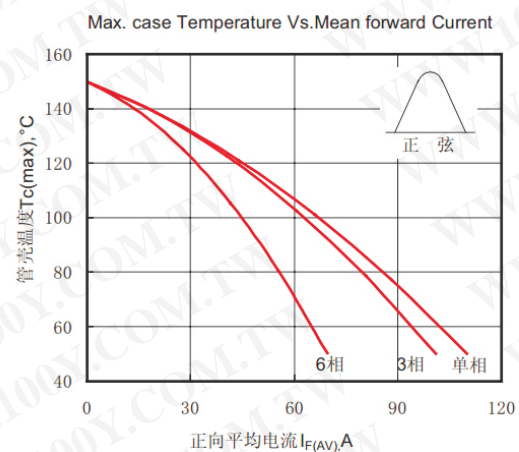


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

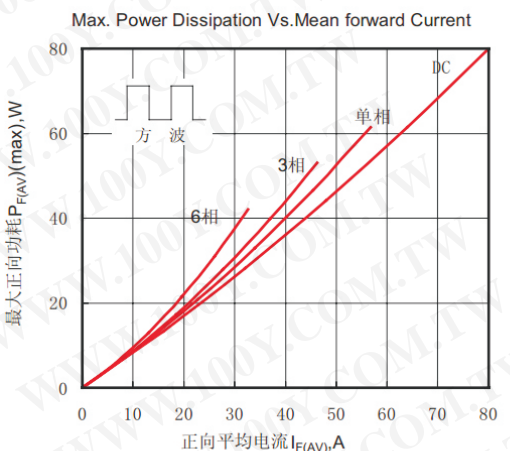


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

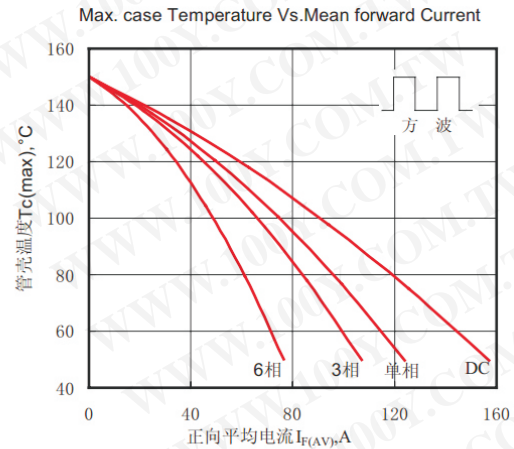


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

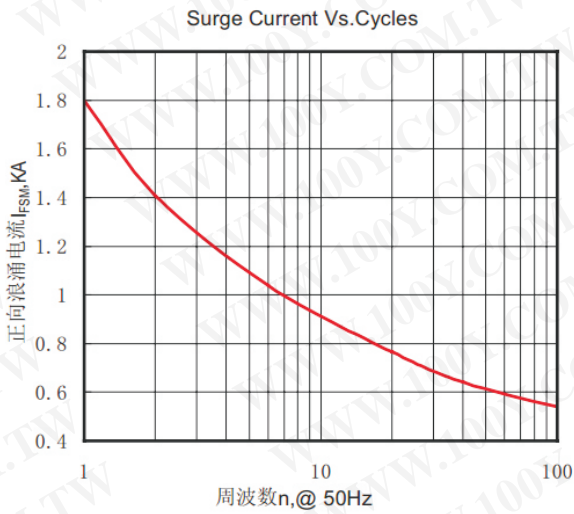


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

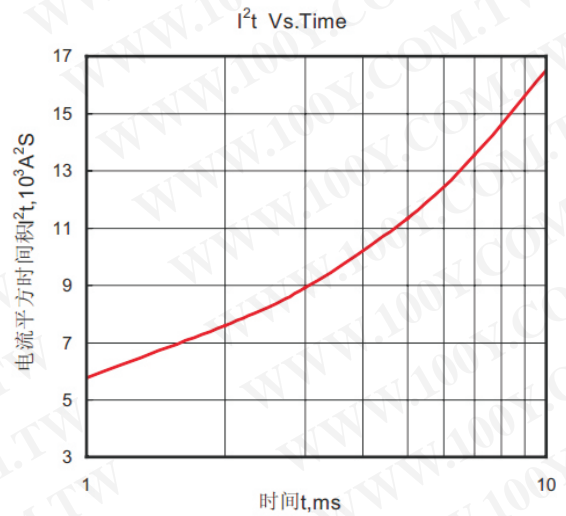
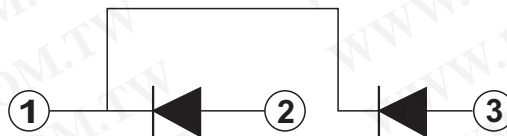
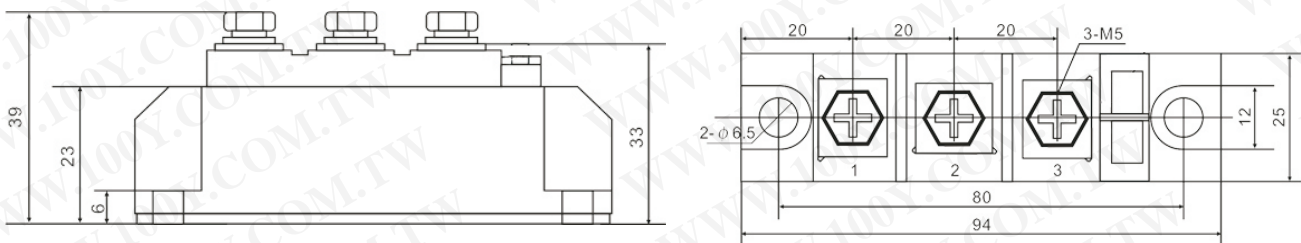


Fig.8 I²t特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	60A
V_{RRM}	1601V
I_{FSM}	$1.3A \times 10^3$
I^2t	$8.6A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			60	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			86	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1601		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			1.30	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			8.6	$A^2s \times 10^3$
I_{T1}	门槛电压		150			0.80	V
rF	斜率电阻		150			3.47	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=170A$	25			1.45	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				0.700	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.2	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, liso: 1mA(max)		2500			V
F_m	安装扭矩(M5)					4	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

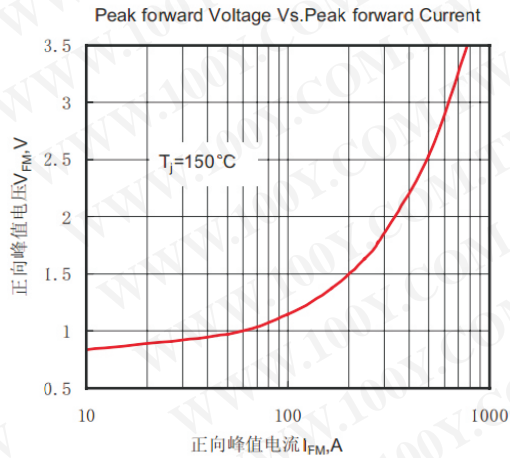


Fig.1 正向伏安特性曲线

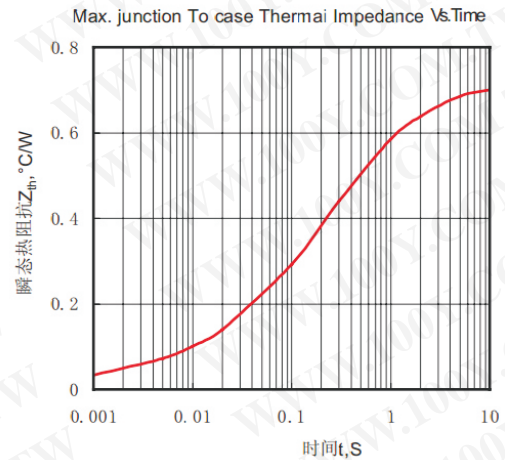


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

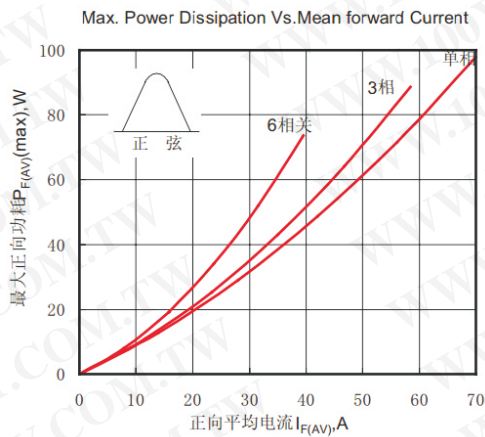


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

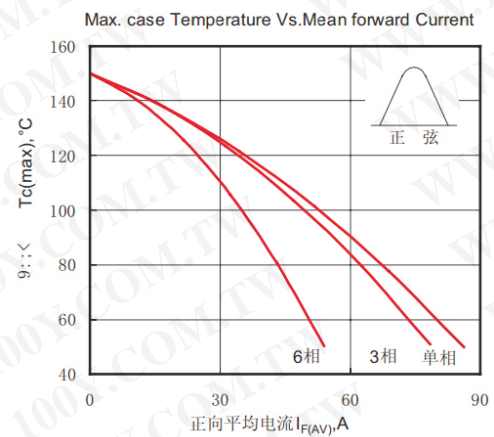


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

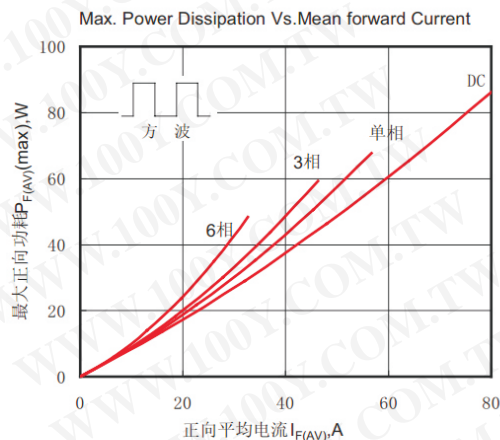


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

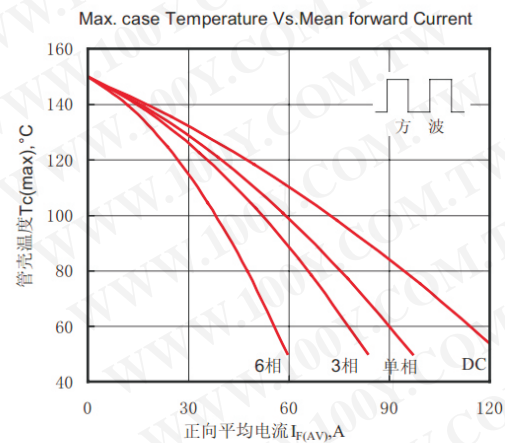


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

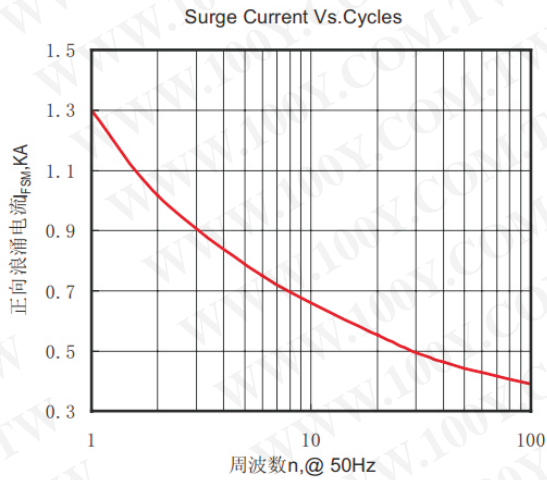


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

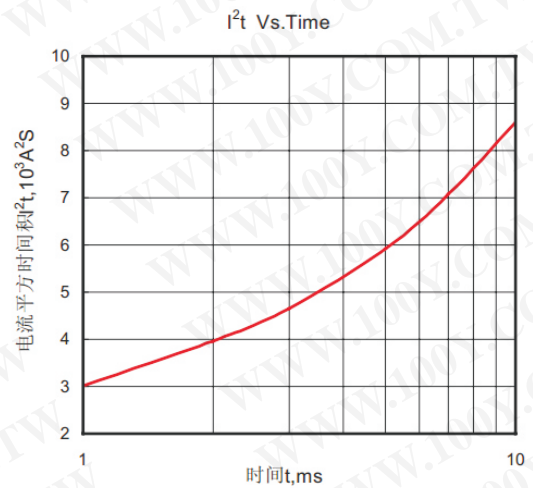
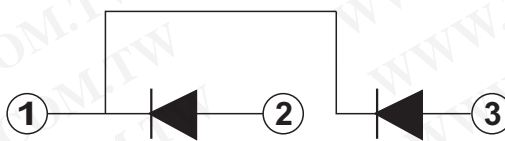
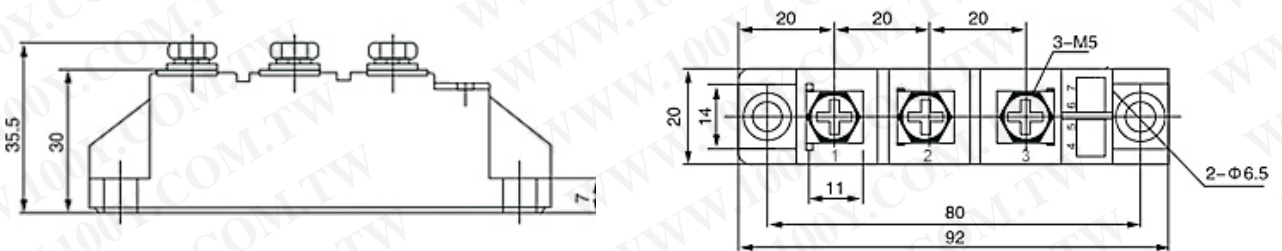


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

I_{FAV}	25A
V_{RRM}	1600V
I_{FSM}	$0.65A \times 10^3$
I_{T1}	$2.1A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
I_{FAV}	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^{\circ}C$	150			25	A
I_{FRMS}	方均根电流		150			41	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	V_{RRM} tp=10ms, $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			8	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			0.65	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			2.1	$A^2s \times 10^3$
I_{T1}	门槛电压		150			0.80	V
r_F	斜率电阻		150			9.80	m Ω
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=80A$	25			1.65	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦半波, 单面散热				1.300	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.2	$^{\circ}C/W$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, t=1min, Iiso: 1mA(max)			2500		V
F_m	安装扭矩(M5)					4	N·m
F_m	安装扭矩(M6)					6	N·m
T_{stg}	贮存温度			-40		125	$^{\circ}C$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

普通整流管模块

MDK25A1600V

ChunShu Rectifier CO., LTD.

性能曲线图

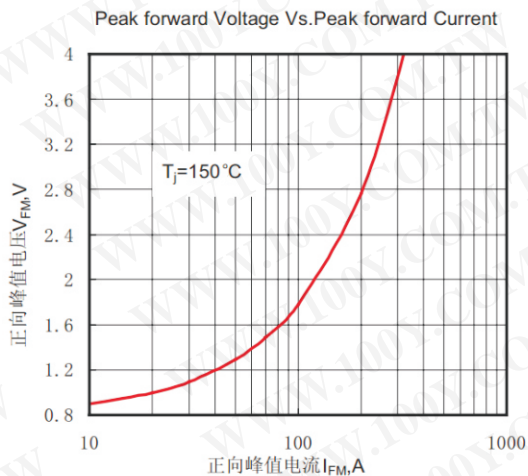


Fig.1 正向伏安特性曲线

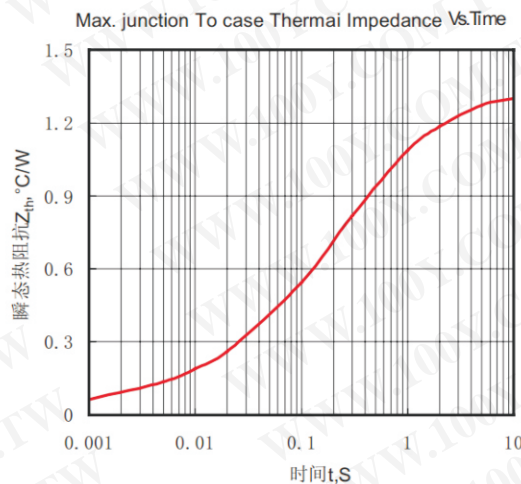


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

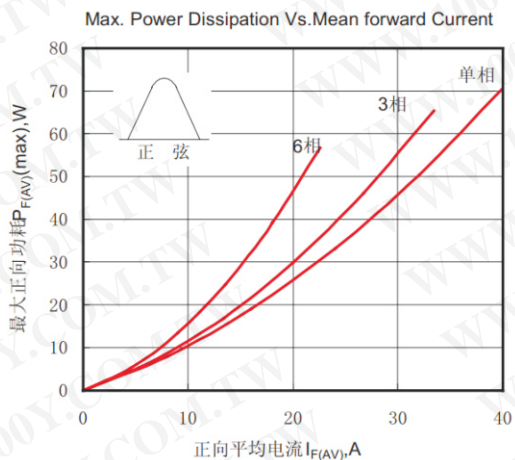


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

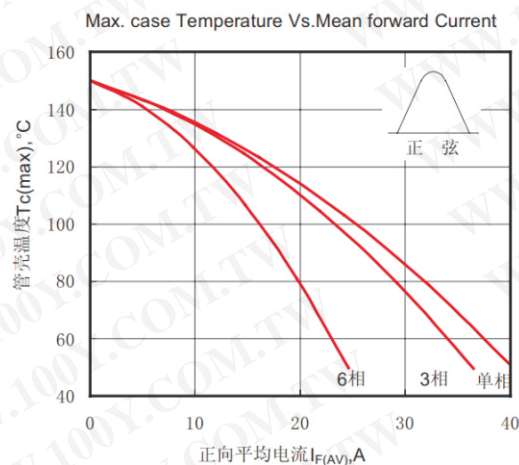


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

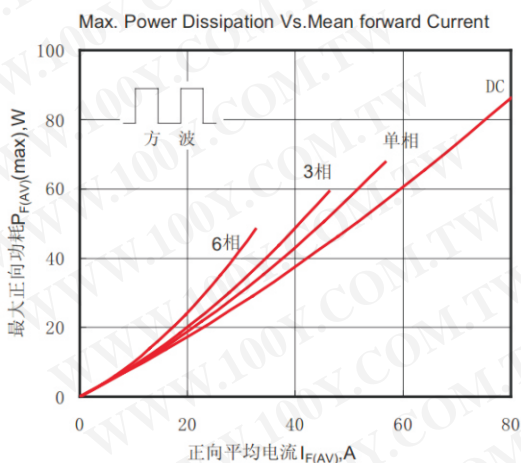


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

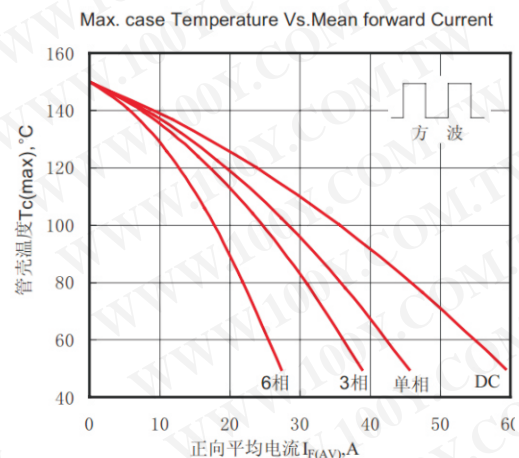


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

普通整流管模块

MDK25A1600V

ChunShu Rectifier CO., LTD.

性能曲线图

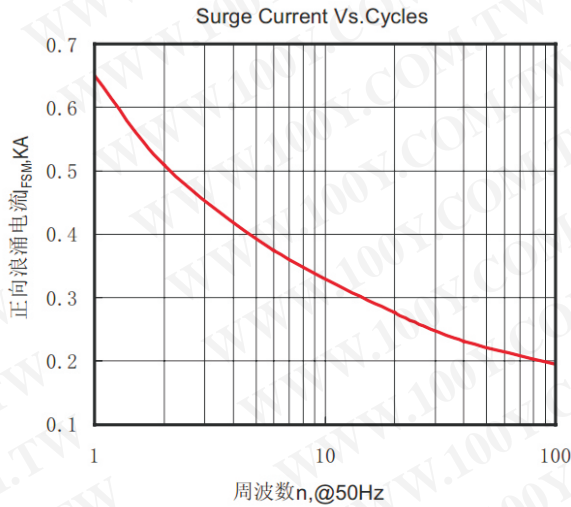


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

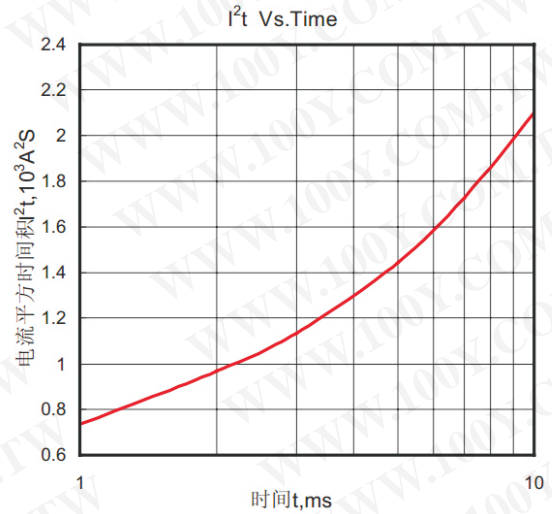


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形尺寸图

